

명세서

청구범위

청구항 1

장치로서,

유효 키 코드를 수신하도록 적응되는 네트워크 인터페이스;

지상 매체를 따라 이동하는 유도 표면과로부터 전기 에너지를 획득하도록 구성되는 유도 표면과 수신 구조물-상기 유도 표면과에는 사용자 키 코드가 임베딩됨 -;

상기 유효 키 코드에 대해 상기 사용자 키 코드를 검증하도록 적응되는 처리 회로- 상기 처리 회로는 상기 사용자 키 코드가 무효화되는 것에 응답하여 상기 유도 표면과로부터의 상기 전기 에너지의 전기 부하로의 전달을 디스에이블하도록 적응됨 -; 및

상기 유도 표면과 수신 구조물에 결합된 상기 전기 부하- 상기 전기 부하는 상기 유도 표면을 생성하는 유도 표면 도파로 프로브에 결합된 여기 소스에서 부하로서 경험됨 -

를 포함하는, 장치.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 유효 키 코드는 전력 서비스 제어기 디바이스로부터 주기적으로 수신되는, 장치.

청구항 3

제1항 또는 제2항에 있어서,

상기 유효 키 코드를 저장하도록 구성되는 예약된 메모리 부분을 추가로 포함하는, 장치.

청구항 4

제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 유효 키 코드는 암호화된 네트워크 채널을 통해 수신되는, 장치.

청구항 5

제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 유효 키 코드는 셀룰러 통신 채널을 통해 수신되는, 장치.

청구항 6

장치로서,

손실형 전도성 매체를 통해 유도 표면을 발진하도록 구성되는 유도 표면 도파로 프로브;

상기 유도 표면과 내에 유효 키 코드를 임베딩하도록 구성되는 변조 회로; 및

상기 유도 표면을 수신하도록 구성되는 유도 표면과 수신 장비에 대역 외 통신 채널에서 사용자 키 코드를 전송하도록 추가로 구성되는 제어기 디바이스- 상기 유효 키 코드에 대한 상기 사용자 키 코드의 긍정적인 비교는 상기 유도 표면과로부터 획득된 전기 에너지를 전기 부하로 전달하기 위한 허가를 표시함 -

를 포함하는, 장치.

청구항 7

제6항에 있어서,

상기 유도 표면 도파로 프로브는 상기 손실형 전도성 매체 위쪽으로 상승된 충전 단자를 포함하고, 상기 손실형 전도성 매체의 복소 브루스터 입사각($\Theta_{i,B}$)으로 입사하는 파면을 합성하는 적어도 하나의 결과적인 필드를 생성하도록 구성되는, 장치.

청구항 8

제7항에 있어서,

상기 충전 단자는 복수의 충전 단자 중 하나인, 장치.

청구항 9

제7항에 있어서,

상기 충전 단자에 전기적으로 결합되는 공급 네트워크를 추가로 포함하고, 상기 공급 네트워크는 상기 유도 표면 도파로 프로브 부근에서 상기 손실형 전도성 매체와 연관된 복소 브루스터 입사각($\Theta_{i,B}$)과 연관된 파 경사각(Ψ)과 매칭하는 위상 지연(Φ)을 제공하는, 장치.

청구항 10

제9항에 있어서,

상기 충전 단자는 복수의 충전 단자 중 하나인, 장치.

청구항 11

제6항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 제어기 디바이스는 갱신된 유효 키 코드를 상기 유도 표면과 수신 장비에 주기적으로 송신하는, 장치.

청구항 12

제11항에 있어서,

상기 갱신된 유효 키 코드는 상기 유도 표면 도파로 프로브에 의해 제공되는 전력 서비스의 현재 가입자의 네트워크 주소로 송신되는, 장치.

청구항 13

제6항 내지 제12항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 유효 키 코드를 생성하도록 적응되는 키 생성기 애플리케이션을 추가로 포함하는, 장치.

청구항 14

제6항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 대역 외 통신 채널은 네트워크 암호화된 채널을 포함하는, 장치.

청구항 15

제6항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 대역 외 통신 채널은 셀룰러 통신 채널을 포함하는, 장치.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 관련 출원의 상호 참조

[0002] 본 출원은 2015년 9월 10일자로 출원된 미국 출원 제14/849,944호 - 그 전체가 본 명세서에 참고로 인용됨 - 에

대한 우선권 및 그의 이익을 주장한다.

[0003] 본 출원은 2013년 3월 7일자로 출원되어 출원 번호 13/789,538을 배정받았고, 2014년 9월 11일자로 공개 번호 US2014/0252886 A1로서 공개되었으며, 참조에 의해 그 전체가 본원에 원용되는, 발명의 명칭이 "Excitation and Use of Guided Surface Wave Modes on Lossy Media"인 공동 계류 중인 미국 정규 특허 출원에 관련되어 있다. 본 출원은 또한 2013년 3월 7일자로 출원되어 출원 번호 13/789,525를 배정받았고, 2014년 9월 11일자로 공개 번호 US2014/0252865 A1로서 공개되었으며, 참조에 의해 그 전체가 본원에 원용되는, 발명의 명칭이 "Excitation and Use of Guided Surface Wave Modes on Lossy Media"인 공동 계류 중인 미국 정규 특허 출원에 관련되어 있다. 본 출원은 게다가 2014년 9월 10일자로 출원되어 출원 번호 14/483,089를 배정받았고, 참조에 의해 그 전체가 본원에 원용되는, 발명의 명칭이 "Excitation and Use of Guided Surface Wave Modes on Lossy Media"인 공동 계류 중인 미국 정규 특허 출원에 관련되어 있다. 본 출원은 게다가 2015년 6월 2일자로 출원되어 출원 번호 14/728,507을 배정받았고, 참조에 의해 그 전체가 본원에 원용되는, 발명의 명칭이 "Excitation and Use of Guided Surface Waves"인 공동 계류 중인 미국 정규 특허 출원에 관련되어 있다. 본 출원은 게다가 2015년 6월 2일자로 출원되어 출원 번호 14/728,492를 배정받았고, 참조에 의해 그 전체가 본원에 원용되는, 발명의 명칭이 "Excitation and Use of Guided Surface Waves"인 공동 계류 중인 미국 정규 특허 출원에 관련되어 있다.

[0004] 배경

[0005] 한 세기 이상 동안, 전파(radio wave)들에 의해 전송되는 신호들은 종래의 안테나 구조물들을 사용하여 발진(launch)되는 방사 필드들을 수반하였다. 전파 공학과는 대조적으로, 지난 세기의 전력 분배 시스템들은 전기 전도체들을 따라 유도되는 에너지의 전송을 수반하였다. 무선 주파수(radio frequency)(RF)와 전력 전송 사이의 구분에 대한 이러한 이해는 1900년대 초 이래로 존재해 왔다.

발명의 내용

[0006] 본 개시내용의 실시예들은 유도 표면과 수신 장비를 인에이블/디스에이블하기 위한 인증을 전달하기 위한 장치 및 방법을 제공한다. 일 실시예에서, 예시적인 장치는 유효 키 코드를 수신하도록 적응되는 네트워크 인터페이스 및 지상 매체를 따라 이동하는 유도 표면과로부터 전기 에너지를 획득하도록 구성되는 유도 표면과 수신 구조물을 포함하고, 유도 표면과에는 사용자 키 코드가 임베딩된다. 상기 장치는 유효 키 코드에 대해 사용자 키 코드를 검증하도록 구성되는 처리 회로 및 유도 표면과 수신 구조물에 결합된 전기 부하를 추가로 포함하고, 처리 회로는 사용자 키 코드가 무효화되는 것에 응답하여 유도 표면과로부터의 전기 에너지의 전기 부하로의 전달을 디스에이블하도록 적응된다. 전기는 유도 표면을 생성하는 유도 표면 도파로 프로브에 결합된 여기 소스에서 부하로서 경험된다.

[0007] 일 실시예에서, 다른 예시적인 장치는 손실형 전도성 매체를 통해 유도 표면을 발진하도록 구성되는 유도 표면 도파로 프로브 및 유도 표면과 내에 유효 키 코드를 임베딩하도록 구성되는 변조 회로를 포함한다. 이러한 장치는 유도 표면을 수신하도록 구성되는 유도 표면과 수신 장비에 대역 외 통신 채널에서 사용자 키 코드를 전송하도록 추가로 구성되는 제어기 디바이스를 추가로 포함하고, 유효 키 코드에 대한 사용자 키 코드의 긍정적인 비교는 유도 표면과로부터 획득된 전기 에너지를 전기 부하로 전달하기 위한 허가를 표시한다.

[0008] 일 실시예에서, 예시적인 방법은 유도 표면과 수신 구조물에 결합된 처리 회로를 통해 사용자 키 코드를 획득하는 단계; 유도 표면과 수신 구조물을 사용하여 유도 표면과의 형태로 전기 에너지를 수신하는 단계- 전기 에너지에는 유효 키 코드가 임베딩됨 -; 사용자 키 코드를 획득하기 위해 처리 회로를 통해 유도 표면을 처리하는 단계; 유효 키 코드에 대해 비교하기 위한 사용자 키 코드를 처리 회로를 통해 검증하는 단계- 처리 회로는 사용자 키 코드가 무효화되는 것에 응답하여 유도 표면과로부터의 전기 에너지의 전기 부하로의 전달을 디스에이블하도록 적응됨 -; 및 검증된 사용자 키 코드에 응답하여 유도 표면과 수신 구조물에 결합된 전기 부하에 전기 에너지를 공급하는 단계를 포함한다.

[0009] 본 개시내용의 다른 시스템들, 방법들, 특징들, 및 장점들은 이하의 도면들 및 상세한 설명을 검토할 때 통상의 기술자에게 명백할 것이거나 명백해질 것이다. 모든 이러한 부가의 시스템들, 방법들, 특징들, 및 장점들이 이 설명 내에 포함되고, 본 개시내용의 범위 내에 있으며, 첨부된 청구항들에 의해 보호되는 것으로 의도되어 있다.

[0010] 그에 부가하여, 기술된 실시예들의 모든 임의적이고 바람직한 특징들 및 수정들이 본원에 교시되는 개시내용 전체의 모든 양태들에서 사용가능하다. 게다가, 종속 청구항들의 개별적인 특징들은 물론, 기술된 실시예들의 모

든 임의적이고 바람직한 특징들 및 수정들이 서로 조합가능하고 상호교환가능하다.

도면의 간단한 설명

[0011]

본 개시내용의 많은 양태들이 이하의 도면들을 참조하여 더 잘 이해될 수 있다. 도면들 내의 컴포넌트들이 꼭 일정 축척으로 되어 있는 것은 아니며, 그 대신에 본 개시내용의 원리들을 명확하게 예시하는 것에 중점을 두고 있다. 더욱이, 도면들에서, 유사한 참조 번호들은 몇 개의 도면에 걸쳐 대응하는 부분들을 가리킨다.

도 1은 필드 강도(field strength)를 유도 전자기 필드(guided electromagnetic field) 및 방사 전자기 필드(radiated electromagnetic field)에 대한 거리의 함수로서 나타낸 차트.

도 2는 본 개시내용의 다양한 실시예들에 따른 유도 표면과의 전송을 위해 이용되는 2개의 영역을 갖는 전파 계면을 예시한 도면.

도 3은 본 개시내용의 다양한 실시예들에 따른 도 2의 전파 계면에 대해 배치된 유도 표면 도파로 프로브를 예시한 도면.

도 4는 본 개시내용의 다양한 실시예들에 따른 1차 Hankel 함수들의 근위(close-in) 및 원위(far-out) 점근선들의 크기들의 일 예의 플롯.

도 5a 및 도 5b는 본 개시내용의 다양한 실시예들에 따른 유도 표면 도파로 프로브에 의해 합성된 전기 필드의 복소 입사각을 예시한 도면.

도 6은 본 개시내용의 다양한 실시예들에 따른 도 5a의 전기 필드가 브루스터 각(Brewster angle)으로 손실형 전도성 매체(lossy conducting medium)와 교차하는 위치에 대한 충전 단자의 고도의 효과를 예시한 그래픽 표현.

도 7은 본 개시내용의 다양한 실시예들에 따른 유도 표면 도파로 프로브의 일 예의 그래픽 표현.

도 8a 내지 도 8c는 본 개시내용의 다양한 실시예들에 따른 도 3 및 도 7의 유도 표면 도파로 프로브의 등가 이미지 평면 모델의 예들을 예시한 그래픽 표현.

도 9a 및 도 9b는 본 개시내용의 다양한 실시예들에 따른 도 8b 및 도 8c의 등가 이미지 평면 모델들의 단선 전송 라인 모델 및 고전적인 전송 라인 모델의 예들을 예시한 그래픽 표현.

도 10은 본 개시내용의 다양한 실시예들에 따른 손실형 전도성 매체의 표면을 따라 유도 표면파를 발진시키기 위해 도 3 및 도 7의 유도 표면 도파로 프로브를 조절하는 것의 일 예를 예시한 플로차트.

도 11은 본 개시내용의 다양한 실시예들에 따른 도 3 및 도 7의 유도 표면 도파로 프로브의 파 경사각(wave tilt angle)과 위상 지연 사이의 관계의 일 예를 예시한 플롯.

도 12는 본 개시내용의 다양한 실시예들에 따른 유도 표면 도파로 프로브의 일 예를 예시한 도면.

도 13은 본 개시내용의 다양한 실시예들에 따른 Hankel 크로스오버 거리(Hankel crossover distance)에서 유도 표면 도파로 모드와 매칭하기 위해 합성 전기 필드가 복소 브루스터 각으로 입사하는 것을 예시한 그래픽 표현.

도 14는 본 개시내용의 다양한 실시예들에 따른 도 12의 유도 표면 도파로 프로브의 일 예의 그래픽 표현.

도 15a는 본 개시내용의 다양한 실시예들에 따른 유도 표면 도파로 프로브의 충전 단자(T_1)의 위상 지연(Φ_v)의 허수부 및 실수부의 일 예의 플롯을 포함하는 도면.

도 15b는 본 개시내용의 다양한 실시예들에 따른 도 14의 유도 표면 도파로 프로브의 개략 다이어그램.

도 16은 본 개시내용의 다양한 실시예들에 따른 유도 표면 도파로 프로브의 일 예를 예시한 도면.

도 17은 본 개시내용의 다양한 실시예들에 따른 도 16의 유도 표면 도파로 프로브의 일 예의 그래픽 표현.

도 18a 내지 도 18c는 본 개시내용의 다양한 실시예들에 따른 유도 표면 도파로 프로브에 의해 발진된 유도 표면파의 형태로 전송된 에너지를 수신하기 위해 이용될 수 있는 수신 구조물들의 예들을 도시한 도면.

도 18d는 본 개시내용의 다양한 실시예들에 따른 수신 구조물을 조절하는 것의 일 예를 예시한 플로차트.

도 19는 본 개시내용의 다양한 실시예들에 따른 유도 표면 도파로 프로브에 의해 발진된 유도 표면파의 형태로

전송된 에너지를 수신하기 위해 이용될 수 있는 부가의 수신 구조물의 일 예를 도시한 도면.

도 20a 내지 도 20e는 본 개시내용의 실시예들을 참조하여 사용되는 다양한 도식 기호들의 예들을 도시한 도면.

도 21은 본 개시내용의 실시예들에 따른 변조 회로 및 유도 표면과 서비스 제어기 디바이스를 포함하는 유도 표면 도파로 프로브의 일 예의 그래픽 표현을 도시한 도면.

도 22는 본 개시내용의 다양한 실시예들에 따른 인증 제어 환경을 도시한 도면.

도 23a 및 도 23b는 본 개시내용의 다양한 실시예들에 따라 사용자 인증을 수행하는 것과 관련된 동작들을 예시한 개략도들.

도 24는 본 개시내용의 다양한 실시예들에 따른 유도 표면과 수신 장비의 일부의 예시적인 동작을 예시한 플로차트.

도 25는 본 개시내용의 실시예들에 따른 유도 표면과 서비스 제어기 디바이스의 개략 블록도.

도 26은 본 개시내용의 실시예들에 따른 유도 표면과 수신 장비의 개략 블록도.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0012] 우선, 뒤따르는 개념들의 논의에서 명료성을 제공하기 위해 일부 용어가 확립되어야 한다. 먼저, 본원에서 고려되는 바와 같이, **방사** 전자기 필드(radiated electromagnetic field)들과 **유도** 전자기 필드(guided electromagnetic field)들 사이의 공식적 구분이 이루어진다.

[0013] 본원에서 고려되는 바와 같이, 방사 전자기 필드는 도파로에 속박되지 않은 파들의 형태로 소스 구조물로부터 방출되는 전자기 에너지를 포함한다. 예를 들어, 방사 전자기 필드는 일반적으로 안테나와 같은 전기 구조물을 벗어나 대기 또는 다른 매체를 통해 전파되고 어떠한 도파로 구조물에도 속박되지 않는 필드이다. 방사 전자기 파들이 안테나와 같은 전기 구조물을 벗어나면, 이들은 소스가 계속 동작하는지 여부에 관계없이 이들이 소실(dissipate)될 때까지 이들의 소스와 독립적으로 (공기와 같은) 전파 매체 속에서 계속 전파된다. 전자기파들이 방사되면, 이들은, 인터셉트되지 않는 한, 회수될 수 없으며, 인터셉트되지 않으면, 방사 전자기파에 내재된 에너지가 영원히 손실된다. 안테나들과 같은 전기 구조물들은 구조물 손실 저항에 대한 방사 저항의 비를 최대 화함으로써 전자기 필드들을 방사하도록 설계된다. 방사 에너지는 공간에서 확산되며 수신기가 존재하는지 여부에 관계없이 손실된다. 방사 필드들의 에너지 밀도는 기하학적 확산(geometric spreading)으로 인해 거리의 함수이다. 그에 따라, "방사"라는 용어는 그의 형태들 모두에서 본원에서 사용되는 바와 같이 이러한 형태의 전자기 전파(electromagnetic propagation)를 지칭한다.

[0014] 유도 전자기 필드는 전파하는 전자기파로서, 그의 에너지는 상이한 전자기 특성들을 갖는 매체들 사이의 경계들 내에 또는 그 근방에 집중된다. 이러한 의미에서, 유도 전자기 필드는 도파로에 속박되는 전자기 필드이고, 도파로에 흐르는 전류에 의해 전달되는 것으로 특징지어질 수 있다. 유도 전자기파에서 전달되는 에너지를 수신 및/또는 소실시키는 어떠한 부하도 없다면, 유도 매체(guiding medium)의 전도율(conductivity)에서 소실되는 에너지를 제외하고는 어떠한 에너지도 손실되지 않는다. 달리 말하면, 유도 전자기파에 대한 어떠한 부하도 없다면, 어떠한 에너지도 소비되지 않는다. 따라서, 유도 전자기 필드를 생성하는 발생기 또는 다른 소스는, 저항성 부하가 존재하지 않는 한, 유효 전력(real power)을 전달하지 않는다. 이 때문에, 이러한 발생기 또는 다른 소스는 부하가 제공될 때까지 본질적으로 무부하(idle) 작동한다. 이것은 어떠한 전기 부하도 없는 전력 라인들을 통해 전송되는 60 헤르츠 전자기파를 생성하기 위해 발생기를 작동시키는 것과 유사하다. 유도 전자기 필드 또는 유도 전자기파가 "전송 라인 모드(transmission line mode)"라고 지칭되는 것과 동등한 것임에 주목해야 한다. 이것은 방사파들을 생성하기 위해 항상 유효 전력이 공급되는 방사 전자기파들과 대조된다. 방사 전자기파들과 달리, 유도 전자기 에너지는 에너지 소스가 턴 오프된 후에 유한 길이 도파로를 따라 계속 전파하지 않는다. 그에 따라, "유도(guide)"라는 용어는 그의 형태들 모두에서 본원에서 사용되는 바와 같이 전자기 전파의 이러한 전송 모드를 지칭한다.

[0015] 이제 도 1을 참조하면, 방사 전자기 필드와 유도 전자기 필드 사이의 구분을 추가로 예시하기 위해 로그-dB 플롯 상에 킬로미터 단위의 거리의 함수로서, 임의적 기준으로부터 데시벨(dB)로 표시된, 미터 당 볼트 단위의 필드 강도의 그래프(100)가 도시되어 있다. 도 1의 그래프(100)는 유도 전자기 필드의 필드 강도를 거리의 함수로서 나타내는 유도 필드 강도 곡선(103)을 도시하고 있다. 이 유도 필드 강도 곡선(103)은 전송 라인 모드와 본질적으로 동일하다. 또한, 도 1의 그래프(100)는 방사 전자기 필드의 필드 강도를 거리의 함수로서 나타내는

방사 필드 강도 곡선(106)을 도시하고 있다.

[0016] 유도파에 대한 곡선(103) 및 방사 전파에 대한 곡선(106)의 형상들이 관심 대상이다. 방사 필드 강도 곡선(106)은 기하학적으로 강하하고($1/d$, 여기서 d 는 거리임), 이것은 로그-로그 스케일에서 직선으로 나타내어진다. 다른 한편으로, 유도 필드 강도 곡선(103)은 $e^{-\alpha d}/\sqrt{d}$ 의 특성 지수 감쇠(characteristic exponential decay)를 갖고 로그-로그 스케일에서 특유의 변곡부(knee)(109)를 나타낸다. 유도 필드 강도 곡선(103) 및 방사 필드 강도 곡선(106)은 교차 거리(crossing distance)에 있는 지점(112)에서 교차한다. 교차 지점(112)에서의 교차 거리보다 작은 거리들에서, 유도 전자기 필드의 필드 강도는 방사 전자기 필드의 필드 강도보다 대부분의 위치들에서 상당히 더 크다. 교차 거리보다 큰 거리들에서는, 그 반대이다. 따라서, 유도 및 방사 필드 강도 곡선들(103 및 106)은 유도 전자기 필드와 방사 전자기 필드 간의 기본적인 전파 차이점을 추가로 예시하고 있다. 유도 전자기 필드와 방사 전자기 필드 간의 차이에 대한 비공식적 논의에 대해서는, [Milligan, T., Modern Antenna Design, McGraw-Hill, 1st Edition, 1985, pp.8-9] - 참조에 의해 그 전체가 본원에 원용됨 - 를 참조한다.

[0017] 앞서 이루어진, 방사 전자기파와 유도 전자기파 사이의 구분은, 공식적으로 쉽게 표현되고 엄격한 기준에 기초한다. 2개의 이러한 다양한 해결책들이 하나의 동일한 선형 편미분 방정식인, 파동 방정식으로부터 나올 수 있다는 것은 문제에 부가되는 경계 조건들로부터 해석적으로 당연히 얻어진다. 파동 방정식 그 자체에 대한 그린 함수(Green function)는 방사파와 유도파의 특성 사이의 구분을 포함한다.

[0018] 빈 공간에서, 파동 방정식은 미분 연산자로서 그의 고유함수(eigenfunction)들은 복소 파수 평면(complex wave-number plane) 상에서 고유값(eigenvalue)들의 연속 스펙트럼을 갖는다. 이 TEM(transverse electro-magnetic) 필드는 방사 필드(radiation field)라고 불리며, 그 전파하는 필드(propagating field)들은 "헤르츠 파(Hertzian wave)"들"이라고 불린다. 그렇지만, 전도성 경계(conducting boundary)의 존재 시에, 파동 방정식과 경계 조건들은, 수학적으로, 이산 스펙트럼들의 합과 연속 스펙트럼으로 이루어진 파수들의 스펙트럼 표현으로 이어진다. 이를 위해, [Sommerfeld, A., "Über die Ausbreitung der Wellen in der Drahtlosen Telegraphie," Annalen der Physik, Vol. 28, 1909, pp. 665-736]을 참조한다. 또한, 문헌 [Sommerfeld, A., "Problems of Radio," published as Chapter 6 in Partial Differential Equations in Physics - Lectures on Theoretical Physics: Volume VI, Academic Press, 1949, pp. 236-289, 295-296]; [Collin, R. E., "Hertzian Dipole Radiating Over a Lossy Earth or Sea: Some Early and Late 20th Century Controversies," IEEE Antennas and Propagation Magazine, Vol. 46, No. 2, April 2004, pp. 64-79]; 및 [Reich, H. J., Ordnung, P.F, Krauss, H.L., and Skalnik, J.G., Microwave Theory and Techniques, Van Nostrand, 1953, pp. 291-293] - 이 참조문헌들 각각은 참조에 의해 그 전체가 본원에 원용됨 - 을 참조한다.

[0019] "지상파(ground wave)" 및 "표면파(surface wave)"라는 용어들은 2개의 뚜렷하게 상이한 물리적 전파 현상을 가리킨다. 표면파는, 해석적으로, 평면파 스펙트럼에 이산 성분(discrete component)을 산출하는 뚜렷한 극점(distinct pole)으로 인해 생긴다. 예컨대, 문헌 ["The Excitation of Plane Surface Waves" by Cullen, A.L., (Proceedings of the IEE (British), Vol. 101, Part IV, August 1954, pp. 225-235)]를 참조한다. 이러한 맥락에서, 표면파는 유도 표면파(guided surface wave)인 것으로 간주된다. (Zenneck-Sommerfeld 유도파 의미에서의) 표면파는, 물리적으로 그리고 수학적으로, 이제 라디오 방송으로부터 친숙한 (Weyl-Norton-FCC의 의미에서의) 지상파와 동일하지 않다. 이 2개의 전파 메커니즘은 복소 평면에서의 상이한 유형들의 고유값 스펙트럼들(연속체 또는 이산)의 여기(excitation)로부터 생긴다. 유도 표면파의 필드 강도는, 도 1의 곡선(103)에 의해 예시된 바와 같이, 거리에 따라 지수적으로 감쇠하고(손실형 도파로(lossy waveguide)에서의 전파와 거의 유사함), 구형으로 전파하는 지상파의 고전적인 헤르츠 방사와는 달리, 방사상 전송 라인(radial transmission line)에서의 전파와 유사하고, 고유값들의 연속체를 가지며, 도 1의 곡선(106)에 의해 예시된 바와 같이 기하학적으로 강하하고, 브랜치-컷 적분(branch-cut integral)들로부터 얻어진다. 문헌 ["The Surface Wave in Radio Propagation over Plane Earth" (Proceedings of the IRE, Vol. 25, No. 2, February, 1937, pp. 219-229)] 및 ["The Surface Wave in Radio Transmission" (Bell Laboratories Record, Vol. 15, June 1937, pp. 321-324)]에서 C.R. Burrows에 의해 실험적으로 입증된 바와 같이, 수직 안테나들이 지상파들은 방사하지만 유도 표면파들은 발진(launch)시키지 않는다.

[0020] 상술한 바를 요약하면, 첫째, 브랜치-컷 적분들에 대응하는, 파수 고유값 스펙트럼의 연속 부분은 방사 필드를 생성하고, 둘째, 적분 경로(contour of integration)에 의해 둘러싸인 극점들로부터 생기는 이산 스펙트럼들 및 대응하는 유수 합(residue sum)은 전파에 대해 횡방향으로 지수적으로 감쇠(damp)하는 비-TEM 진행 표면파(non-

TEM traveling surface wave)들을 초래한다. 이러한 표면파들은 유도 전송 라인 모드(guided transmission line mode)들이다. 추가 설명에 대해서는, [Friedman, B., Principles and Techniques of Applied Mathematics, Wiley, 1956, pp. pp. 214, 283-286, 290, 298-300]을 참조한다.

[0021] 자유 공간에서, 안테나들은, E_z 와 H_ϕ 가 동위상(in-phase)인 외향으로 전파하는(outwardly propagating) RF 에너지가 영원히 손실되는 방사 필드인, 파동 방정식의 연속체 고유값들을 여기서킨다. 다른 한편으로, 도파로 프로브들은 이산 고유값들을 여기서키고, 이는 전송 라인 전파를 초래한다. 문헌 [Collin, R. E., Field Theory of Guided Waves, McGraw-Hill, 1960, pp. 453, 474-477]을 참조한다. 이러한 이론적 분석들은 손실형 균질 매체(lossy, homogeneous media)의 평면형 또는 구형 표면들 위에 개방 표면 유도파(open surface guided wave)들을 발진시키는 가설적 가능성을 제공하였지만, 한 세기 이상 동안, 임의의 실용적 효율로 이것을 달성하기 위한 공학 기술 분야들에서의 어떠한 공지된 구조물들도 존재하지 않았다. 불행하게도, 앞서 기재된 이론적 분석은, 1900년대 초에 출현한 이후로, 본질적으로 이론으로 남아 있었으며, 손실형 균질 매체의 평면형 또는 구형 표면들 위에 개방 표면 유도파들을 발진시키는 것을 실용적으로 달성하기 위한 어떠한 공지된 구조물들도 없었다.

[0022] 본 개시내용의 다양한 실시예들에 따르면, 손실형 전도성 매체의 표면을 따라 유도 표면 도파로 모드에 결합되는 전기 필드들을 여기서키도록 구성되는 다양한 유도 표면 도파로 프로브들이 기술된다. 이러한 유도 전자기 필드들은 크기 및 위상이 손실형 전도성 매체의 표면 상의 유도 표면파 모드에 실질적으로 모드-매칭된다. 이러한 유도 표면파 모드는 Zenneck 도파로 모드라고도 지칭될 수 있다. 본원에 기술되는 유도 표면 도파로 프로브들에 의해 여기서되는 결과적인 필드들이 손실형 전도성 매체의 표면 상에서의 유도 표면 도파로 모드에 실질적으로 모드-매칭된다는 사실로 인해, 유도 표면파 형태의 유도 전자기 필드가 손실형 전도성 매체의 표면을 따라 발진된다. 일 실시예에 따르면, 손실형 전도성 매체는 지구와 같은 지상 매체(terrestrial medium)를 포함한다.

[0023] 도 2를 참조하면, Jonathan Zenneck의 논문 [Zenneck, J., "On the Propagation of Plane Electromagnetic Waves Along a Flat Conducting Surface and their Relation to Wireless Telegraphy," *Annalen der Physik*, Serial 4, Vol. 23, September 20, 1907, pp. 846-866]에 기재된 바와 같이 Jonathan Zenneck에 의해 1907년에 도출(derive)된 Maxwell의 방정식들에 대한 경계값 해(boundary value solution)들에 대한 검토를 제공하는 전파 계면(propagation interface)이 도시되어 있다. 도 2는 영역 1로서 지정된 손실형 전도성 매체와 영역 2로서 지정된 절연체 사이의 계면을 따라 방사상으로 전파하는 파들에 대한 원통 좌표들을 도시하고 있다. 영역 1은, 예를 들어, 임의의 손실형 전도성 매체를 포함할 수 있다. 일 예에서, 이러한 손실형 전도성 매체는 지구 또는 다른 매체와 같은 지상 매체를 포함할 수 있다. 영역 2는 영역 1과 경계 계면을 공유하고 영역 1에 대해 상이한 구성 파라미터들을 갖는 제2 매체이다. 영역 2는, 예를 들어, 대기 또는 다른 매체와 같은 임의의 절연체를 포함할 수 있다. 이러한 경계 계면에 대한 반사 계수는 복소 브루스터 각(complex Brewster angle)으로의 입사에 대해서만 0이 된다. 문헌 [Stratton, J. A., Electromagnetic Theory, McGraw-Hill, 1941, p. 516]을 참조한다.

[0024] 다양한 실시예들에 따르면, 본 개시내용은 영역 1을 포함하는 손실형 전도성 매체의 표면 상에서의 유도 표면 도파로 모드에 실질적으로 모드-매칭되는 전자기 필드들을 생성하는 다양한 유도 표면 도파로 프로브들을 기재하고 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 이러한 전자기 필드들은 제로 반사(zero reflection)를 초래할 수 있는 손실형 전도성 매체의 복소 브루스터 각으로 입사하는 파면(wave front)을 실질적으로 합성한다.

[0025] 추가로 설명하기 위해, $e^{j\omega t}$ 필드 변동(field variation)이 가정되고 $\rho \neq 0$ 및 $z \geq 0$ (원통 좌표들에서 z 는 영역 1의 표면에 수직인 수직 좌표이고 ρ 는 반경방향 치수(radial dimension)임)인 영역 2에서, 계면을 따라 경계 조건들을 충족시키는 Maxwell의 방정식들의 Zenneck의 폐쇄형 엄밀해(closed-form exact solution)는 다음과 같은 전기 필드 및 자기 필드 성분들에 의해 표현된다:

[0026] [수학식 1]

[0027]
$$H_{2\phi} = Ae^{-u_2 z} H_1^{(2)}(-j\gamma\rho)$$

[0028] [수학식 2]

$$E_{2\rho} = A \left(\frac{u_2}{j\omega\epsilon_0} \right) e^{-u_2 z} H_1^{(2)}(-j\gamma\rho)$$

[0029]

[0030] [수학식 3]

$$E_{2z} = A \left(\frac{-\gamma}{\omega\epsilon_0} \right) e^{-u_2 z} H_0^{(2)}(-j\gamma\rho)$$

[0031]

[0032] $e^{j\omega t}$ 필드 변동이 가정되고 $\rho \neq 0$ 및 $z \leq 0$ 인 영역 1에서, 계면을 따라 경계 조건들을 충족시키는 Maxwell의 방정식들의 Zenneck의 폐쇄형 엄밀해는 다음과 같은 전기 필드 및 자기 필드 성분들에 의해 표현된다:

[0033] [수학식 4]

$$H_{1\phi} = A e^{u_1 z} H_1^{(2)}(-j\gamma\rho)$$

[0034]

[0035] [수학식 5]

$$E_{1\rho} = A \left(\frac{-u_1}{\sigma_1 + j\omega\epsilon_1} \right) e^{u_1 z} H_1^{(2)}(-j\gamma\rho)$$

[0036]

[0037] [수학식 6]

$$E_{1z} = A \left(\frac{-j\gamma}{\sigma_1 + j\omega\epsilon_1} \right) e^{u_1 z} H_0^{(2)}(-j\gamma\rho)$$

[0038]

[0039] 이 표현식들에서, z 는 영역 1의 표면에 수직인 수직 좌표이고, ρ 는 반경방향 좌표(radial coordinate)이며, $H_n^{(2)}(-j\gamma\rho)$ 는 제2종(second kind) n 차(order n) 복소 편각 Hankel 함수(complex argument Hankel function)이고, u_1 은 영역 1에서의 양의 수직(z) 방향의 전파 상수이며, u_2 는 영역 2에서의 수직(z) 방향의 전파 상수이고, σ_1 은 영역 1의 전도율이고, $\omega = 2\pi f$ - 여기서, f 는 여기 주파수임 -이며, ϵ_0 는 자유 공간의 유전율이고, ϵ_1 은 영역 1의 유전율이며, A 는 소스에 의해 부과되는 소스 상수이고, γ 는 표면파 방사상 전파 상수(surface wave radial propagation constant)이다.

[0040] $\pm z$ 방향들에서의 전파 상수들은 영역 1과 영역 2 사이의 계면 위 및 아래에서 파동 방정식을 분리시키고 경계 조건들을 부과함으로써 결정된다. 이렇게 하는 것은, 영역 2에서, 수학식 7을 제공하고,

[0041] [수학식 7]

$$u_2 = \frac{-jk_0}{\sqrt{1 + (\epsilon_r - jx)}}$$

[0042]

[0043] 영역 1에서, 수학식 8을 제공한다.

[0044] [수학식 8]

$$u_1 = -u_2(\epsilon_r - jx)$$

[0045]

[0046] 방사상 전파 상수(γ)는 수학식 9에 의해 주어지고,

[0047] [수학식 9]

$$\gamma = j\sqrt{k_0^2 + u_2^2} = j\frac{k_0 n}{\sqrt{1 + n^2}}$$

[0048]

[0049] 이것은 n 이 수학식 10에 의해 주어지는 복소 굴절률인 복소 표현식이다.

[0050] [수학식 10]

$$n = \sqrt{\epsilon_r - jx}$$

[0052] 이상의 수학식들 모두에서,

[0053] [수학식 11]

$$x = \frac{\sigma_1}{\omega \epsilon_0}$$

[0055] 이고,

[0056] [수학식 12]

$$k_o = \omega \sqrt{\mu_o \epsilon_o} = \frac{\lambda_o}{2\pi}$$

[0058] 이며, 여기서 ϵ_r 은 영역 1의 상대 투자율을 포함하고, σ_1 은 영역 1의 전도율이며, ϵ_o 은 자유 공간의 투자율 이고, μ_o 은 자유 공간의 투자율을 포함한다. 따라서, 생성된 표면파는 계면에 평행하게 전파하고, 그에 수직 으로는 지수적으로 감쇠한다. 이것은 소실(evanesence)이라고 알려져 있다.

[0059] 따라서, 수학식 1 내지 수학식 3은 원통-대칭이고 방사상으로 전파하는 도파로 모드(cylindrically-symmetric, radially-propagating waveguide mode)인 것으로 간주될 수 있다. 문헌 [Barlow, H. M., and Brown, J., Radio Surface Waves, Oxford University Press, 1962, pp. 10-12, 29-33]을 참조한다. 본 개시내용은 이러한 "개방 경계(open boundary)" 도파로 모드를 여기시키는 구조물들을 상술한다. 구체적으로는, 다양한 실시예들 에 따르면, 유도 표면 도파로 프로브는, 전압 및/또는 전류를 공급받고 영역 2와 영역 1 사이의 경계 계면에 대 해 위치되는, 적절한 크기의 충전 단자를 구비하고 있다. 이것은 도 3을 참조하여 보다 잘 이해될 수 있으며, 도 3은 손실형 전도성 매체(203)에 의해 제공되는 평면에 수직인 수직 축(z)을 따라 손실형 전도성 매체(203) (예컨대, 지구)보다 위로 상승되어 있는 충전 단자(charge terminal)(T₁)를 포함하는 유도 표면 도파로 프로브 (200a)의 일 예를 도시하고 있다. 손실형 전도성 매체(203)는 영역 1을 구성하고, 제2 매체(206)는 영역 2를 구성하며 손실형 전도성 매체(203)와 경계 계면을 공유한다.

[0060] 일 실시예에 따르면, 손실형 전도성 매체(203)는 지구라는 행성과 같은 지상 매체를 포함할 수 있다. 이를 위 해, 이러한 지상 매체는 자연적인 것이든 인공적인 것이든 간에 그 위에 포함된 모든 구조물들 또는 형태들을 포함한다. 예를 들어, 이러한 지상 매체는 바위, 토양, 모래, 담수, 해수, 나무들, 초목, 및 우리의 행성을 구 성하는 모든 다른 자연적 요소들과 같은 자연적 요소들을 포함할 수 있다. 그에 부가하여, 이러한 지상 매체는 콘크리트, 아스팔트, 건축 재료들, 및 다른 인공 재료들과 같은 인공적 요소들을 포함할 수 있다. 다른 실시예 들에서, 손실형 전도성 매체(203)는, 자연적으로 발생한 것이든 인공적인 것이든 간에, 지구 이외의 어떤 매체 를 포함할 수 있다. 다른 실시예들에서, 손실형 전도성 매체(203)는, 자동차들, 항공기, 인공적 재료들(합판, 플라스틱 시트, 또는 다른 재료들 등) 또는 다른 매체들과 같은 인공적 표면들 및 구조물들과 같은 다른 매체들 을 포함할 수 있다.

[0061] 손실형 전도성 매체(203)가 지상 매체 또는 지구를 포함하는 경우에, 제2 매체(206)는 지면 위의 대기를 포함할 수 있다. 이와 같이, 대기는, 지구의 대기를 이루고 있는 공기 및 다른 요소들을 포함하는, "대기 매체 (atmospheric medium)"라고 지칭될 수 있다. 그에 부가하여, 제2 매체(206)는 손실형 전도성 매체(203)에 대 해 다른 매체들을 포함할 수 있다.

[0062] 유도 표면 도파로 프로브(200a)는 여기 소스(212)를, 예컨대, 수직 공급 라인 전도체(vertical feed line conductor)를 거쳐 충전 단자(T₁)에 결합시키는 공급 네트워크(feed network)(209)를 포함한다. 다양한 실시예 들에 따르면, 임의의 주어진 순간에 단자(T₁)에 인가되는 전압에 기초하여 전기 필드를 합성하기 위해 전하(Q₁) 가 충전 단자(T₁) 상에 부여된다. 전기 필드(E)의 입사각(Θ_i)에 따라, 영역 1을 포함하는 손실형 전도성 매체 (203)의 표면 상의 유도 표면 도파로 모드에 전기 필드를 실질적으로 모드-매칭시키는 것이 가능하다.

[0063] 수학식 1 내지 수학식 6의 Zenneck 폐쇄형 해들을 고려함으로써, 영역 1과 영역 2 사이의 Leontovich 임피던스

경계 조건은 수학식 13으로서 서술될 수 있고,

[0064] [수학식 13]

$$\hat{z} \times \vec{H}_2(\rho, \varphi, 0) = \vec{J}_s$$

여기서 $\hat{z}$ 는 양의 수직(+z) 방향에서의 단위 법선이고, $\vec{H}_2$ 는 상기 수학식 1에 의해 표현된 영역 2에서의 자기 필드 강도이다. 수학식 13은 수학식 1 내지 수학식 3에 명시된 전기 및 자기 필드들이 경계 계면을 따라 방사상 표면 전류 밀도를 초래할 수 있다는 것을 암시하며, 여기서 방사상 표면 전류 밀도는 수학식 14에 의해 명시될 수 있고,

[0067] [수학식 14]

$$J_\rho(\rho') = -A H_1^{(2)}(-j\gamma\rho')$$

여기서 A는 상수이다. 게다가, 유도 표면 도파로 프로브(200)에 대한 근위(close-in)에서($\rho \ll \lambda$ 에 대해), 상기 수학식 14는 수학식 15의 거동을 갖는다는 점에 주목해야 한다.

[0070] [수학식 15]

$$J_{close}(\rho') = \frac{-A(j2)}{\pi(-j\gamma\rho')} = -H_\phi = -\frac{I_o}{2\pi\rho'}$$

음의 부호는, 소스 전류(I_o)가 도 3에 예시된 바와 같이 수직 방향으로 흐를 때, "근위" 접지 전류가 방사상으로 *내향*으로 흐른다는 것을 의미한다. "근위"에서의 H_ϕ 에 관한 필드 매칭에 의해, 수학식 16이라고 결정될 수 있고,

[0073] [수학식 16]

$$A = -\frac{I_o\gamma}{4} = -\frac{\omega q_1\gamma}{4}$$

여기서, 수학식 1 내지 수학식 6 및 수학식 14에서, $q_1 = C_1V_1$ 이다. 따라서, 수학식 14의 방사상 표면 전류 밀도는 수학식 17로서 서술될 수 있다.

[0076] [수학식 17]

$$J_\rho(\rho') = \frac{I_o\gamma}{4} H_1^{(2)}(-j\gamma\rho')$$

수학식 1 내지 수학식 6 및 수학식 17에 의해 표현되는 필드들은, 지상파 전파와 연관되어 있는 *방사 필드들이 아닌*, 손실형 계면에 속박된 *전송 라인 모드*의 특성을 갖는다. 문헌 [Barlow, H. M. and Brown, J., Radio Surface Waves, Oxford University Press, 1962, pp. 1-5]를 참조한다.

이 시점에서, 파동 방정식의 이 해들에 대해 수학식 1 내지 수학식 6 및 수학식 17에서 사용되는 Hankel 함수들의 특성의 고찰이 제공된다. 제1종 및 제2종 n차 Hankel 함수들이 제1종 및 제2종 표준 Bessel 함수들의 복소 조합들로서 정의된다는 것을 알 수 있다.

[0080] [수학식 18]

$$H_n^{(1)}(x) = J_n(x) + jN_n(x)$$

[0082] [수학식 19]

$$H_n^{(2)}(x) = J_n(x) - jN_n(x)$$

[0084] 이 함수들은, 각각, 방사상으로 내향으로 $(H_n^{(1)})$ 그리고 외향으로 $(H_n^{(2)})$ 전파하는 원통형 파들을 나타낸다. 이 정의는 관계 $e^{\pm jx} = \cos x \pm j \sin x$ 와 유사하다. 예를 들어, 문헌 [Harrington, R. F., Time-Harmonic Fields, McGraw-Hill, 1961, pp. 460-463]을 참조한다.

[0085] $H_n^{(2)}(k_\rho \rho)$ 가 유출파(outgoing wave)라는 것이 $J_n(x)$ 및 $N_n(x)$ 의 급수 정의(series definition)들로부터 직접적으로 획득되는 그의 대각 점근 거동(large argument asymptotic behavior)으로부터 인식될 수 있다. 유도 표면 도파로 프로브로부터의 원위에서:

[0086] [수학식 20a]

$$H_n^{(2)}(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{2j}{\pi x}} j^n e^{-jx} = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} j^n e^{-j(x - \frac{\pi}{4})}$$

[0087]

[0088] 이는 $e^{j\omega t}$ 와 곱해질 때, $1/\sqrt{\rho}$ 공간 변동을 갖는 형태 $e^{j(\omega t - k\rho)}$ 의 외향으로 전파하는 원통형 파(outward propagating cylindrical wave)이다. 1차($n = 1$) 해는 수학식 20a로부터 수학식 20b인 것으로 결정될 수 있다.

[0089] [수학식 20b]

$$H_1^{(2)}(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} j \sqrt{\frac{2j}{\pi x}} e^{-jx} = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} e^{-j(x - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4})}$$

[0090]

[0091] 유도 표면 도파로 프로브에 대한 근위에서($\rho \ll \lambda$ 에 대해), 제2종 1차 Hankel 함수는 수학식 21과 같이 거동한다.

[0092] [수학식 21]

$$H_1^{(2)}(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{2j}{\pi x}$$

[0093]

[0094] 이러한 점근식(asymptotic expression)들이 복소량(complex quantity)들이라는 점에 주목한다. x 가 실수량(real quantity)일 때, 수학식 20b와 수학식 21은 $\sqrt{j}$ - 이는 45° 또는, 등가적으로, $\lambda/8$ 의 추가 위상 전진(extra phase advance) 또는 "위상 부스트(phase boost)"에 대응함 - 만큼 위상이 상이하다. 제2종 1차 Hankel 함수의 근위 및 원위 점근선들은, 이들이 $\rho = R_x$ 의 거리에서 동일한 크기인, Hankel "크로스오버" 지점("crossover" point) 또는 전이 지점(transition point)을 갖는다.

[0095] 따라서, Hankel 크로스오버 지점을 넘어서면, "원위" 표현이 Hankel 함수의 "근위" 표현보다 우세하다. Hankel 크로스오버 지점까지의 거리(또는 Hankel 크로스오버 거리(Hankel crossover distance))는 $-j\gamma\rho$ 에 대해 수학식 20b와 수학식 21을 같다고 놓고 R_x 에 대해 푸는 것에 의해 구해질 수 있다. $x = \sigma/\omega\epsilon_0$ 인 경우, 원위 및 근위 Hankel 함수 점근선들이 주파수 의존적이고, 주파수가 낮아짐에 따라 Hankel 크로스오버 지점이 밖으로 이동한다는 것을 알 수 있다. 손실형 전도성 매체의 전도율(σ)이 변화함에 따라 Hankel 함수 점근선들이 또한 변할 수 있다는 점에 또한 주목해야 한다. 예를 들어, 토양의 전도율이 기상 상태들의 변화들에 따라 변할 수 있다.

[0096] 도 4를 참조하면, 1850 kHz의 동작 주파수에서, $\epsilon_r = 15$ 의 상대 유전율 및 $\sigma = 0.010$ mhos/m의 전도율인 영역 1에 대하여 수학식 20b 및 수학식 21의 1차 Hankel 함수들의 크기들의 플롯의 일 예가 도시되어 있다. 곡선(115)은 수학식 20b의 원위 점근선의 크기이고, 곡선(118)은 수학식 21의 근위 점근선의 크기이며, Hankel 크로스오버 지점(121)은 $R_x = 54$ 피트의 거리에서 발생한다. 크기들은 동일하지만, Hankel 크로스오버 지점(121)에서 2개의 점근선 사이에 위상 오프셋이 존재한다. Hankel 크로스오버 거리가 동작 주파수의 파장보다 훨씬 더

작다는 것을 또한 알 수 있다.

[0097] 영역 2에서의 Zenneck 폐쇄형 해의 수학적식 2 및 수학적식 3에 의해 주어지는 전기 필드 성분들을 고려하면, E_z 와 E_ρ 의 비가 점근적으로 수학적식 22로 되고,

[0098] [수학적식 22]

[0099]
$$\frac{E_z}{E_\rho} = \left(\frac{-j\gamma}{u_2} \right) \frac{H_0^{(2)}(-j\gamma\rho)}{H_1^{(2)}(-j\gamma\rho)} \xrightarrow{\rho \rightarrow \infty} \sqrt{\epsilon_r - j \frac{\sigma}{\omega\epsilon_0}} = n = \tan \theta_i$$

[0100] 여기서 n 은 수학적식 10의 복소 굴절률이고, θ_i 는 전기 필드의 입사각이다. 그에 부가하여, 수학적식 3의 모드-매칭된 전기 필드의 수직 성분이 점근적으로 수학적식 23으로 되며,

[0101] [수학적식 23]

[0102]
$$E_{2z} \xrightarrow{\rho \rightarrow \infty} \left(\frac{q_{free}}{\epsilon_0} \right) \sqrt{\frac{\gamma^3}{8\pi}} e^{-u_2 z} \frac{e^{-j(\gamma\rho - \pi/4)}}{\sqrt{\rho}}$$

[0103] 수학적식 23은 단자 전압에 있는 상승된 충전 단자의 정전용량의 고립 컴포넌트(isolated component) 상의 자유 전하, $q_{free} = C_{free} \times V_1$ 에 선형적으로 비례한다.

[0104] 예를 들어, 도 3에서의 상승된 충전 단자(T_1)의 높이(H_1)가 충전 단자(T_1) 상의 자유 전하의 양에 영향을 미친다. 충전 단자(T_1)가 영역 1의 접지 평면(ground plane) 근방에 있을 때, 단자 상의 전하(Q_1)의 대부분은 "속박된다(bound)". 충전 단자(T_1)가 상승됨에 따라, 충전 단자(T_1)가 고립 전하의 실질적으로 전부가 자유 상태로 되는 높이에 도달할 때까지 속박 전하가 줄어든다.

[0105] 충전 단자(T_1)에 대한 용량성 고도(capacitive elevation)의 증가의 장점은 상승된 충전 단자(T_1) 상의 전하가 접지 평면으로부터 추가로 제거되어, 에너지를 유도 표면 도파로 모드에 결합시킬 자유 전하(q_{free})의 양의 증가를 초래한다는 것이다. 충전 단자(T_1)가 접지 평면으로부터 멀리 이동됨에 따라, 전하 분포는 단자의 표면 주위에 보다 균일하게 분포되게 된다. 자유 전하의 양은 충전 단자(T_1)의 자기 정전용량(self-capacitance)에 관련되어 있다.

[0106] 예를 들어, 구형 단자의 정전용량은 접지 평면으로부터의 물리적 높이의 함수로서 표현될 수 있다. 완전 접지면(perfect ground)으로부터 h 의 물리적 높이에 있는 구체의 정전용량은 수학적식 24에 의해 주어지고,

[0107] [수학적식 24]

[0108]
$$C_{\text{elevated sphere}} = 4\pi\epsilon_0 a (1 + M + M^2 + M^3 + 2M^4 + 3M^5 + \dots)$$

[0109] 여기서 구체의 직경은 $2a$ 이고, 여기서 $M = a/2h$ 이며, h 는 구형 단자의 높이이다. 알 수 있는 바와 같이, 단자 높이(h)의 증가는 충전 단자의 정전용량(C)을 감소시킨다. 직경의 약 4배 ($4D = 8a$)의 높이에 있는 충전 단자(T_1)의 고도들에 대해, 전하 분포가 구형 단자 주위에서 대략 균일하며, 이는 유도 표면 도파로 모드에의 결합을 향상시킬 수 있다는 것을 알 수 있다.

[0110] 충분히 고립된 단자의 경우에, 전도성 구체의 자기 정전용량은 $C = 4\pi\epsilon_0 a$ 에 의해 근사화될 수 있고, 여기서, a 는 미터 단위의 구체 반경이며, 디스크의 자기 정전용량은 $C = 8\epsilon_0 a$ 에 의해 근사화될 수 있고, 여기서, a 는 미터 단위의 디스크 반경이다. 충전 단자(T_1)는 구체, 디스크, 원통, 원추체, 원환체(torus), 후드(hood), 하나 이상의 링, 또는 임의의 다른 랜덤화된 형상이나 형상들의 조합과 같은 임의의 형상을 포함할 수 있다. 충전 단자(T_1)를 위치시키기 위해 등가 구체 직경(equivalent spherical diameter)이 결정되어 사용될 수 있다.

[0111] 이것은 충전 단자(T_1)가 손실형 전도성 매체(203)로부터 $h_p = H_1$ 의 물리적 높이로 상승되어 있는 도 3의 예를 참조하여 추가로 이해될 수 있다. "속박(bound)" 전하의 효과들을 감소시키기 위해, 충전 단자(T_1)가 속박 전하 효과들을 감소시키도록 충전 단자(T_1)의 구체 직경(또는 등가 구체 직경)의 4배 이상인 물리적 높이에 위치될 수 있다.

[0112] 다음에 도 5a를 참조하면, 도 3의 충전 단자(T_1) 상의 상승된 전하(Q_1)에 의해 생성된 전기 필드의 광선 광학 해석이 도시되어 있다. 광학에서와 같이, 입사 전기 필드의 반사를 최소화하는 것은 손실형 전도성 매체(203)의 유도 표면 도파로 모드에 결합되는 에너지를 향상 및/또는 최대화할 수 있다. 입사 평면(경계 계면이 아님)에 평행하게 편파(polarize)되는 전기 필드들($E_{||}$)에 대하여, 입사 전기 필드의 반사의 양은 수학식 25로서 표현될 수 있는 Fresnel 반사 계수를 사용하여 결정될 수 있고,

[0113] [수학식 25]

[0114]

$$\Gamma_{||}(\theta_i) = \frac{E_{||,R}}{E_{||,i}} = \frac{\sqrt{(\epsilon_r - jx) - \sin^2 \theta_i} - (\epsilon_r - jx) \cos \theta_i}{\sqrt{(\epsilon_r - jx) - \sin^2 \theta_i} + (\epsilon_r - jx) \cos \theta_i}$$

[0115] 여기서 θ_i 는 표면 법선에 대해 측정된 통상의 입사각이다.

[0116] 도 5a의 예에서, 광선 광학 해석은, 표면 법선($\hat{z}$)에 대해 측정되는, θ_i 의 입사각을 갖는 입사 평면에 평행하게 편파되는 입사 필드를 보여준다. $\Gamma_{||}(\theta_i) = 0$ 일 때 입사 전기 필드의 어떠한 반사도 없을 것이며, 따라서 입사 전기 필드는 손실형 전도성 매체(203)의 표면을 따라 유도 표면 도파로 모드에 완전히 결합될 것이다. 입사각이 수학식 26일 때 수학식 25의 분자가 0으로 된다는 것을 알 수 있고,

[0117] [수학식 26]

[0118]

$$\theta_i = \arctan(\sqrt{\epsilon_r - jx}) = \theta_{i,B}$$

[0119] 여기서 $x = \sigma / \omega \epsilon_o$ 이다. 이 복소 입사각($\theta_{i,B}$)은 브루스터 각이라고 지칭된다. 수학식 22를 다시 참조하면, 동일한 복소 브루스터 각($\theta_{i,B}$) 관계가 수학식 22 및 수학식 26 둘 다에 존재한다는 것을 알 수 있다.

[0120] 도 5a에 예시된 바와 같이, 전기 필드 벡터($\mathbf{E}$)는 입사 평면에 평행하게 편파된 유입 비균일 평면파(incoming non-uniform plane wave)로서 묘사될 수 있다. 전기 필드 벡터($\mathbf{E}$)는 수학식 27과 같이 독립적인 수평 및 수직 성분들로부터 생성될 수 있다.

[0121] [수학식 27]

[0122]

$$\vec{E}(\theta_i) = E_\rho \hat{\rho} + E_z \hat{z}$$

[0123] 기하학적으로, 도 5a에서의 예시는 전기 필드 벡터($\mathbf{E}$)가 수학식 28a 및 수학식 28b에 의해 주어질 수 있다는 것을 암시하고,

[0124] [수학식 28a]

[0125]

$$E_\rho(\rho, z) = E(\rho, z) \cos \theta_i$$

[0126] [수학식 28b]

[0127]

$$E_z(\rho, z) = E(\rho, z) \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta_i\right) = E(\rho, z) \sin \theta_i$$

[0128] 이는 필드 비가 수학식 29라는 것을 의미한다.

[0129] [수학식 29]

$$\frac{E_{\rho}}{E_z} = \frac{1}{\tan \theta_i} = \tan \psi_i$$

[0131] "파 경사(wave tilt)"라고 불리는 일반화된 파라미터(W)는 수학식 30a 및 수학식 30b에 의해 주어지는 수직 전기 필드 성분에 대한 수평 전기 필드 성분의 비로서 여기서 표기되고,

[0132] [수학식 30a]

$$W = \frac{E_{\rho}}{E_z} = |W|e^{j\Psi}$$

[0134] 또는

[0135] [수학식 30b]

$$\frac{1}{W} = \frac{E_z}{E_{\rho}} = \tan \theta_i = \frac{1}{|W|} e^{-j\Psi}$$

[0137] 이는 복소수이고 크기 및 위상 둘 다를 갖는다. 영역 2에서의 전자기파에 대하여, 파 경사각(wave tilt angle)(Ψ)은 영역 1과의 경계 계면에서의 파면의 법선과 이 경계 계면에 대한 접선 사이의 각도이다. 이것은 방사상 원통형 유도 표면파에 대해 전자기파의 등위상 표면들과 그들의 법선들을 예시하는 도 5b에서 보다 쉽게 알 수 있다. 완전 전도체와의 경계 계면($z = 0$)에서, 파면 법선은 경계 계면의 접선에 평행하고, 그 결과 $W = 0$ 이 된다. 그렇지만, 손실형 유전체의 경우에, 파면 법선이 $z = 0$ 에서 경계 계면의 접선과 평행하지 않기 때문에 파 경사(W)가 존재한다.

[0138] 유도 표면파에 수학식 30b를 적용하면 수학식 31이 주어진다.

[0139] [수학식 31]

$$\tan \theta_{i,B} = \frac{E_z}{E_{\rho}} = \frac{u_z}{v} = \sqrt{\epsilon_r - jx} = n = \frac{1}{W} = \frac{1}{|W|} e^{-j\Psi}$$

[0141] 복소 브루스터 각($\theta_{i,B}$)과 동일한 입사각에서, 수학식 25의 Fresnel 반사 계수가, 수학식 32에 의해 나타낸 바와 같이, 사라진다.

[0142] [수학식 32]

$$\Gamma_{\parallel}(\theta_{i,B}) = \frac{\sqrt{(\epsilon_r - jx) - \sin^2 \theta_i} - (\epsilon_r - jx) \cos \theta_i}{\sqrt{(\epsilon_r - jx) - \sin^2 \theta_i} + (\epsilon_r - jx) \cos \theta_i} \Big|_{\theta_i = \theta_{i,B}} = 0$$

[0144] 수학식 22의 복소 필드 비를 조절함으로써, 반사가 감소되거나 제거되는 복소 각도로 입사하도록 입사 필드가 합성될 수 있다. 이 비를 $n = \sqrt{\epsilon_r - jx}$ 로 설정하면 복소 브루스터 각으로 입사하는 합성 전기 필드가 얻어지고, 반사들이 사라진다.

[0145] 전기적 유효 높이(electrical effective height)의 개념은 유도 표면 도파로 프로브(200)에서 복소 입사각을 갖는 전기 필드를 합성하는 것에 대한 추가적 통찰을 제공할 수 있다. 전기적 유효 높이(h_{eff})는 h_p 의 물리적 높이(또는 길이)를 갖는 모노폴에 대해 수학식 33으로서 정의된다.

[0146] [수학식 33]

$$h_{eff} = \frac{1}{I_0} \int_0^{h_p} I(z) dz$$

[0148] 이 표현식이 구조물을 따라 소스 분포의 크기 및 위상에 의존하기 때문에, 유효 높이(또는 길이)는 일반적으로 복소수이다. 구조물의 분포 전류(distributed current) $I(z)$ 의 적분이 구조물의 물리적 높이(h_p)에 걸쳐 수행

되고, 구조물의 베이스(base)(또는 입력)를 통해 상향으로 흐르는 접지 전류(I_0)에 대해 정규화된다. 구조물을 따라 있는 분포 전류는 수학적 식 34에 의해 표현될 수 있고,

[수학적 식 34]

$$I(z) = I_c \cos(\beta_0 z)$$

여기서 β_0 는 구조물 상에서 전파하는 전류에 대한 전파 인자(propagation factor)이다. 도 3의 예에서, I_c 는 유도 표면 도파로 프로브(200a)의 수직 구조물을 따라 분포되는 전류이다.

예를 들어, 구조물의 저부에 저 손실 코일(예컨대, 나선형 코일)을 포함하는 공급 네트워크(209) 및 충전 단자(T_1)와 코일 사이에 연결되는 수직 공급 라인 전도체를 고려한다. 코일(또는 나선형 지연 라인)로 인한 위상 지연은, 물리적 길이가 l_c 이고 전파 인자가 수학적 식 35인 경우, $\theta_c = \beta_p l_c$ 이며,

[수학적 식 35]

$$\beta_p = \frac{2\pi}{\lambda_p} = \frac{2\pi}{V_f \lambda_0}$$

여기서 V_f 는 구조물 상의 속도 인자(velocity factor)이고, λ_0 는 공급된 주파수에서의 파장이며, λ_p 는 속도 인자 V_f 로부터 얻어지는 전파 파장이다. 위상 지연은 접지 (말뚝(stake)) 전류(I_0)에 대해 측정된다.

그에 부가하여, 수직 공급 라인 전도체의 길이(l_w)를 따른 공간적 위상 지연(spatial phase delay)은 $\theta_y = \beta_w l_w$ 에 의해 주어질 수 있고, 여기서 β_w 는 수직 공급 라인 전도체에 대한 전파 위상 상수(propagation phase constant)이다. 일부 구현들에서, 공간적 위상 지연은 $\theta_y = \beta_w h_p$ 에 의해 근사화되는데, 그 이유는 유도 표면 도파로 프로브(200a)의 물리적 높이(h_p)와 수직 공급 라인 전도체 길이(l_w) 사이의 차이가 공급된 주파수에서의 파장(λ_0)보다 훨씬 더 작기 때문이다. 그 결과, 코일 및 수직 공급 라인 전도체를 통한 총 위상 지연은 $\Phi = \theta_c + \theta_y$ 이고, 물리적 구조물의 저부로부터 코일의 상단으로 공급되는 전류는 수학적 식 36이며,

[수학적 식 36]

$$I_c(\theta_c + \theta_y) = I_0 e^{j\Phi}$$

총 위상 지연(Φ)은 접지 (말뚝) 전류(I_0)에 대해 측정된다. 결과적으로, 유도 표면 도파로 프로브(200)의 전기적 유효 높이는 물리적 높이 $h_p \ll \lambda_0$ 인 경우에 대해 수학적 식 37에 의해 근사화될 수 있다.

[수학적 식 37]

$$h_{eff} = \frac{1}{I_0} \int_0^{h_p} I_0 e^{j\Phi} \cos(\beta_0 z) dz \cong h_p e^{j\Phi}$$

Φ 의 각도(또는 위상 시프트)에서의 모노폴의 복소 유효 높이($h_{eff} = h_p$)가 소스 필드들을 유도 표면 도파로 모드에 매칭시키고 유도 표면파를 손실형 전도성 매체(203) 상에 발진시키도록 조절될 수 있다.

도 5a의 예에서, Hankel 크로스오버 거리(R_x)(121)에서 복소 브루스터 입사각($\theta_{i,B}$)을 갖는 입사 전기 필드(E)의 복소 각도 삼각법(complex angle trigonometry)을 예시하기 위해 광선 광학이 사용된다. 수학적 식 26으로부터, 손실형 전도성 매체에 대해, 브루스터 각이 복소수이고 수학적 식 38에 의해 명시된다는 것을 상기한다.

[수학적 식 38]

$$\tan \theta_{i,B} = \sqrt{\epsilon_r - j \frac{\sigma}{\omega \epsilon_0}} = n$$

[0166] 전기적으로, 기하학적 파라미터들은 수학식 39에 의해 충전 단자(T_1)의 전기적 유효 높이(h_{eff})에 의해 관련되어 있고,

[0167] [수학식 39]

$$R_x \tan \psi_{i,B} = R_x \times W = h_{eff} = h_p e^{j\Phi}$$

[0169] 여기서, $\Psi_{i,B} = (\pi/2) - \Theta_{i,B}$ 는 손실형 전도성 매체의 표면으로부터 측정된 브루스터 각이다. 유도 표면 도파로 모드에 결합하기 위해, Hankel 크로스오버 거리에서의 전기 필드의 파 경사는 수학식 40과 같이 전기적 유효 높이와 Hankel 크로스오버 거리의 비로서 표현될 수 있다.

[0170] [수학식 40]

$$\frac{h_{eff}}{R_x} = \tan \psi_{i,B} = W_{Rx}$$

[0172] 물리적 높이(h_p)와 Hankel 크로스오버 거리(R_x) 둘 다 실수량들이기 때문에, Hankel 크로스오버 거리(R_x)에서의 원하는 유도 표면과 경사각(Ψ)이 복소 유효 높이(h_{eff})의 위상(Φ)과 동일하다. 이것은, 코일의 공급 지점에서의 위상, 그리고 따라서 수학식 37에서의 위상 시프트를 변화시킴으로써, 복소 유효 높이의 위상(Φ)이 Hankel 크로스오버 지점(121)에서의 유도 표면 도파로 모드의 파 경사각(Ψ)과 매칭하도록 조절될 수 있다는 것을 암시한다: $\Phi = \Psi$.

[0173] 도 5a에서, 손실형 전도성 매체 표면을 따라 있는 길이 R_x 의 인접한 변, 및 충전 단자(T_1)의 중심과 R_x 에 있는 Hankel 크로스오버 지점(121) 사이에서 연장하는 광선(124)과, 충전 단자(T_1)와 Hankel 크로스오버 지점(121) 사이의 손실형 전도성 매체 표면(127) 사이에서 측정되는 복소 브루스터 각($\Psi_{i,B}$)을 갖는 직각 삼각형이 도시되어 있다. 충전 단자(T_1)가 물리적 높이(h_p)에 위치되고 적절한 위상 지연(Φ)을 갖는 전하로 여기된 경우, 결과적인 전기 필드는 Hankel 크로스오버 거리(R_x)에서 그리고 브루스터 각으로 손실형 전도성 매체 경계 계면에 입사한다. 이러한 조건들 하에서, 반사 없이 또는 실질적으로 무시할 만한 반사로 유도 표면 도파로 모드가 여기될 수 있다.

[0174] 유효 높이(h_{eff})의 위상 시프트(Φ)를 변화시키지 않으면서 충전 단자(T_1)의 물리적 높이가 감소되면, 결과적인 전기 필드는 유도 표면 도파로 프로브(200)로부터 감소된 거리에서 브루스터 각으로 손실형 전도성 매체(203)와 교차한다. 도 6은 전기 필드가 브루스터 각으로 입사하는 경우 거리에 대한 충전 단자(T_1)의 물리적 높이를 감소시키는 것의 효과를 그래픽으로 예시하고 있다. 이 높이가 h_3 로부터 h_2 를 거쳐 h_1 로 감소됨에 따라, 전기 필드가 손실형 전도성 매체(예컨대, 지구)와 브루스터 각으로 교차하는 지점이 충전 단자 위치에 보다 가깝게 이동한다. 그렇지만, 수학식 39가 나타내는 바와 같이, 충전 단자(T_1)의 높이(H_1)(도 3)는 Hankel 함수의 원위 성분(far-out component)을 여기시키기 위해 물리적 높이(h_p) 이상이어야만 한다. 충전 단자(T_1)가 유효 높이(h_{eff})에 또는 그보다 위에 위치된 경우, 손실형 전도성 매체(203)가, 도 5a에 예시된 바와 같이, Hankel 크로스오버 거리(R_x)(121)에서 또는 그를 넘어서 브루스터 입사각($\Psi_{i,B} = (\pi/2) - \Theta_{i,B}$)으로 조사(illuminate)될 수 있다. 충전 단자(T_1) 상의 속박 전하를 감소시키거나 최소화하기 위해, 그 높이가, 앞서 언급된 바와 같이, 충전 단자(T_1)의 구체 직경(또는 등가 구체 직경)의 4배 이상이어야만 한다.

[0175] 유도 표면 도파로 프로브(200)는 손실형 전도성 매체(203)의 표면을 복소 브루스터 각으로 조사하는 파에 대응하는 파 경사를 갖는 전기 필드를 확립함으로써, R_x 에 있는 Hankel 크로스오버 지점(121)에서(또는 그를 넘어서) 유도 표면과 모드에 실질적으로 모드-매칭하는 것에 의해 방사상 표면 전류들을 여기시키도록 구성될 수 있다.

[0176] 도 7을 참조하면, 충전 단자(T_1)를 포함하는 유도 표면 도파로 프로브(200b)의 일 예의 그래픽 표현이 도시되어 있다. AC 소스(212)는 충전 단자(T_1)에 대한 여기 소스로서 기능하고, 이는, 예컨대, 나선형 코일과 같은 코일(215)을 포함하는 공급 네트워크(209)(도 3)를 통해 유도 표면 도파로 프로브(200b)에 결합된다. 다른 구현들

에서, AC 소스(212)는 1차 코일을 통해 코일(215)에 유도적으로 결합될 수 있다. 일부 실시예들에서, AC 소스(212)와 코일(215) 간의 결합을 향상시키고 그리고/또는 최대화하기 위해 임피던스 매칭 네트워크가 포함될 수 있다.

[0177] 도 7에 도시된 바와 같이, 유도 표면 도파로 프로브(200b)는 손실형 전도성 매체(203)에 의해 제공되는 평면에 실질적으로 수직인 수직 축(z)을 따라 위치되는 상부 충전 단자(T_1)(예컨대, 높이(h_p)에 있는 구체)를 포함할 수 있다. 제2 매체(206)는 손실형 전도성 매체(203) 위쪽에 위치된다. 충전 단자(T_1)는 자기 정전용량(C_T)을 갖는다. 동작 동안, 임의의 주어진 순간에 단자(T_1)에 인가되는 전압에 의존하는 전하(Q_i)가 단자(T_1)에 부여된다.

[0178] 도 7의 예에서, 코일(215)은 제1 단부에서 접지 말뚝(ground stake)(218)에 결합되고 수직 공급 라인 전도체(221)를 통해 충전 단자(T_1)에 결합된다. 일부 구현들에서, 도 7에 도시되는 바와 같이, 충전 단자(T_1)에의 코일 연결은 코일(215)의 탭(tap)(224)을 사용하여 조절될 수 있다. 코일(215)은 코일(215)의 하부 부분에 있는 탭(227)을 통해 AC 소스(212)에 의해 동작 주파수로 에너지를 공급받을 수 있다. 다른 구현들에서, AC 소스(212)는 1차 코일을 통해 코일(215)에 유도적으로 결합될 수 있다.

[0179] 유도 표면 도파로 프로브(200)의 구성 및 조절은, 전송 주파수, 손실형 전도성 매체의 조건들(예컨대, 토양 전도율(σ) 및 상대 유전율(ϵ_r)), 및 충전 단자(T_1)의 크기와 같은, 다양한 동작 조건들에 기초한다. 굴절률은 수학식 10 및 수학식 11로부터 수학식 41로서 계산될 수 있고,

[0180] [수학식 41]

[0181]
$$n = \sqrt{\epsilon_r - jx}$$

[0182] 여기서 $x = \sigma / \omega \epsilon_0$ 이고 $\omega = 2\pi f$ 이다. 전도율(σ) 및 상대 유전율(ϵ_r)은 손실형 전도성 매체(203)의 테스트 측정들을 통해 결정될 수 있다. 표면 법선으로부터 측정된 복소 브루스터 각($\theta_{i,B}$)은 수학식 26으로부터 수학식 42로서 결정될 수 있거나,

[0183] [수학식 42]

[0184]
$$\theta_{i,B} = \arctan(\sqrt{\epsilon_r - jx})$$

[0185] 도 5a에 도시되는 바와 같이 표면으로부터 수학식 43으로서 측정될 수 있다.

[0186] [수학식 43]

[0187]
$$\psi_{i,B} = \frac{\pi}{2} - \theta_{i,B}$$

[0188] Hankel 크로스오버 거리에서의 파 경사(W_{R_x})가 또한 수학식 40을 사용하여 구해질 수 있다.

[0189] 도 4에 예시된 바와 같이 Hankel 크로스오버 거리가 또한 $-j\gamma\rho$ 에 대하여 수학식 20b의 크기와 수학식 21의 크기를 같다고 놓고 R_x 에 대해 푸는 것에 의해 구해질 수 있다. 전기적 유효 높이는 이어서 수학식 39로부터 Hankel 크로스오버 거리 및 복소 브루스터 각을 사용하여 수학식 44로서 결정될 수 있다.

[0190] [수학식 44]

[0191]
$$h_{eff} = h_p e^{j\Phi} = R_x \tan \psi_{i,B}$$

[0192] 수학식 44로부터 알 수 있는 바와 같이, 복소 유효 높이(h_{eff})는 충전 단자(T_1)의 물리적 높이(h_p)와 연관되어 있는 크기 및 Hankel 크로스오버 거리(R_x)에서의 파 경사각(Ψ)과 연관될 위상 지연(Φ)을 포함한다. 이 변수들 및 선택된 충전 단자(T_1) 구성을 사용해, 유도 표면 도파로 프로브(200)의 구성을 결정하는 것이 가능하다.

[0193] 충전 단자(T_1)가 물리적 높이(h_p)에 또는 그보다 위에 위치된 경우, 공급 네트워크(209)(도 3) 및/또는 공급 네

트위크를 충전 단자(T_1)에 연결시키는 수직 공급 라인은 충전 단자(T_1) 상의 전하(Q_1)의 위상(Φ)을 파 경사(W)의 각도(Ψ)에 매칭시키도록 조절될 수 있다. 충전 단자(T_1)의 크기는 단자들 상에 부여된 전하(Q_1)를 위한 충분히 큰 표면을 제공하도록 선택될 수 있다. 일반적으로, 충전 단자(T_1)를 실용적일 정도로 크게 만드는 것이 바람직하다. 충전 단자(T_1)의 크기는, 충전 단자 주변에 전기 방전 또는 스파크 발생(sparking)을 초래할 수 있는, 주변 공기의 이온화를 피할 정도로 충분히 커야 한다.

[0194] 나선형으로 권취된 코일(helically-wound coil)의 위상 지연(θ_c)은 [Corum, K.L. and J.F. Corum, "RF Coils, Helical Resonators and Voltage Magnification by Coherent Spatial Modes," *Microwave Review*, Vol. 7, No. 2, September 2001, pp. 36-45.] - 참조에 의해 그 전체가 본원에 원용됨 - 에 의해 논의된 바와 같이 Maxwell의 방정식들로부터 결정될 수 있다. $H/D > 1$ 인 나선형 코일의 경우, 광속(c)에 대한 코일의 종축을 따른 파의 전파 속도(v)의 비, 또는 "속도 인자"는 수학식 45에 의해 주어지고,

[0195] [수학식 45]

$$V_f = \frac{v}{c} = \frac{1}{\sqrt{1 + 20\left(\frac{D}{s}\right)^{2.5} \left(\frac{D}{\lambda_0}\right)^{0.5}}}$$

[0196]

[0197] 여기서, H 는 솔레노이드 헬릭스(solenoidal helix)의 축방향 길이이고, D 는 코일 직경이며, N 은 코일의 턴 수(number of turns)이고, $s = H/N$ 은 코일의 턴간 간격(turn-to-turn spacing)(또는 헬릭스 피치(helix pitch))이고, λ_0 는 자유 공간 파장이다. 이러한 관계에 기초하여, 나선형 코일의 전기적 길이 또는 위상 지연은 수학식 46에 의해 주어진다.

[0198] [수학식 46]

$$\theta_c = \beta_p H = \frac{2\pi}{\lambda_p} H = \frac{2\pi}{V_f \lambda_0} H$$

[0199]

[0200] 헬릭스가 나선형으로 권취되거나 짧고 뚱뚱한 경우 원리는 동일하지만, V_f 및 θ_c 는 실험적 측정에 의해 획득하기가 보다 용이하다. 나선형 전송 라인의 특성 (파) 임피던스에 대한 표현식이 또한 수학식 47로서 도출되었다.

[0201] [수학식 47]

$$Z_c = \frac{60}{V_f} \left[\ell n \left(\frac{V_f \lambda_0}{D} \right) - 1.027 \right]$$

[0202]

[0203] 구조물의 공간적 위상 지연(θ_y)은 수직 공급 라인 전도체(221)(도 7)의 진행파 위상 지연을 사용하여 결정될 수 있다. 완전 접지 평면(perfect ground plane)보다 위에 있는 원통형 수직 전도체의 정전용량은 수학식 48로서 표현될 수 있고,

[0204] [수학식 48]

$$C_A = \frac{2\pi\epsilon_0 h_w}{\ell n\left(\frac{h}{a}\right) - 1} \text{ Farads}$$

[0205]

[0206] 여기서 h_w 는 전도체의 수직 길이(또는 높이)이고, a 는 반경이다(mks 단위로 되어 있음). 나선형 코일에서와 같이, 수직 공급 라인 전도체의 진행파 위상 지연은 수학식 49에 의해 주어질 수 있고,

[0207] [수학식 49]

$$\theta_y = \beta_w h_w = \frac{2\pi}{\lambda_w} h_w = \frac{2\pi}{V_w \lambda_0} h_w$$

[0208]

[0209] 여기서 β_w 는 수직 공급 라인 전도체에 대한 전파 위상 상수이고, h_w 는 수직 공급 라인 전도체의 수직 길이(또는 높이)이며, V_w 는 전선(wire) 상에서의 속도 인자이고, λ_0 는 공급 주파수에서의 파장이며, λ_w 는 속도 인자(V_w)로부터 초래되는 전파 파장이다. 균일 원통형 전도체(uniform cylindrical conductor)에 대하여, 속도 인자는 $V_w \approx 0.94$ 인 상수이거나, 약 0.93 내지 약 0.98의 범위에 있다. 마스트(mast)가 균일 전송 라인(uniform transmission line)인 것으로 간주되는 경우, 그의 평균 특성 임피던스는 수학식 50에 의해 근사화될 수 있고,

[0210] [수학식 50]

$$Z_w = \frac{60}{V_w} \left[\ln \left(\frac{h_w}{a} \right) - 1 \right]$$

[0211]

[0212] 여기서 균일 원통형 전도체에 대하여 $V_w \approx 0.94$ 이고, a 는 전도체의 반경이다. 단선 공급 라인(single-wire feed line)의 특성 임피던스에 대해 아마추어 무선 문헌에서 이용되어 온 대안의 표현식은 수학식 51에 의해 주어진다.

[0213] [수학식 51]

$$Z_w = 138 \log \left(\frac{1.123 V_w \lambda_0}{2\pi a} \right)$$

[0214]

[0215] 수학식 51은 단선 피더(single-wire feeder)에 대한 Z_w 가 주파수에 따라 변한다는 것을 암시한다. 위상 지연은 정전용량 및 특성 임피던스에 기초하여 결정될 수 있다.

[0216]

도 3에 도시되는 바와 같이 충전 단자(T_1)가 손실형 전도성 매체(203) 위쪽에 위치한 경우, 복소 유효 높이(h_{eff})의 위상 시프트(Φ)가 Hankel 크로스오버 거리에서의 파 경사각(Ψ)과 동일한 경우 또는 $\Phi = \Psi$ 인 경우 충전 단자(T_1)를 여기서키도록 공급 네트워크(209)가 조절될 수 있다. 이 조건이 충족될 때, 충전 단자(T_1) 상의 진동하는 전하(Q_1)에 의해 생성되는 전기 필드는 손실형 전도성 매체(203)의 표면을 따라 진행하는 유도 표면 도파로 모드에 결합된다. 예를 들어, 브루스터 각($\theta_{i,B}$), 수직 공급 라인 전도체(221)(도 7)와 연관된 위상 지연(θ_y), 및 코일(215)(도 7)의 구성이 알려져 있는 경우, 탭(224)(도 7)의 위치는 위상 $\Phi = \Psi$ 인 경우 충전 단자(T_1) 상의 진동 전하(oscillating charge)(Q_1)를 부여하도록 결정 및 조절될 수 있다. 탭(224)의 위치는 진행 표면파들을 유도 표면 도파로 모드에 결합시키는 것을 최대화하도록 조절될 수 있다. 용량성 효과(capacitive effect)들을 감소시키기 위해 탭(224)의 위치를 넘어선 잉여 코일 길이가 제거될 수 있다. 수직 전선 높이 및/또는 나선형 코일의 기하학적 파라미터들이 또한 변화될 수 있다.

[0217]

충전 단자(T_1) 상의 전하(Q_1)와 연관된 복소 이미지 평면(complex image plane)과 관련하여 정재파 공진(standing wave resonance)을 하도록 유도 표면 도파로 프로브(200)를 튜닝함으로써 손실형 전도성 매체(203)의 표면 상의 유도 표면 도파로 모드에의 결합이 향상 및/또는 최적화될 수 있다. 이렇게 함으로써, 충전 단자(T_1) 상의 증가된 및/또는 최대 전압(그리고 따라서 전하(Q_1))을 위해 유도 표면 도파로 프로브(200)의 성능이 조절될 수 있다. 도 3을 다시 참조하면, 영역 1에서의 손실형 전도성 매체(203)의 효과가 이미지 이론 분석을 사용하여 검사될 수 있다.

[0218]

물리적으로는, 완전 전도성 평면(perfectly conducting plane) 위쪽에 배치되는 상승된 전하(Q_1)가 완전 전도성 평면 상의 자유 전하를 끌어당기고, 자유 전하가 이어서 상승된 전하(Q_1) 아래의 영역에 "축적된다(pile up)". 완전 전도성 평면 상의 "속박" 전기("bound" electricity)의 결과적인 분포는 종형 곡선(bell-shaped curve)과 유사하다. 상승된 전하(Q_1)의 전위와 그 아래에 있는 유도 "축적" 전하(induced "piled up" charge)의 전위의 중첩(superposition)은 완전 전도성 평면에 대한 제로 등전위면(zero equipotential surface)을 강제로 생기게

한다. 완전 전도성 평면 위쪽에 있는 영역에서의 필드들을 기술하는 경계값 문제 해는, 상승된 전하로부터의 필드가 완전 전도성 평면 아래에 있는 대응하는 "이미지" 전하로부터의 필드와 중첩되는, 이미지 전하(image charge)들의 고전적 개념을 사용하여 획득될 수 있다.

[0219] 유도 표면 도파로 프로브(200) 아래에 유효 이미지 전하(effective image charge)(Q_1')가 존재한다고 가정하는 것에 의해 손실형 전도성 매체(203)와 관련하여 이 분석이 또한 사용될 수 있다. 도 3에 예시된 바와 같이, 유효 이미지 전하(Q_1')가 전도성 이미지 접지 평면(conducting image ground plane)(130)을 기준으로 충전 단자(T_1) 상의 전하(Q_1)와 동시에 나타난다(coincide). 그렇지만, 이미지 전하(Q_1')가, 완전 전도체의 경우에 그러한 것처럼, 어떤 실수 깊이(real depth)에서 충전 단자(T_1) 상의 1차 소스 전하(Q_1)와 180° 위상이 어긋나게 위치되는 것만은 아니다. 오히려, 손실형 전도성 매체(203)(예컨대, 지상 매체)는 위상 시프트된 이미지를 제공한다. 즉, 이미지 전하(Q_1')가 손실형 전도성 매체(203)의 표면(또는 물리적 경계) 아래로 복소 깊이(complex depth)에 있다. 복소 이미지 깊이에 대한 논의에 대해서는, [Wait, J. R., "Complex Image Theory-Revisited," IEEE Antennas and Propagation Magazine, Vol. 33, No. 4, August 1991, pp. 27-29] - 참조에 의해 그 전체가 본원에 원용됨 - 를 참조한다.

[0220] 이미지 전하(Q_1')가 전하(Q_1)의 물리적 높이(H_1)와 동일한 깊이에 있지 않고, 전도성 이미지 접지 평면(130)(완전 전도체를 나타냄)이 $z = -d/2$ 의 복소 깊이에 위치되고, 이미지 전하(Q_1')는, $-D_1 = -(d/2 + d/2 + H_1) \neq H_1$ 에 의해 주어지는, 복소 깊이(즉, "깊이"가 크기 및 위상 둘 다를 가짐)에 나타난다. 지구 위쪽에 있는 수직 편파 소스(vertically polarized source)들에 대하여,

[0221] [수학식 52]

$$d = \frac{2\sqrt{\gamma_e^2 + k_0^2}}{\gamma_e} \approx \frac{2}{\gamma_e} = d_r + jd_i = |d|\angle\zeta$$

[0222]

이고, 여기서

[0223]

[0224] [수학식 53]

$$\gamma_e^2 = j\omega\mu_1\sigma_1 - \omega^2\mu_1\epsilon_1$$

[0225]

이고

[0226]

수학식 12에 나타낸 바와 같이

[0227]

[0228] [수학식 54]

$$k_o = \omega\sqrt{\mu_o\epsilon_o}$$

[0229]

이다. 이미지 전하의 복소 간격은, 차례로, 외부 필드들이 계면이 유전체 또는 완전 전도체 중 어느 하나일 때는 직면하지 않는 추가 위상 시프트(extra phase shift)들을 경험할 것임을 암시한다. 손실형 전도성 매체에서, 파면 법선이 $z = -d/2$ 에서는 전도성 이미지 접지 평면(130)의 접선에 평행하고 영역 1과 영역 2 사이의 경계 계면에서는 그렇지 않다.

[0231] 손실형 전도성 매체(203)가 물리적 경계(136)를 갖는 유한 전도성 지구(finitely conducting Earth)(133)인 도 8a에 예시된 경우를 고려한다. 유한 전도성 지구(133)는, 도 8b에 도시된 바와 같이, 물리적 경계(136) 아래로 복소 깊이(z_1)에 위치되는 완전 전도성 이미지 접지 평면(139)으로 대체될 수 있다. 이러한 등가 표현은 물리적 경계(136)에 있는 계면 안쪽으로 내려다볼 때 동일한 임피던스를 나타낸다. 도 8b의 등가 표현이, 도 8c에 도시되는 바와 같이, 등가 전송 라인으로서 모델링될 수 있다. 등가 구조물의 단면은 (z-방향의(z-directed)) 종단 부하를 갖는 전송 라인(end-loaded transmission line)으로서 표현되고, 완전 전도성 이미지 평면의 임피던스는 단락 회로($z_s = 0$)이다. 깊이(z_1)는 지구를 내려다볼 때의 TEM 파 임피던스를 도 8c의 전송 라인을 들여다볼 때 보이는 이미지 접지 평면 임피던스(z_{in})와 같다고 놓음으로써 결정될 수 있다.

[0232] 도 8a의 경우에, 상부 영역(공기)(142)에서의 전파 상수 및 파 고유 임피던스(wave intrinsic impedance)는 수학식 55 및 수학식 56이다.

[0233] [수학식 55]

$$\gamma_o = j\omega\sqrt{\mu_o\epsilon_o} = 0 + j\beta_o$$

[0235] [수학식 56]

$$Z_o = \frac{j\omega\mu_o}{\gamma_o} = \sqrt{\frac{\mu_o}{\epsilon_o}}$$

[0237] 손실형 지구(133)에서, 전파 상수 및 파 고유 임피던스는 수학식 57 및 수학식 58이다.

[0238] [수학식 57]

$$\gamma_e = \sqrt{j\omega\mu_1(\sigma_1 + j\omega\epsilon_1)}$$

[0240] [수학식 58]

$$Z_e = \frac{j\omega\mu_1}{\gamma_e}$$

[0242] 수직 입사에 대해, 도 8b의 등가 표현은 TEM 전송 라인 - 그의 특성 임피던스는 γ_o 의 전파 상수를 갖는 공기의 특성 임피던스(z_o)이고 그의 길이는 z_1 임 - 과 등가이다. 이에 따라, 도 8c의 단락된 전송 라인에 대한 계면에 서 보이는 이미지 접지 평면 임피던스(Z_{in})는 수학식 59에 의해 주어진다.

[0243] [수학식 59]

$$Z_{in} = Z_o \tanh(\gamma_o z_1)$$

[0245] 도 8c의 등가 모델과 연관된 이미지 접지 평면 임피던스(Z_{in})를 도 8a의 수직 입사 파 임피던스와 같다고 놓고, z_1 에 대해 풀면 단락 회로(완전 전도성 이미지 접지 평면(139))까지의 거리가 수학식 60으로서 주어진다.

[0246] [수학식 60]

$$z_1 = \frac{1}{\gamma_o} \tanh^{-1} \left(\frac{Z_e}{Z_o} \right) = \frac{1}{\gamma_o} \tanh^{-1} \left(\frac{\gamma_o}{\gamma_e} \right) \approx \frac{1}{\gamma_e}$$

[0248] 이 근사화를 위해 역 쌍곡선 탄젠트(inverse hyperbolic tangent)에 대한 급수 전개와 첫 번째 항만이 고려된다. 공기 영역(142)에서, 전파 상수가 $\gamma_o = j\beta_o$ 이고, 따라서, $Z_{in} = jZ_o \tan \beta_o z_1$ (실수 z_1 에 대한 순 허수량(purely imaginary quantity)임)이지만, $\sigma \neq 0$ 인 경우 z_e 가 복소 값이라는 점에 주목한다. 따라서, z_1 이 복소 거리일 때에만 $Z_{in} = Z_e$ 이다.

[0249] 도 8b의 등가 표현이 완전 전도성 이미지 접지 평면(139)을 포함하기 때문에, 지구의 표면(물리적 경계(136))에 놓인 전하 또는 전류에 대한 이미지 깊이는 이미지 접지 평면(139)의 반대 쪽 측면(other side)에서의 거리(z_1)와 동일하거나 지구의 표면($z = 0$ 에 위치됨) 아래로 $d = 2 \times z_1$ 이다. 따라서, 완전 전도성 이미지 접지 평면(139)까지의 거리는 수학식 61에 의해 근사화될 수 있다.

[0250] [수학식 61]

$$d = 2z_1 \approx \frac{2}{\gamma_e}$$

[0252] 그에 부가하여, "이미지 전하"는 실제 전하(real charge)와 "동일하고 그와 반대쪽에 있으며", 따라서 깊이 z_1

= - d/2에 있는 완전 전도성 이미지 접지 평면(139)의 전위는 0일 것이다.

[0253] 도 3에 예시된 바와 같이 전하(Q_1)가 지구의 표면으로부터 거리(H_1)만큼 상승되어 있는 경우, 이미지 전하(Q_1')는 그 표면 아래로 $D_1 = d + H_1$ 의 복소 거리에, 또는 이미지 접지 평면(130) 아래로 $d/2 + H_1$ 의 복소 거리에 존재한다. 도 7의 유도 표면 도파로 프로브(200b)는 도 8b의 완전 전도성 이미지 접지 평면(139)에 기초할 수 있는 등가 단선 전송 라인 이미지 평면 모델로서 모델링될 수 있다. 도 9a는 등가 단선 전송 라인 이미지 평면 모델의 일 예를 도시하고 있으며, 도 9b는, 도 8c의 단락된 전송 라인을 포함하는, 고전적 등가 전송 라인 모델의 일 예를 도시하고 있다.

[0254] 도 9a 및 도 9b의 등가 이미지 평면 모델들에서, $\Phi = \Theta_y + \Theta_c$ 는 지구(133)(또는 손실형 전도성 매체(203))를 기준으로 한 유도 표면 도파로 프로브(200)의 진행과 위상 지연이고, $\Theta_c = \beta_p H$ 는, 도 단위로 표현되는, 물리적 길이(H)의 코일(215)(도 7)의 전기적 길이이며, $\Theta_y = \beta_w h_w$ 는, 도 단위로 표현되는, 물리적 길이(h_w)의 수직 공급 라인 전도체(221)(도 7)의 전기적 길이이고, $\Theta_d = \beta_o d/2$ 는 이미지 접지 평면(139)과 지구(133)(또는 손실형 전도성 매체(203))의 물리적 경계(136) 사이의 위상 시프트이다. 도 9a 및 도 9b의 예에서, Z_w 는 옴 단위의 상승된 수직 공급 라인 전도체(221)의 특성 임피던스이고, Z_c 는 옴 단위의 코일(215)의 특성 임피던스이며, Z_o 는 자유 공간의 특성 임피던스이다.

[0255] 유도 표면 도파로 프로브(200)의 베이스에서, 구조물 안쪽으로 "올려다볼 때" 보이는 임피던스는 $Z_{\uparrow} = Z_{base}$ 이다. 부하 임피던스가 수학식 62:

[0256] [수학식 62]

$$Z_L = \frac{1}{j\omega C_T}$$

[0257]

[0258] - C_T 는 충전 단자(T_1)의 자기 정전용량임 - 인 경우, 수직 공급 라인 전도체(221)(도 7) 안쪽으로 "올려다볼 때" 보이는 임피던스는 수학식 63에 의해 주어지고:

[0259] [수학식 63]

$$Z_2 = Z_W \frac{Z_L + Z_W \tanh(j\beta_w h_w)}{Z_W + Z_L \tanh(j\beta_w h_w)} = Z_W \frac{Z_L + Z_W \tanh(j\theta_y)}{Z_W + Z_L \tanh(j\theta_y)}$$

[0260]

[0261] 코일(215)(도 7) 안쪽으로 "올려다볼 때" 보이는 임피던스는 수학식 64에 의해 주어진다:

[0262] [수학식 64]

$$Z_{base} = Z_c \frac{Z_2 + Z_c \tanh(j\beta_p H)}{Z_c + Z_2 \tanh(j\beta_p H)} = Z_c \frac{Z_2 + Z_c \tanh(j\theta_c)}{Z_c + Z_2 \tanh(j\theta_c)}$$

[0263]

[0264] 유도 표면 도파로 프로브(200)의 베이스에서, 손실형 전도성 매체(203) 안쪽으로 "내려다볼 때" 보이는 임피던스는, 수학식 65에 의해 주어지는, $Z_{\downarrow} = Z_{in}$ 이고:

[0265] [수학식 65]

$$Z_{in} = Z_o \frac{Z_s + Z_o \tanh[j\beta_o(d/2)]}{Z_o + Z_s \tanh[j\beta_o(d/2)]} = Z_o \tanh(j\theta_d)$$

[0266]

[0267] 여기서 $Z_s = 0$ 이다.

[0268] 손실들을 무시하면, 등가 이미지 평면 모델은 물리적 경계(136)에서 $Z_{\downarrow} + Z_{\uparrow} = 0$ 일 때 공진으로 튜닝될 수 있다. 또는, 저 손실의 경우에, 물리적 경계(136)에서 $X_{\downarrow} + X_{\uparrow} = 0$ 이고, 여기서 X는 대응하는 무효 성분(reactive component)이다. 따라서, 유도 표면 도파로 프로브(200) 안쪽으로 "올려다볼 때의" 물리적 경계

(136)에서의 임피던스는 손실형 전도성 매체(203) 안쪽으로 "내려다볼 때의" 물리적 경계(136)에서의 임피던스의 켈레(conjugate)이다. $\Phi = \Psi -$ 이는 프로브의 전기 필드를 손실형 전도성 매체(203)(예컨대, 지구)의 표면을 따른 유도 표면 도파로 모드에 결합시키는 것을 향상 및/또는 최대화함 - 이도록, 진행파 위상 지연(Φ)을 매체의 파 경사각(Ψ)과 동일하게 유지하면서 충전 단자(T_1)의 부하 임피던스(Z_L)를 조절하는 것에 의해, 도 9a 및 도 9b의 등가 이미지 평면 모델이 이미지 접지 평면(139)과 관련하여 공진으로 튜닝될 수 있다. 이러한 방식으로, 등가 복소 이미지 평면 모델의 임피던스는 순수 저항성(purely resistive)이고, 이는, 단자(T_1) 상의 전압 및 상승된 전하를 최대화하고 수학적 1 내지 수학적 3 및 수학적 16에 의해 전파하는 표면파를 최대화하는, 프로브 구조물 상의 중첩 정재파를 유지한다.

[0269] Hankel 해(Hankel solution)들로부터, 유도 표면 도파로 프로브(200)에 의해 여기된 유도 표면파가 외향으로 전파하는 진행파라는 것을 알 수 있다. 유도 표면 도파로 프로브(200)(도 3 및 도 7)의 접지 말뚝(218)과 충전 단자(T_1) 사이의 공급 네트워크(209)를 따른 소스 분포는 실제로는 구조물 상의 정재파와 진행파의 중첩으로 이루어져 있다. 충전 단자(T_1)가 물리적 높이(h_p)에 또는 그보다 위쪽에 위치한 경우, 공급 네트워크(209)를 통해 이동하는 진행파의 위상 지연은 손실형 전도성 매체(203)와 연관된 파 경사각에 매칭된다. 이러한 모드-매칭은 진행파가 손실형 전도성 매체(203)를 따라 발전될 수 있게 한다. 진행파에 대한 위상 지연이 확립되면, 프로브 구조물을 - $d/2$ 의 복소 깊이에 있는 이미지 접지 평면(도 3의 130 또는 도 8의 139)과 관련하여 정재파 공진 상태에 들어가게 하기 위해 충전 단자(T_1)의 부하 임피던스(Z_L)가 조절된다. 그 경우에, 이미지 접지 평면으로부터 보이는 임피던스는 제로 리액턴스(zero reactance)를 갖고, 충전 단자(T_1) 상의 전하가 최대화된다.

[0270] 진행파 현상과 정재파 현상 사이의 차이점은 (1) 길이(d)의 전송 라인의 섹션(때때로 "지연 라인"이라고 불림) 상의 진행파들의 위상 지연($\Theta = \beta d$)이 전파 시간 지연들에 기인하는 반면; (2) 정재파들(순방향으로 전파하는 파(forward propagating wave)와 역방향으로 전파하는 파(backward propagating wave)로 이루어짐)의 위치 의존적 위상이 상이한 특성 임피던스들의 라인 섹션들 사이의 계면들에서의 임피던스 전이(impedance transition)들 및 라인 길이 전파 시간 지연 둘 다에 의존한다는 것이다. 사인파 정상 상태(sinusoidal steady-state)에서 동작하는 전송 라인의 섹션의 물리적 길이에 기인하여 발생하는 위상 지연에 부가하여, Z_{oa}/Z_{ob} 의 비에 기인하는 임피던스 불연속들에서의 추가 반사 계수 위상이 있고, 여기서 Z_{oa} 및 Z_{ob} 는, 예컨대, 특성 임피던스 $Z_{oa} = Z_c$ 의 나선형 코일 섹션(도 9b) 및 특성 임피던스 $Z_{ob} = Z_w$ 의 수직 공급 라인 전도체의 직선 섹션(도 9b)과 같은 전송 라인의 2개의 섹션의 특성 임피던스들이다.

[0271] 이러한 현상의 결과로서, 크게 상이한 특성 임피던스의 2개의 비교적 짧은 전송 라인 섹션이 매우 큰 위상 시프트를 제공하는 데 사용될 수 있다. 예를 들어, 0.25λ 공진과 등가인 90° 의 위상 시프트를 제공하기 위해, 모두 합하여, 말하자면, 0.05λ 의 물리적 길이를 갖는 전송 라인의 2개의 섹션 - 하나는 저 임피던스이고 하나는 고 임피던스임 - 으로 이루어진 프로브 구조물이 제조될 수 있다. 이것은 특성 임피던스들의 큰 폭의 급등으로 인한 것이다. 이러한 방식으로, 물리적으로 짧은 프로브 구조물이 전기적으로는 조합된 2개의 물리적 길이들보다 더 길 수 있다. 이것이 도 9a 및 도 9b에 예시되어 있으며, 여기서 임피던스 비들의 불연속들은 위상의 큰 폭의 급등들을 제공한다. 섹션들이 서로 조인(join)되는 곳에서 임피던스 불연속은 실질적인 위상 시프트를 제공한다.

[0272] 도 10을 참조하면, 유도 표면 도파로 프로브(200)(도 3 및 도 7)를 손실형 전도성 매체의 표면 상의 유도 표면 도파로 모드에 실질적으로 모드-매칭되도록 - 이는 손실형 전도성 매체(203)(도 3)의 표면을 따라 유도 표면 진행파를 발전시킴 - 조절하는 것의 일 예를 예시하는 플로차트(150)가 도시되어 있다. 153에서 시작하여, 유도 표면 도파로 프로브(200)의 충전 단자(T_1)는 손실형 전도성 매체(203)로부터 정의된 높이에 위치된다. 손실형 전도성 매체(203)의 특성들 및 유도 표면 도파로 프로브(200)의 동작 주파수를 이용하여, Hankel 크로스오버 거리가 또한 도 4에 도시되는 바와 같이 $-j\gamma\rho$ 에 대하여 수학적 20b와 수학적 21의 크기들을 같다고 놓고 R_x 에 대해 푸는 것에 의해 구해질 수 있다. 복소 굴절률(n)이 수학적 41을 사용하여 결정될 수 있고, 복소 브루스터 각($\theta_{i,B}$)이 이어서 수학적 42로부터 결정될 수 있다. 충전 단자(T_1)의 물리적 높이(h_p)가 이어서 수학적 44로부터 결정될 수 있다. 충전 단자(T_1)는 Hankel 함수의 원위 성분을 여기시키기 위해 물리적 높이(h_p)에 또는 그보다 더 높게 있어야만 한다. 이러한 높이 관계는 초기에 표면파들을 발전시킬 때 고려된다. 충전 단자(T_1) 상의 속박 전하를 감소시키거나 최소화하기 위해, 그 높이가 충전 단자(T_1)의 구체 직경(또는 등가 구체 직경)의

4배 이상이어야만 한다.

[0273] 156에서, 충전 단자(T_1) 상의 상승된 전하(Q_1)의 전기적 위상 지연(Φ)이 복소 파 경사각(Ψ)에 매칭된다. Φ 를 파 경사(W)의 각도(Ψ)와 동일하도록 하기 위해 나선형 코일의 위상 지연(Θ_c) 및/또는 수직 공급 라인 전도체의 위상 지연(Θ_y)이 조절될 수 있다. 수학식 31에 기초하여, 파 경사각(Ψ)이 수학식 66으로부터 결정될 수 있다:

[0274] [수학식 66]

$$W = \frac{E_\rho}{E_z} = \frac{1}{\tan \theta_{i,B}} = \frac{1}{n} = |W|e^{j\Psi}$$

[0275]

[0276] 전기적 위상(Φ)이 이어서 파 경사각에 매칭될 수 있다. 이 각도(또는 위상) 관계가 다음에 표면파들을 발진시킬 때 고려된다. 예를 들어, 전기적 위상 지연($\Phi = \Theta_c + \Theta_y$)은 코일(215)(도 7)의 기하학적 파라미터들 및/또는 수직 공급 라인 전도체(221)(도 7)의 길이(또는 높이)를 변화시키는 것에 의해 조절될 수 있다. $\Phi = \Psi$ 를 매칭시키는 것에 의해, 표면 도파로 모드를 여기시키고 손실형 전도성 매체(203)를 따라 진행파를 발진시키기 위해 경계 계면에서 복소 브루스터 각으로 Hankel 크로스오버 거리(R_x)에서 또는 그를 넘어서 전기 필드들이 확립될 수 있다.

[0277] 다음에 159에서, 충전 단자(T_1)의 부하 임피던스가 유도 표면 도파로 프로브(200)의 등가 이미지 평면 모델을 공진시키도록 튜닝된다. 도 9a 및 도 9b의 전도성 이미지 접지 평면(139)(또는 도 3의 130)의 깊이($d/2$)는 수학식 52, 수학식 53 및 수학식 54 그리고, 측정될 수 있는, 손실형 전도성 매체(203)(예컨대, 지구)의 값들을 사용하여 결정될 수 있다. 그 깊이를 사용하여, 손실형 전도성 매체(203)의 물리적 경계(136)와 이미지 접지 평면(139) 사이의 위상 시프트(Θ_d)는 $\Theta_d = \beta_0 d/2$ 를 사용하여 결정될 수 있다. 손실형 전도성 매체(203) 안쪽으로 "내려다볼 때" 보이는 임피던스(Z_{in})가 이어서 수학식 65를 사용하여 결정될 수 있다. 발진된 표면파들을 최대화하기 위해 이러한 공진 관계가 고려될 수 있다.

[0278] 코일(215)의 조절된 파라미터들 및 수직 공급 라인 전도체(221)의 길이에 기초하여, 코일(215) 및 수직 공급 라인 전도체(221)의 속도 인자, 위상 지연, 및 임피던스가 수학식 45 내지 수학식 51을 사용하여 결정될 수 있다. 그에 부가하여, 충전 단자(T_1)의 자기 정전용량(C_T)이, 예컨대, 수학식 24를 사용하여 결정될 수 있다. 코일(215)의 전파 인자(β_p)는 수학식 35를 사용하여 결정될 수 있고, 수직 공급 라인 전도체(221)에 대한 전파 위상 상수(β_w)는 수학식 49를 사용하여 결정될 수 있다. 코일(215) 및 수직 공급 라인 전도체(221)의 결정된 값들 및 자기 정전용량을 사용하여, 코일(215) 안쪽으로 "올려다볼 때" 보이는 유도 표면 도파로 프로브(200)의 임피던스(Z_{base})는 수학식 62, 수학식 63 및 수학식 64를 사용하여 결정될 수 있다.

[0279] Z_{base} 의 리액턴스 성분(X_{base})이 Z_{in} 의 리액턴스 성분(X_{in})을 소거하도록 또는 $X_{base} + X_{in} = 0$ 이도록 부하 임피던스(Z_L)를 조절하는 것에 의해, 유도 표면 도파로 프로브(200)의 등가 이미지 평면 모델이 공진으로 튜닝될 수 있다. 따라서, 유도 표면 도파로 프로브(200) 안쪽으로 "올려다볼 때의" 물리적 경계(136)에서의 임피던스는 손실형 전도성 매체(203) 안쪽으로 "내려다볼 때의" 물리적 경계(136)에서의 임피던스의 켤레이다. 충전 단자(T_1)의 전기적 위상 지연($\Phi = \Theta_c + \Theta_y$)을 변화시키지 않으면서 충전 단자(T_1)의 정전용량(C_T)을 변화시킴으로써 부하 임피던스(Z_L)가 조절될 수 있다. 전도성 이미지 접지 평면(139)(또는 130)과 관련하여 등가 이미지 평면 모델을 공진시키도록 부하 임피던스(Z_L)를 튜닝하기 위해 반복적 접근법이 취해질 수 있다. 이러한 방식으로, 전기 필드를 손실형 전도성 매체(203)(예컨대, 지구)의 표면을 따른 유도 표면 도파로 모드에 결합시키는 것이 항상 및/또는 최대화될 수 있다.

[0280] 이것은 상황을 수치 예로 예시하는 것에 의해 보다 잘 이해될 수 있다. 상단에 충전 단자(T_1)와 함께 물리적 높이(h_p)의 상단 부하를 갖는 수직 스텐브(top-loaded vertical stub)를 포함하는 유도 표면 도파로 프로브(200)를 고려하고, 여기서 충전 단자(T_1)는 1.85 MHz의 동작 주파수(f_0)에서 나선형 코일 및 수직 공급 라인 전도체를 통해 여기된다. 높이(H_1)가 16 피트이고 손실형 전도성 매체(203)(예컨대, 지구)가 $\epsilon_r = 15$ 의 상대 유

전율 및 $\sigma_1 = 0.010$ mhos/m의 전도율을 갖는 경우, $f_0 = 1.850$ MHz에 대해 몇몇 표면파 전파 파라미터들이 계산될 수 있다. 이 조건들 하에서, 물리적 높이가 $h_p = 5.5$ 피트 - 이는 충전 단자(T_1)의 실제 높이보다 매우 아래에 있음 - 인 경우, Hankel 크로스오버 거리가 $R_x = 54.5$ 피트인 것으로 구해질 수 있다. $H_1 = 5.5$ 피트의 충전 단자 높이가 사용될 수 있지만, 보다 높은 프로브 구조물은 속박 정전용량(bound capacitance)을 감소시켜, 충전 단자(T_1) 상의 보다 많은 비율의 자유 전하가 진행파의 보다 큰 필드 강도 및 여기를 제공하는 것을 가능하게 한다.

[0281] 파장은 수학식 67로서 결정될 수 있고:

[0282] [수학식 67]

$$\lambda_o = \frac{c}{f_o} = 162.162 \text{ meters}$$

[0283]

[0284] 여기서 c 는 광속이다. 수학식 41로부터 복소 굴절률은 수학식 68이고:

[0285] [수학식 68]

$$n = \sqrt{\epsilon_r - jx} = 7.529 - j 6.546$$

[0286]

[0287] 여기서 $x = \sigma_1 / \omega \epsilon_o$ 이고 $\omega = 2\pi f_o$ 이며, 수학식 42로부터 복소 브루스터 각은 수학식 69이다:

[0288] [수학식 69]

$$\theta_{i,B} = \arctan(\sqrt{\epsilon_r - jx}) = 85.6 - j 3.744^\circ$$

[0289]

[0290] 수학식 66을 사용하여, 파 경사 값들이 수학식 70이 되도록 결정될 수 있다:

[0291] [수학식 70]

$$W = \frac{1}{\tan \theta_{i,B}} = \frac{1}{n} = |W|e^{j\Psi} = 0.101e^{j40.614^\circ}$$

[0292]

[0293] 따라서, $\Phi = \Psi = 40.614^\circ$ 을 매칭시키도록 나선형 코일이 조절될 수 있다.

[0294]

수직 공급 라인 전도체(0.27 인치의 직경을 갖는 균일 원통형 전도체로서 근사화됨)의 속도 인자는 $V_w \approx 0.93$ 로서 주어질 수 있다. $h_p \ll \lambda_o$ 이기 때문에, 수직 공급 라인 전도체에 대한 전파 위상 상수는 수학식 71로 근사화될 수 있다:

[0295] [수학식 71]

$$\beta_w = \frac{2\pi}{\lambda_w} = \frac{2\pi}{V_w \lambda_o} = 0.042 \text{ m}^{-1}$$

[0296]

[0297] 수학식 49로부터 수직 공급 라인 전도체의 위상 지연은 수학식 72이다:

[0298] [수학식 72]

$$\theta_y = \beta_w h_w \approx \beta_w h_p = 11.640^\circ$$

[0299]

[0300] $\theta_c = 28.974^\circ = 40.614^\circ - 11.640^\circ$ 이도록 나선형 코일의 위상 지연을 조절하는 것에 의해, 유도 표면 도파로 모드를 매칭시키기 위해 $\Phi = \Psi$ 일 것이다. Φ 와 Ψ 사이의 관계를 예시하기 위해, 도 11은 일정 범위의 주파수들에 걸쳐 둘 다의 플롯을 도시하고 있다. Φ 및 Ψ 둘 다가 주파수 의존적이기 때문에, 그 각자의 곡선들이 대략 1.85 MHz에서 서로 크로스오버하는 것을 볼 수 있다.

[0301]

0.0881 인치의 전도체 직경, 30 인치의 코일 직경(D) 및 4 인치의 턴간 간격(s)을 갖는 나선형 코일에 대하여, 코일에 대한 속도 인자는 수학식 45를 사용하여 수학식 73인 것으로 결정될 수 있고:

[0302] [수학식 73]

$$V_f = \frac{1}{\sqrt{1+20\left(\frac{D}{s}\right)^{2.5}\left(\frac{D}{\lambda_0}\right)^{0.5}}} = 0.069$$

[0303]

[0304] 수학식 35로부터 전파 인자는 수학식 74이다:

[0305] [수학식 74]

$$\beta_p = \frac{2\pi}{v_f \lambda_0} = 0.564 \text{ m}^{-1}$$

[0306]

[0307] $\theta_c = 28.974^\circ$ 인 경우, 솔레노이드 헬릭스의 축방향 길이(H)는 수학식 75이도록 수학식 46을 사용하여 결정될 수 있다:

[0308] [수학식 75]

$$H = \frac{\theta_c}{\beta_p} = 35.2732 \text{ inches}$$

[0309]

[0310] 이 높이는 수직 공급 라인 전도체가 연결되는 나선형 코일 상의 위치를 결정하고, 그 결과 8.818개의 턴($N = H/s$)을 갖는 코일이 얻어진다.

[0311] 코일 및 수직 공급 라인 전도체의 진행과 위상 지연이 파 경사각과 매칭하도록 조절된 경우($\Phi = \theta_c + \theta_y = \Psi$ 인 경우), 유도 표면과 프로브(200)의 등가 이미지 평면 모델의 정재파 공진을 위해 충전 단자(T_1)의 부하 임피던스(Z_L)가 조절될 수 있다. 지구의 측정된 유전율, 전도율 및 투자율로부터, 수학식 57을 사용하여 방사상 전파 상수가 결정될 수 있다.

[0312] [수학식 76]

$$\gamma_e = \sqrt{j\omega u_1(\sigma_1 + j\omega \epsilon_1)} = 0.25 + j 0.292 \text{ m}^{-1}$$

[0313]

[0314] 그리고 수학식 52로부터 전도성 이미지 접지 평면의 복소 깊이가 수학식 77로서 근사화될 수 있고:

[0315] [수학식 77]

$$d \approx \frac{2}{\gamma_e} = 3.364 + j 3.963 \text{ meters}$$

[0316]

[0317] 여기서 지구의 물리적 경계와 전도성 이미지 접지 평면 사이의 대응하는 위상 시프트는 수학식 78에 의해 주어진다:

[0318] [수학식 78]

$$\theta_d = \beta_o(d/2) = 4.015 - j 4.73^\circ$$

[0319]

[0320] 수학식 65를 사용하여, 손실형 전도성 매체(203)(즉, 지구) 안쪽으로 "내려다볼 때" 보이는 임피던스는 수학식 79로서 결정될 수 있다:

[0321] [수학식 79]

$$Z_{in} = Z_o \tanh(j\theta_d) = R_{in} + jX_{in} = 31.191 + j 26.27 \text{ ohms}$$

[0322]

[0323] 손실형 전도성 매체(203) 안쪽으로 "내려다볼 때" 보이는 무효 성분(X_{in})을 유도 표면과 프로브(200) 안쪽으로 "올려다볼 때" 보이는 무효 성분(X_{base})과 매칭시키는 것에 의해, 유도 표면 도파로 모드에의 결합이 최대화될 수 있다. 이것은 코일 및 수직 공급 라인 전도체의 진행과 위상 지연들을 변화시키지 않으면서 충전 단자(T_1)의

정전용량을 조절하는 것에 의해 달성될 수 있다. 예를 들어, 충전 단자 정전용량(C_T)을 61.8126 pF로 조절하는 것에 의해, 수학식 62로부터의 부하 임피던스는 수학식 80이 되고:

[0324] [수학식 80]

$$Z_L = \frac{1}{j\omega C_T} = -j 1392 \text{ ohms}$$

[0326] 경계에서의 무효 성분들이 매칭된다.

[0327] 수학식 51을 사용하여, 수직 공급 라인 전도체(0.27 인치의 직경^(2a)을 가짐)의 임피던스는 수학식 81로서 주어지고,

[0328] [수학식 81]

$$Z_w = 138 \log \left(\frac{1.123 V_w \lambda_0}{2\pi a} \right) = 537.534 \text{ ohms}$$

[0330] 수직 공급 라인 전도체 안쪽으로 "올려다볼 때" 보이는 임피던스는 수학식 63에 의해 수학식 82로서 주어진다:

[0331] [수학식 82]

$$Z_2 = Z_w \frac{Z_L + Z_w \tanh(j\theta_y)}{Z_w + Z_L \tanh(j\theta_y)} = -j 835.438 \text{ ohms}$$

[0333] 수학식 47을 사용하여, 나선형 코일의 특성 임피던스는 수학식 83으로서 주어지고,

[0334] [수학식 83]

$$Z_c = \frac{60}{V_f} \left[\ell n \left(\frac{V_f \lambda_0}{D} \right) - 1.027 \right] = 1446 \text{ ohms}$$

[0336] 베이스에서 코일 안쪽으로 "올려다볼 때" 보이는 임피던스는 수학식 64에 의해 수학식 84로서 주어진다:

[0337] [수학식 84]

$$Z_{base} = Z_c \frac{Z_2 + Z_c \tanh(j\theta_c)}{Z_c + Z_2 \tanh(j\theta_c)} = -j 26.271 \text{ ohms}$$

[0339] 수학식 79의 해와 비교할 때, 무효 성분들이 서로 마주하고 대략 동일하며, 따라서 서로의 켈레라는 것을 알 수 있다. 따라서, 완전 전도성 이미지 접지 평면으로부터 도 9a 및 도 9b의 등가 이미지 평면 모델 안쪽으로 "올려다볼 때" 보이는 임피던스(Z_{ip})는 저항성뿐이거나 $Z_{ip} = R + j0$ 이다.

[0340] 유도 표면 도파로 프로브(200)(도 3)에 의해 생성된 전기 필드들이 공급 네트워크의 진행과 위상 지연을 파 경사각에 매칭시키는 것에 의해 확립되고 프로브 구조물이 복소 깊이 $z = -d/2$ 에서 완전 전도성 이미지 접지 평면과 관련하여 공진될 때, 필드들이 손실형 전도성 매체의 표면 상의 유도 표면 도파로 모드에 실질적으로 모드-매칭되고, 유도 표면 진행파가 손실형 전도성 매체의 표면을 따라 발견된다. 도 1에 예시된 바와 같이, 유도 전자기 필드의 유도 필드 강도 곡선(103)은 $e^{-\alpha d}/\sqrt{d}$ 의 특성 지수 감쇠를 갖고 로그-로그 스케일에서 특유의 변곡부(109)를 나타낸다.

[0341] 요약하면, 분석적으로도 실험적으로도, 유도 표면 도파로 프로브(200)의 구조물 상의 진행과 성분은 그의 상부 단자에서의 위상 지연(Φ)이 표면 진행파의 파 경사각(Ψ)과 매칭한다($\Phi = \Psi$). 이 조건 하에서, 표면 도파로는 "모드-매칭된(mode-matched)" 것으로 간주될 수 있다. 게다가, 유도 표면 도파로 프로브(200)의 구조물 상의 공진 정재파 성분은 충전 단자(T_1)에서 V_{MAX} 를 그리고 아래에 있는 이미지 평면(139)(도 8b)에서 V_{MIN} 을 가지며, 여기서 손실형 전도성 매체(203)(도 8b)의 물리적 경계(136)에서의 연결에서가 아니라 $z = -d/2$ 의 복소 깊이에서 $Z_{ip} = R_{ip} + j0$ 이다. 마지막으로, 충전 단자(T_1)가 도 3의 충분한 높이(H_1)를 가짐으로써($h \geq R_x \tan \Psi_{i,B}$)

복소 브루스터 각으로 손실형 전도성 매체(203) 상으로 입사하는 전자기파들이 $1/\sqrt{r}$ 항이 우세한 거리($\geq R_x$)에서는 계속 그렇게 된다. 무선 전송 및/또는 전력 전달 시스템들을 용이하게 하기 위해 하나 이상의 유도 표

면 도파로 프로브를 갖는 수신 회로들이 이용될 수 있다.

[0342] 도 3을 다시 참조하면, 유도 표면 도파로 프로브(200)의 동작이 유도 표면 도파로 프로브(200)와 연관된 동작 조건들의 변동들에 맞춰 조절되도록 제어될 수 있다. 예를 들어, 적응적 프로브 제어 시스템(230)은 유도 표면 도파로 프로브(200)의 동작을 제어하기 위해 공급 네트워크(209) 및/또는 충전 단자(T_1)를 제어하는 데 사용될 수 있다. 동작 조건들은 손실형 전도성 매체(203)의 특성들(예컨대, 전도율(σ) 및 상대 유전율(ϵ_r))의 변동들, 필드 강도의 변동들 및/또는 유도 표면 도파로 프로브(200)의 부하(loadings)의 변동들을 포함할 수 있지만, 이들로 제한되지 않는다. 수학적 식 31, 수학적 식 41 및 수학적 식 42로부터 알 수 있는 바와 같이, 굴절률(n), 복소 브루스터 각($\theta_{i,B}$), 및 파 경사($|W|e^{j\psi}$)가, 예컨대, 기상 상태들로 인한 토양 전도율 및 유전율의 변화들에 의해 영향을 받을 수 있다.

[0343] 예컨대, 전도율 측정 프로브들, 유전율 센서들, 접지 파라미터 미터들, 필드 미터들, 전류 모니터들 및/또는 부하 수신기들과 같은 장비가 동작 조건들의 변화들이 있는지 모니터링하고 현재의 동작 조건들에 관한 정보를 적응적 프로브 제어 시스템(230)에게 제공하는 데 사용될 수 있다. 프로브 제어 시스템(230)은 이어서 유도 표면 도파로 프로브(200)에 대한 명시된 동작 조건들을 유지하기 위해 유도 표면 도파로 프로브(200)에 대한 하나 이상의 조절을 행할 수 있다. 예를 들어, 수분과 온도가 변함에 따라, 토양의 전도율이 또한 변할 것이다. 전도율 측정 프로브들 및/또는 유전율 센서들이 유도 표면 도파로 프로브(200) 주위의 다수의 위치들에 위치될 수 있다. 일반적으로, 동작 주파수에 대해 Hankei 크로스오버 거리(R_c)에서의 또는 그 주위에서의 전도율 및/또는 유전율을 모니터링하는 것이 바람직할 것이다. 전도율 측정 프로브들 및/또는 유전율 센서들이 유도 표면 도파로 프로브(200) 주위의 다수의 위치들에(예컨대, 각각의 사분면에) 위치될 수 있다.

[0344] 전도율 측정 프로브들 및/또는 유전율 센서들은 전도율 및/또는 유전율을 주기적으로 평가하고 정보를 프로브 제어 시스템(230)에게 전달하도록 구성될 수 있다. 정보는 LAN, WLAN, 셀룰러 네트워크, 또는 다른 적절한 유선 또는 무선 통신 네트워크 - 이들로 제한되지 않음 - 와 같은 네트워크를 통해 프로브 제어 시스템(230)에게 전달될 수 있다. 모니터링된 전도율 및/또는 유전율에 기초하여, 프로브 제어 시스템(230)은, 공급 네트워크(209)의 위상 지연(Φ)을 파 경사각(Ψ)과 동일하도록 유지하기 위해 그리고/또는 유도 표면 도파로 프로브(200)의 등가 이미지 평면 모델의 공진을 유지하기 위해, 굴절률(n), 복소 브루스터 각($\theta_{i,B}$), 및/또는 파 경사($|W|e^{j\psi}$)의 변동을 평가하고 유도 표면 도파로 프로브(200)를 조절할 수 있다. 이것은, 예컨대, θ_y , θ_c 및/또는 C_T 를 조절하는 것에 의해 달성될 수 있다. 예를 들어, 프로브 제어 시스템(230)은, 유도 표면파의 전기적 발진 효율(electrical launching efficiency)을 그의 최대치에 또는 그 근방에 유지하기 위해, 충전 단자(T_1)의 자기 정전용량 및/또는 충전 단자(T_1)에 인가되는 위상 지연(θ_y , θ_c)을 조절할 수 있다. 예를 들어, 충전 단자(T_1)의 자기 정전용량은 단자의 크기를 변화시키는 것에 의해 변화될 수 있다. 충전 단자(T_1)의 크기를 증가시키는 것 - 이는 충전 단자(T_1)로부터의 전기 방전의 가능성을 감소시킬 수 있음 - 에 의해 전하 분포가 또한 개선될 수 있다. 다른 실시예들에서, 충전 단자(T_1)는 부하 임피던스(Z_L)를 변화시키기 위해 조절될 수 있는 가변 인덕턴스를 포함할 수 있다. 코일(215)(도 7) 상의 탭 위치를 변화시키는 것에 의해 그리고/또는 코일(215)을 따라 복수의 미리 정의된 탭들을 포함시키고 발진 효율을 최대화하도록 상이한 미리 정의된 탭 위치들 간에 스위칭하는 것에 의해, 충전 단자(T_1)에 인가되는 위상이 조절될 수 있다.

[0345] 유도 표면파와 연관된 필드들의 필드 강도를 측정하기 위해 필드 또는 필드 강도(FS) 미터들이 또한 유도 표면 도파로 프로브(200) 주위에 분포될 수 있다. 필드 또는 FS 미터들은 필드 강도 및/또는 필드 강도(예컨대, 전기 필드 강도)의 변화들을 검출하고 그 정보를 프로브 제어 시스템(230)에게 전달하도록 구성될 수 있다. 정보는 LAN, WLAN, 셀룰러 네트워크, 또는 다른 적절한 통신 네트워크 - 이들로 제한되지 않음 - 와 같은 네트워크를 통해 프로브 제어 시스템(230)에게 전달될 수 있다. 부하 및/또는 환경 조건들이 동작 동안 변화하거나 변화함에 따라, 수신기들 및 이들이 공급하는 부하들에의 적절한 전력 전달을 보장하기 위해 FS 미터 위치들에서 명시된 필드 강도(들)를 유지하도록 유도 표면 도파로 프로브(200)가 조절될 수 있다.

[0346] 예를 들어, 충전 단자(T_1)에 인가되는 위상 지연($\Phi = \theta_y + \theta_c$)이 파 경사각(Ψ)과 매칭하도록 조절될 수 있다. 한쪽 또는 양쪽 위상 지연들을 조절하는 것에 의해, 파 경사가 복소 브루스터 각에 대응하도록 보장하기 위해 유도 표면 도파로 프로브(200)가 조절될 수 있다. 이것은 충전 단자(T_1)에 공급되는 위상 지연을 변화시

키기 위해 코일(215)(도 7) 상의 탭 위치를 조절하는 것에 의해 달성될 수 있다. 충전 단자(T_1)에 공급되는 전압 레벨이 전기 필드 강도를 조절하기 위해 증가 또는 감소될 수 있다. 이것은 여기 소스(212)의 출력 전압을 조절하는 것에 의해 또는 공급 네트워크(209)를 조절 또는 재구성하는 것에 의해 달성될 수 있다. 예를 들어, AC 소스(212)에 대한 탭(227)(도 7)의 위치가 충전 단자(T_1)에게 보이는 전압을 증가시키도록 조절될 수 있다. 필드 강도 레벨들을 미리 정의된 범위들 내에 유지하는 것은 수신기들에 의한 결합을 개선시키고, 접지 전류 손실들을 감소시키며, 다른 유도 표면 도파로 프로브들(200)로부터의 전송과의 간섭을 회피할 수 있다.

[0347] 프로브 제어 시스템(230)은 하드웨어, 펌웨어, 하드웨어에 의해 실행되는 소프트웨어, 또는 이들의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 프로브 제어 시스템(230)은 프로세서 및 메모리 - 이들 둘 다는, 본 기술분야의 통상의 기술자에 의해 인지될 수 있는 바와 같이, 예를 들어, 부수된 제어/주소 버스를 갖는 데이터 버스와 같은 로컬 인터페이스에 결합될 수 있음 - 를 포함하는 처리 회로부를 포함할 수 있다. 모니터링된 조건들에 기초하여 유도 표면 도파로 프로브(200)의 동작을 조절하기 위해 프로세서에 의해 프로브 제어 애플리케이션이 실행될 수 있다. 프로브 제어 시스템(230)은 또한 다양한 모니터링 디바이스들과 통신하기 위한 하나 이상의 네트워크 인터페이스를 포함할 수 있다. 통신은 LAN, WLAN, 셀룰러 네트워크, 또는 다른 적절한 통신 네트워크 - 이들로 제한되지 않음 - 와 같은 네트워크를 통해 수 있다. 프로브 제어 시스템(230)은, 예를 들어, 서버, 데스크톱 컴퓨터, 랩톱, 또는 유사한 능력을 갖는 다른 시스템과 같은 컴퓨터 시스템을 포함할 수 있다.

[0348] 도 5a의 예를 다시 참조하면, Hankel 크로스오버 거리(R_x)에서 복소 브루스터 각($\theta_{i,B}$)을 갖는 충전 단자(T_1)의 입사 전기 필드(E)의 광선 광학 해석에 대한 복소 각도 삼각법이 도시되어 있다. 손실형 전도성 매체에 대해, 브루스터 각이 복소수이고 수학적 식 38에 의해 명시된다는 것을 상기한다. 전기적으로, 기하학적 파라미터들은 수학적 식 39에 의해 충전 단자(T_1)의 전기적 유효 높이(h_{eff})에 의해 관련되어 있다. 물리적 높이(h_p)와 Hankel 크로스오버 거리(R_x) 둘 다 실수량들이기 때문에, Hankel 크로스오버 거리에서의 원하는 유도 표면파 경사(W_{Rx})의 각도가 복소 유효 높이(h_{eff})의 위상(Φ)과 동일하다. 충전 단자(T_1)가 물리적 높이(h_p)에 위치되고 적절한 위상(Φ)을 갖는 전하로 여기된 경우, 결과적인 전기 필드는 Hankel 크로스오버 거리(R_x)에서 그리고 브루스터 각으로 손실형 전도성 매체 경계 계면에 입사한다. 이러한 조건들 하에서, 반사 없이 또는 실질적으로 무시할 만한 반사로 유도 표면 도파로 모드가 여기될 수 있다.

[0349] 그렇지만, 수학적 식 39는 유도 표면 도파로 프로브(200)의 물리적 높이가 비교적 작을 수 있다는 것을 의미한다. 이것이 유도 표면 도파로 모드를 여기시킬 것이지만, 이것은 적은 자유 전하를 갖는 과도하게 큰 속박 전하를 초래할 수 있다. 보상하기 위해, 충전 단자(T_1)가 자유 전하의 양을 증가시키기 위해 적절한 고도까지 상승될 수 있다. 하나의 예시적인 경험적으로서, 충전 단자(T_1)가 충전 단자(T_1)의 유효 직경의 약 4 내지 5배(또는 그 이상)의 고도에 위치될 수 있다. 도 6은 도 5a에 도시된 물리적 높이(h_p)보다 위쪽으로 충전 단자(T_1)를 상승시키는 것의 효과를 예시하고 있다. 증가된 고도는 파 경사가 손실형 전도성 매체에 입사하는 거리를 Hankel 크로스오버 지점(121)(도 5a)을 넘어서 이동시킨다. 유도 표면 도파로 모드에의 결합을 개선시키고, 따라서 유도 표면파의 보다 큰 발전 효율을 제공하기 위해, 하부 보상 단자(T_2)가 Hankel 크로스오버 거리에서의 파 경사가 브루스터 각으로 있도록 충전 단자(T_1)의 총 유효 높이(h_{TE})를 조절하는 데 사용될 수 있다.

[0350] 도 12를 참조하면, 손실형 전도성 매체(203)에 의해 제공되는 평면에 수직인 수직 축(z)을 따라 배열되는 상승된 충전 단자(T_1) 및 하부 보상 단자(T_2)를 포함하는 유도 표면 도파로 프로브(200c)의 일 예가 도시되어 있다. 이와 관련하여, 충전 단자(T_1)가 보상 단자(T_2) 바로 위쪽에 위치되지만, 2개 이상의 충전 및/또는 보상 단자(T_N)의 어떤 다른 배열이 사용될 수 있는 것이 가능하다. 본 개시내용의 일 실시예에 따르면, 유도 표면 도파로 프로브(200c)는 손실형 전도성 매체(203) 위쪽에 배치된다. 손실형 전도성 매체(203)는 영역 1을 구성하고, 제2 매체(206)는 영역 2를 구성하며 손실형 전도성 매체(203)와 경계 계면을 공유한다.

[0351] 유도 표면 도파로 프로브(200c)는 여기 소스(212)를 충전 단자(T_1) 및 보상 단자(T_2)에 결합시키는 공급 네트워크(209)를 포함한다. 다양한 실시예들에 따르면, 임의의 주어진 순간에 단자들(T_1 및 T_2)에 인가되는 전압들에 의존하는 전하들(Q_1 및 Q_2)이 각자의 충전 및 보상 단자들(T_1 및 T_2) 상에 부여될 수 있다. I_1 은 단자 리드를 거쳐 충전 단자(T_1) 상에 전하(Q_1)를 공급하는 전도 전류이고, I_2 는 단자 리드를 거쳐 보상 단자(T_2) 상에 전하(Q

2)를 공급하는 전도 전류이다.

[0352] 도 12의 실시예에 따르면, 충전 단자(T_1)는 손실형 전도성 매체(203) 위쪽으로 물리적 높이(H_1)에 위치되고, 보상 단자(T_2)는 수직 축(z)을 따라 T_1 바로 아래로 물리적 높이(H_2)에 위치되며, 여기서 H_2 는 H_1 보다 작다. 전송 구조물의 높이(h)는 $h = H_1 - H_2$ 로서 계산될 수 있다. 충전 단자(T_1)는 고립(또는 자기) 정전용량(C_1)을 갖고, 보상 단자(T_2)는 고립(또는 자기) 정전용량(C_2)을 갖는다. 단자(T_1)와 단자(T_2) 사이에 그들 사이의 거리에 의존하는 상호 정전용량(C_M)이 또한 존재할 수 있다. 동작 동안, 임의의 주어진 순간에 충전 단자(T_1) 및 보상 단자(T_2)에 인가되는 전압들에 의존하는 전하(Q_1)와 전하(Q_2)가 충전 단자(T_1)와 보상 단자(T_2)에, 각각, 부여된다.

[0353] 다음에 도 13을 참조하면, 도 12의 충전 단자(T_1) 상의 상승된 전하(Q_1) 및 보상 단자(T_2)에 의해 생성된 효과들의 광선 광학 해석이 도시되어 있다. 충전 단자(T_1)가 광선이 라인(163)에 의해 예시된 바와 같이 Hankel 크로스오버 지점(121)보다 더 큰 거리에서 손실형 전도성 매체와 브루스터 각으로 교차하는 높이로 상승된 경우, 보상 단자(T_2)는 증가된 높이를 보상함으로써 h_{TE} 를 조절하는 데 사용될 수 있다. 보상 단자(T_2)의 효과는 라인(166)에 의해 예시된 바와 같이 Hankel 크로스오버 거리에서의 파 경사가 브루스터 각으로 있도록 유도 표면 도파로 프로브의 전기적 유효 높이를 감소시키는 것(또는 손실형 매체 계면을 효과적으로 상승시키는 것)이다.

[0354] 총 유효 높이는 수학식 85이도록 충전 단자(T_1)와 연관된 상부 유효 높이(h_{UE})와 보상 단자(T_2)와 연관된 하부 유효 높이(h_{LE})의 중첩으로서 쓰여질 수 있고,

[0355] [수학식 85]

$$h_{TE} = h_{UE} + h_{LE} = h_p e^{j(\beta h_p + \Phi_U)} + h_d e^{j(\beta h_d + \Phi_L)} = R_x \times W$$

[0357] 여기서 Φ_U 는 상부 충전 단자(T_1)에 인가된 위상 지연이고, Φ_L 은 하부 보상 단자(T_2)에 인가된 위상 지연이며, $\beta = 2\pi/\lambda_p$ 는 수학식 35로부터의 전파 인자이고, h_p 는 충전 단자(T_1)의 물리적 높이이며, h_d 는 보상 단자(T_2)의 물리적 높이이다. 추가 리드 길이들이 고려되는 경우, 이들이 수학식 86에 나타낸 바와 같이 충전 단자 리드 길이(z)를 충전 단자(T_1)의 물리적 높이(h_p)에 그리고 보상 단자 리드 길이(y)를 보상 단자(T_2)의 물리적 높이(h_d)에 가산하는 것에 의해 참작될 수 있다.

[0358] [수학식 86]

$$h_{TE} = (h_p + z) e^{j(\beta(h_p + z) + \Phi_U)} + (h_d + y) e^{j(\beta(h_d + y) + \Phi_L)} = R_x \times W$$

[0360] 총 유효 높이(h_{TE})를 도 5a의 복소 유효 높이(h_{eff})와 동일하도록 조절하기 위해 하부 유효 높이가 사용될 수 있다.

[0361] Hankel 크로스오버 거리에서 원하는 파 경사를 획득하기 위해 보상 단자(T_2)의 하부 디스크의 물리적 높이 및 단자들에 공급할 위상각들을 결정하는 데 수학식 85 또는 수학식 86이 사용될 수 있다. 예를 들어, 수학식 86은 수학식 87을 제공하도록 보상 단자 높이(h_d)의 함수로서 충전 단자(T_1)에 인가되는 위상 시프트로서 다시 쓰여질 수 있다.

[0362] [수학식 87]

$$\Phi_U(h_d) = -\beta(h_p + z) - j \ln \left(\frac{R_x \times W - (h_d + y) e^{j(\beta h_d + \beta y + \Phi_L)}}{(h_p + z)} \right)$$

[0364] 보상 단자(T_2)의 위치선정을 결정하기 위해, 앞서 논의된 관계들이 이용될 수 있다. 먼저, 총 유효 높이(h_{TE})는, 수학식 86에 표현된 바와 같이, 상부 충전 단자(T_1)의 복소 유효 높이(h_{UE})와 하부 보상 단자(T_2)의 복소 유효 높이(h_{LE})의 중첩이다. 다음에, 입사각의 탄젠트는 기하학적으로 수학식 88로서 표현될 수 있고,

[0365] [수학식 88]

[0366]
$$\tan \psi_E = \frac{h_{TE}}{R_x}$$

[0367] 수학식 88은 파 경사(W)의 정의와 동일하다. 마지막으로, 원하는 Hankel 크로스오버 거리(R_x)가 주어지면, 입사 광선의 파 경사를 Hankel 크로스오버 지점(121)에서의 복소 브루스터 각과 매칭시키기 위해 h_{TE} 가 조절될 수 있다. 이것은 h_p , Φ_U , 및/또는 h_d 를 조절하는 것에 의해 달성될 수 있다.

[0368] 이 개념들은 유도 표면 도파로 프로브의 일 예와 관련하여 논의될 때 보다 잘 이해될 수 있다. 도 14를 참조하면, 손실형 전도성 매체(203)에 의해 제공되는 평면에 실질적으로 수직인 수직 축(z)을 따라 위치되는 상부 충전 단자(T_1)(예컨대, 높이 h_T 에 있는 구체) 및 하부 보상 단자(T_2)(예컨대, 높이 h_d 에 있는 디스크)를 포함하는 유도 표면 도파로 프로브(200d)의 일 예의 그래픽 표현이 도시되어 있다. 동작 동안, 임의의 주어진 순간에 단자들(T_1 및 T_2)에 인가되는 전압들에 의존하는 전하(Q_1)와 전하(Q_2)가 충전 단자(T_1)와 보상 단자(T_2)에, 각각, 부여된다.

[0369] AC 소스(212)는 충전 단자(T_1)에 대한 여기 소스로서 기능하고, 이는, 예컨대, 나선형 코일과 같은 코일(215)을 포함하는 공급 네트워크(209)를 통해 유도 표면 도파로 프로브(200d)에 결합된다. AC 소스(212)는, 도 14에 도시된 바와 같이, 탭(227)을 통해 코일(215)의 하부 부분에 걸쳐 연결될 수 있거나, 1차 코일을 통해 코일(215)에 유도적으로 결합될 수 있다. 코일(215)은 제1 단부에서 접지 말뚝(218)에 그리고 제2 단부에서 충전 단자(T_1)에 결합될 수 있다. 일부 구현들에서, 충전 단자(T_1)에의 연결은 코일(215)의 제2 단부에 있는 탭(224)을 사용하여 조절될 수 있다. 보상 단자(T_2)는 손실형 전도성 매체(203)(예컨대, 지면 또는 지구)의 위쪽에 그와 실질적으로 평행하게 위치되고, 코일(215)에 결합된 탭(233)을 통해 에너지를 공급받는다. 코일(215)과 접지 말뚝(218) 사이에 위치된 전류계(236)는 유도 표면 도파로 프로브의 베이스에서의 전류 흐름(I_0)의 크기의 표시를 제공하는 데 사용될 수 있다. 대안적으로, 전류 흐름(I_0)의 크기의 표시를 획득하기 위해 접지 말뚝(218)에 결합된 전도체 주위에 전류 클램프(current clamp)가 사용될 수 있다.

[0370] 도 14의 예에서, 코일(215)은 제1 단부에서 접지 말뚝(218)에 그리고 제2 단부에서 수직 공급 라인 전도체(221)를 통해 충전 단자(T_1)에 결합된다. 일부 구현들에서, 도 14에 도시된 바와 같이, 충전 단자(T_1)에의 연결은 코일(215)의 제2 단부에 있는 탭(224)을 사용하여 조절될 수 있다. 코일(215)은 코일(215)의 하부 부분에 있는 탭(227)을 통해 AC 소스(212)에 의해 동작 주파수로 에너지를 공급받을 수 있다. 다른 구현들에서, AC 소스(212)는 1차 코일을 통해 코일(215)에 유도적으로 결합될 수 있다. 보상 단자(T_2)는 코일(215)에 결합된 탭(233)을 통해 에너지를 공급받는다. 코일(215)과 접지 말뚝(218) 사이에 위치된 전류계(236)는 유도 표면 도파로 프로브(200d)의 베이스에서의 전류 흐름의 크기의 표시를 제공하는 데 사용될 수 있다. 대안적으로, 전류 흐름의 크기의 표시를 획득하기 위해 접지 말뚝(218)에 결합된 전도체 주위에 전류 클램프가 사용될 수 있다. 보상 단자(T_2)는 손실형 전도성 매체(203)(예컨대, 지면) 위쪽에 그와 실질적으로 평행하게 위치된다.

[0371] 도 14의 예에서, 코일(215) 상에 위치된 충전 단자(T_1)에의 연결은 보상 단자(T_2)에 대한 탭(233)의 연결 지점 위쪽에 있다. 이러한 조절은 증가된 전압(그리고 따라서 보다 높은 전하(Q_1))이 상부 충전 단자(T_1)에 인가될 수 있게 한다. 다른 실시예들에서, 충전 단자(T_1) 및 보상 단자(T_2)에 대한 연결 지점들이 반대로 될 수 있다. Hankel 크로스오버 거리(R_x)에서 유도 표면과 경사를 갖는 전기 필드를 여기시키기 위해 유도 표면 도파로 프로브(200d)의 총 유효 높이(h_{TE})를 조절하는 것이 가능하다. 도 4에 예시된 바와 같이 Hankel 크로스오버 거리 R_x 또한 $-jY\rho$ 에 대하여 수학식 20b의 크기와 수학식 21의 크기를 같다고 놓고 R_x 에 대해 푸는 것에 의해 구해질 수 있다. 굴절률(n), 복소 브루스터 각($\Theta_{i,B}$ 및 $\Psi_{i,B}$), 파 경사($|W|e^{j\varphi}$) 및 복소 유효 높이($h_{eff} = h_p e^{j\Phi}$)가 상기 수학식 41 내지 수학식 44와 관련하여 기술된 바와 같이 결정될 수 있다.

[0372] 선택된 충전 단자(T_1) 구성의 경우, 구체 직경(또는 유효 구체 직경)이 결정될 수 있다. 예를 들어, 충전 단자(T_1)가 구체로서 구성되지 않은 경우, 단자 구성이 유효 구체 직경을 갖는 구체 정전용량으로서 모델링될 수 있

다. 충전 단자(T_1)의 크기는 단자들 상에 부여된 전하(Q_1)를 위한 충분히 큰 표면을 제공하도록 선택될 수 있다. 일반적으로, 충전 단자(T_1)를 실용적일 정도로 크게 만드는 것이 바람직하다. 충전 단자(T_1)의 크기는, 충전 단자 주변에 전기 방전 또는 스파크 발생을 초래할 수 있는, 주변 공기의 이온화를 피할 정도로 충분히 커야 한다. 충전 단자(T_1) 상의 속박 전하의 양을 감소시키기 위해, 유도 표면파를 발진시키기 위한 충전 단자(T_1) 상의 자유 전하를 제공하는 원하는 고도는 손실형 전도성 매체(예컨대, 지구) 위쪽에 있는 유효 구체 직경의 4 내지 5배 이상이어야만 한다. 보상 단자(T_2)는 R_x 에서 유도 표면파 경사를 갖는 전기 필드를 여기시키기 위해 유도 표면 도파로 프로브(200d)의 총 유효 높이(h_{TE})를 조절하는 데 사용될 수 있다. 보상 단자(T_2)는 충전 단자(T_1) 아래로 $h_d = h_T - h_p$ 에 위치될 수 있고, 여기서 h_T 는 충전 단자(T_1)의 총 물리적 높이이다. 보상 단자(T_2)의 위치가 고정되고 위상 지연(Φ_U)이 상부 충전 단자(T_1)에 인가되는 경우, 하부 보상 단자(T_2)에 인가되는 위상 지연(Φ_L)이 수학식 89이도록 수학식 86의 관계들을 사용하여 결정될 수 있다:

[0373] [수학식 89]

$$\Phi_U(h_d) = -\beta(h_d + y) - j \ln \left(\frac{R_x \times W - (h_p + z)e^{j(\beta h_p + \beta z + \Phi_L)}}{(h_d + y)} \right)$$

대안의 실시예들에서, 보상 단자(T_2)가 $\text{Im}\{\Phi_L\} = 0$ 인 높이 h_d 에 위치될 수 있다. 이것이 도 15a에 그래픽으로 예시되어 있으며, 도 15a는 Φ_U 의 허수부의 플롯(172) 및 실수부의 플롯(175)을 도시하고 있다. 보상 단자(T_2)는, 플롯(172)에 그래픽으로 예시된 바와 같이, $\text{Im}\{\Phi_U\} = 0$ 인 높이 h_d 에 위치된다. 이 고정 높이에서, 플롯(175)에 그래픽으로 예시된 바와 같이, 코일 위상(Φ_U)은 $\text{Re}\{\Phi_U\}$ 로부터 결정될 수 있다.

AC 소스(212)가 (예컨대, 결합을 최대화하기 위해 50Ω 지점에서) 코일(215)에 결합된 경우, 동작 주파수에서 보상 단자(T_2)와 코일의 적어도 일부분 간의 병렬 공진을 위해 탭(233)의 위치가 조절될 수 있다. 도 15b는 도 14의 개괄적인 전기 배선(electrical hookup)의 개략 다이어그램을 도시하고 있으며, 여기서 V_1 은 AC 소스(212)로부터 탭(227)을 통해 코일(215)의 하부 부분에 인가되는 전압이고, V_2 는 상부 충전 단자(T_1)에 공급되는 탭(224)에서의 전압이며, V_3 은 탭(233)을 통해 하부 보상 단자(T_2)에 인가되는 전압이다. 저항(R_p) 및 저항(R_d)은, 각각, 충전 단자(T_1) 및 보상 단자(T_2)의 접지 귀로 저항(ground return resistance)들을 나타낸다. 충전 단자(T_1) 및 보상 단자(T_2)는 구체, 원통, 토로이드(toroid), 링, 후드, 또는 용량성 구조물의 임의의 다른 조합으로서 구성될 수 있다. 충전 단자(T_1) 및 보상 단자(T_2)의 크기는 단자들 상에 부여된 전하들(Q_1 및 Q_2)을 위한 충분히 큰 표면을 제공하도록 선택될 수 있다. 일반적으로, 충전 단자(T_1)를 실용적일 정도로 크게 만드는 것이 바람직하다. 충전 단자(T_1)의 크기는, 충전 단자 주변에 전기 방전 또는 스파크 발생을 초래할 수 있는, 주변 공기의 이온화를 피할 정도로 충분히 커야 한다. 충전 단자(T_1)의 자기 정전용량(C_p) 및 보상 단자(T_2)의 자기 정전용량(C_d)은, 예를 들어, 수학식 24를 사용하여 결정될 수 있다.

도 15b에서 알 수 있는 바와 같이, 코일(215)의 인덕턴스의 적어도 일부분, 보상 단자(T_2)의 자기 정전용량(C_d), 및 보상 단자(T_2)와 연관된 접지 귀로 저항(R_d)에 의해 공진 회로가 형성된다. 보상 단자(T_2)에 인가되는 전압(V_3)을 조절하는 것에 의해(예컨대, 코일(215) 상의 탭(233) 위치를 조절하는 것에 의해) 또는 C_d 를 조절하기 위해 보상 단자(T_2)의 높이 및/또는 크기를 조절하는 것에 의해 병렬 공진이 확립될 수 있다. 병렬 공진을 위해 코일 탭(233)의 위치가 조절될 수 있으며, 그 결과 접지 말뚝(218)을 통한 그리고 전류계(236)를 통한 접지 전류가 최대 지점에 도달할 것이다. 보상 단자(T_2)의 병렬 공진이 확립된 후에, AC 소스(212)에 대한 탭(227)의 위치가 코일(215) 상의 50Ω 지점으로 조절될 수 있다.

코일(215)로부터의 전압(V_2)이 충전 단자(T_1)에 인가될 수 있고, 총 유효 높이(h_{TE})의 위상(Φ)이 Hankele 크로스 오버 거리(R_x)에서의 유도 표면파 경사(W_{RX})의 각도와 대략 동일하도록 탭(224)의 위치가 조절될 수 있다. 이 동작점에 도달할 때까지 코일 탭(224)의 위치가 조절될 수 있고, 그 결과 전류계(236)를 통한 접지 전류가 최대

로 증가한다. 이 시점에서, 유도 표면 도파로 프로브(200d)에 의해 여기되는 결과적인 필드들이 손실형 전도성 매체(203)의 표면 상에서의 유도 표면 도파로 모드에 실질적으로 모드-매칭되고, 그 결과 유도 표면파가 손실형 전도성 매체(203)의 표면을 따라 발진한다. 이것은 유도 표면 도파로 프로브(200)로부터 연장되는 방사상 구조(radial)를 따라 필드 강도를 측정하는 것에 의해 검증될 수 있다.

[0379] 보상 단자(T_2)를 포함하는 회로의 공진이 충전 단자(T_1)의 부차에 따라 그리고/또는 탭(224)을 통해 충전 단자(T_1)에 인가되는 전압의 조절에 따라 변할 수 있다. 공진을 위해 보상 단자 회로를 조절하는 것이 충전 단자 연결의 후속 조절에는 도움이 되지만, Hankel 크로스오버 거리(R_x)에서 유도 표면파 경사(W_{Rx})를 확립하는 데는 필요하지 않다. 이 시스템은, AC 소스(212)가 코일(215) 상의 50Ω 지점에 있도록 탭(227)의 위치를 반복적으로 조절하는 것 및 전류계(236)를 통한 접지 전류를 최대화하기 위해 탭(233)의 위치를 조절하는 것에 의해, 결합을 개선시키기 위해 추가로 조절될 수 있다. 탭(227) 및 탭(233)의 위치들이 조절될 때 또는 다른 컴포넌트들이 코일(215)에 부착될 때 보상 단자(T_2)를 포함하는 회로의 공진이 드리프트할 수 있다.

[0380] 다른 구현들에서, 코일(215)로부터의 전압(V_2)이 충전 단자(T_1)에 인가될 수 있고, 총 유효 높이(h_{TE})의 위상(Φ)이 R_x 에서의 유도 표면파 경사각(Ψ)과 대략 동일하도록 탭(233)의 위치가 조절될 수 있다. 동작점에 도달할 때까지 코일 탭(224)의 위치가 조절될 수 있고, 그 결과 전류계(236)를 통한 접지 전류가 최대치에 실질적으로 도달한다. 결과적인 필드들이 손실형 전도성 매체(203)의 표면 상에서의 유도 표면 도파로 모드에 실질적으로 모드-매칭되고, 유도 표면파가 손실형 전도성 매체(203)의 표면을 따라 발진된다. 이것은 유도 표면 도파로 프로브(200)로부터 연장되는 방사상 구조(radial)를 따라 필드 강도를 측정하는 것에 의해 검증될 수 있다. 이 시스템은, AC 소스(212)가 코일(215) 상의 50Ω 지점에 있도록 탭(227)의 위치를 반복적으로 조절하는 것 및 전류계(236)를 통한 접지 전류를 최대화하기 위해 탭(224 및/또는 233)의 위치를 조절하는 것에 의해, 결합을 개선시키기 위해 추가로 조절될 수 있다.

[0381] 도 12를 다시 참조하면, 유도 표면 도파로 프로브(200)의 동작이 유도 표면 도파로 프로브(200)와 연관된 동작 조건들의 변동들에 맞춰 조절되도록 제어될 수 있다. 예를 들어, 프로브 제어 시스템(230)은 유도 표면 도파로 프로브(200)의 동작을 제어하기 위해 공급 네트워크(209) 그리고/또는 충전 단자(T_1) 및/또는 보상 단자(T_2)의 위치선정을 제어하는 데 사용될 수 있다. 동작 조건들은 손실형 전도성 매체(203)의 특성들(예컨대, 전도율(σ) 및 상대 유전율(ϵ_r))의 변동들, 필드 강도의 변동들 및/또는 유도 표면 도파로 프로브(200)의 부하의 변동들을 포함할 수 있지만, 이들로 제한되지 않는다. 수학적 41 내지 수학적 44로부터 알 수 있는 바와 같이, 굴절률(n), 복소 브루스터 각($\Theta_{i,B}$ 및 $\Psi_{i,B}$), 과 경사($|W|e^{j\Psi}$) 및 복소 유효 높이($h_{eff} = h_p e^{j\Phi}$)가, 예컨대, 기상 상태들로 인한 토양 전도율 및 유전율의 변화들에 의해 영향을 받을 수 있다.

[0382] 예컨대, 전도율 측정 프로브들, 유전율 센서들, 접지 파라미터 미터들, 필드 미터들, 전류 모니터들 및/또는 부하 수신기들과 같은 장비가 동작 조건들의 변화들이 있는지 모니터링하고 현재의 동작 조건들에 관한 정보를 프로브 제어 시스템(230)에게 제공하는 데 사용될 수 있다. 프로브 제어 시스템(230)은 이어서 유도 표면 도파로 프로브(200)에 대한 명시된 동작 조건들을 유지하기 위해 유도 표면 도파로 프로브(200)에 대한 하나 이상의 조절을 행할 수 있다. 예를 들어, 수분과 온도가 변함에 따라, 토양의 전도율이 또한 변할 것이다. 전도율 측정 프로브들 및/또는 유전율 센서들이 유도 표면 도파로 프로브(200) 주위의 다수의 위치들에 위치될 수 있다. 일반적으로, 동작 주파수에 대해 Hankel 크로스오버 거리(R_x)에서의 또는 그 주위에서의 전도율 및/또는 유전율을 모니터링하는 것이 바람직할 것이다. 전도율 측정 프로브들 및/또는 유전율 센서들이 유도 표면 도파로 프로브(200) 주위의 다수의 위치들에(예컨대, 각각의 사분면에) 위치될 수 있다.

[0383] 이어서 도 16을 참조하면, 수직 축(z)을 따라 배열되는 충전 단자(T_1) 및 충전 단자(T_2)를 포함하는 유도 표면 도파로 프로브(200e)의 일 예가 도시되어 있다. 유도 표면 도파로 프로브(200e)는, 영역 1을 구성하는, 손실형 전도성 매체(203) 위쪽에 배치된다. 그에 부가하여, 제2 매체(206)는 손실형 전도성 매체(203)와 경계 계면을 공유하고 영역 2를 구성한다. 충전 단자들(T_1 및 T_2)은 손실형 전도성 매체(203) 위쪽에 위치된다. 충전 단자(T_1)는 높이(H_1)에 위치되고, 충전 단자(T_2)는 수직 축(z)을 따라 T_1 바로 아래로 높이(H_2)에 위치되며, 여기서 H_2 는 H_1 보다 작다. 유도 표면 도파로 프로브(200e)에 의해 제공되는 전송 구조물의 높이(h)는 $h = H_1 - H_2$ 이다. 유도 표면 도파로 프로브(200e)는 여기 소스(212)를 충전 단자들(T_1 및 T_2)에 결합시키는 공급 네트워크(209)를

포함한다.

[0384] 충전 단자들(T_1 및/또는 T_2)은, 실용적으로 가능한 한 많은 전하를 보유하는 크기로 될 수 있는, 전하를 보유할 수 있는 전도성 질량체(conductive mass)를 포함한다. 충전 단자(T_1)는 자기 정전용량(C_1)을 갖고, 충전 단자(T_2)는 자기 정전용량(C_2)을 가지며, 이 자기 정전용량들은, 예를 들어, 수학적 24를 사용하여 결정될 수 있다. 충전 단자(T_1)를 충전 단자(T_2) 바로 위쪽에 배치하는 것에 의해, 충전 단자(T_1)와 충전 단자(T_2) 사이에 상호 정전용량(C_M)이 생성된다. 충전 단자들(T_1 및 T_2)이 동일할 필요는 없고, 각각이 개별적인 크기 및 형상을 가질 수 있으며, 상이한 전도성 재료들을 포함할 수 있다는 것에 유의한다. 궁극적으로, 유도 표면 도파로 프로브(200e)에 의해 발견되는 유도 표면파의 필드 강도는 단자(T_1) 상의 전하의 양에 정비례한다. 전하(Q_1)는, 차례로, 충전 단자(T_1)와 연관된 자기 정전용량(C_1)에 비례하는데, 그 이유는 $Q_1 = C_1 V$ 이기 때문이고, 여기서 V 는 충전 단자(T_1) 상에 부여된 전압이다.

[0385] 미리 정의된 동작 주파수에서 동작하도록 적절하게 조절될 때, 유도 표면 도파로 프로브(200e)는 손실형 전도성 매체(203)의 표면을 따라 유도 표면파를 생성한다. 여기 소스(212)는 구조물을 여기시키기 위해 유도 표면 도파로 프로브(200e)에 인가되는 전기 에너지를 미리 정의된 주파수로 생성할 수 있다. 유도 표면 도파로 프로브(200e)에 의해 생성된 전자기 필드들이 손실형 전도성 매체(203)와 실질적으로 모드-매칭될 때, 전자기 필드들은 반사를 거의 또는 전혀 초래하지 않는 복소 브루스터 각으로 입사하는 파면을 실질적으로 합성한다. 따라서, 표면 도파로 프로브(200e)는 방사파를 생성하지 않고, 손실형 전도성 매체(203)의 표면을 따라 유도 표면 진행파를 발견시킨다. 여기 소스(212)로부터의 에너지는 유도 표면 도파로 프로브(200e)의 유효 전송 범위(effective transmission range) 내에 위치되는 하나 이상의 수신기에게 Zenneck 표면 전류들로서 전송될 수 있다.

[0386] 손실형 전도성 매체(203)의 표면 상에서의 방사상 Zenneck 표면 전류($J_\rho(\rho)$)의 점근선들이 근위에서 $J_1(\rho)$ 이고 원위에서 $J_2(\rho)$ 인 것으로 결정할 수 있고, 여기서

[0387] [수학적 90]

[0388] Close-in ($\rho < \lambda/8$): $J_\rho(\rho) \sim J_1 = \frac{I_1 + I_2}{2\pi\rho} + \frac{E_\rho^{QS}(Q_1) + E_\rho^{QS}(Q_2)}{Z_\rho}$

[0389] 이고,

[0390] [수학적 91]

[0391] Far-out ($\rho \gg \lambda/8$): $J_\rho(\rho) \sim J_2 = \frac{j\gamma\omega Q_1}{4} \times \sqrt{\frac{2\gamma}{\pi}} \times \frac{e^{-(\alpha+j\beta)\rho}}{\sqrt{\rho}}$

[0392] 이며,

[0393] 여기서 I_1 은 제1 충전 단자(T_1) 상의 전하(Q_1)를 공급하는 전도 전류이고, I_2 는 제2 충전 단자(T_2) 상의 전하(Q_2)를 공급하는 전도 전류이다. 상부 충전 단자(T_1) 상의 전하(Q_1)는 $Q_1 = C_1 V_1$ 에 의해 결정되고, 여기서 C_1 은 충

전 단자(T_1)의 고립 정전용량(isolated capacitance)이다. $(E_\rho^{Q_1})/Z_\rho$ 에 의해 주어지는 앞서 기재된 J_1 에 대한 제3 성분이 있으며, 이 제3 성분이 Leontovich 경계 조건으로부터 나오고 제1 충전 단자 상의 상승된 진동 전하(Q_1)의 준정적 필드에 의해 펌핑되는 손실형 전도성 매체(203)에서의 방사상 전류 기여분이라는 것에 유의한다. 양 $Z_\rho = j\omega\mu_o/\gamma_e$ 가 손실형 전도성 매체의 방사상 임피던스(radial impedance)이고, 여기서 $\gamma_e = (j\omega\mu_1\sigma_1 - \omega^2\mu_1\epsilon_1)^{1/2}$ 이다.

[0394] 수학적 90 및 수학적 91에 의해 기재된 바와 같은 근위에서의 방사상 전류 및 원위에서의 방사상 전류를 나타내는 점근선들은 복소량들이다. 다양한 실시예들에 따르면, 물리적 표면 전류($J(\rho)$)는 크기 및 위상에서 전류

접근선들과 가능한 한 가깝게 매칭하도록 합성된다. 즉, 근위 $|J(\rho)|$ 는 $|J_1|$ 에 접할 것이고 원위 $|J(\rho)|$ 는 $|J_2|$ 에 접할 것이다. 또한, 다양한 실시예들에 따르면, $J(\rho)$ 의 위상은 근위에서의 J_1 의 위상으로부터 원위에서의 J_2 의 위상으로 전이해야만 한다.

[0395] 유도 표면파를 발진시키도록 전송 지점(site of transmission)에서의 유도 표면파 모드를 매칭시키기 위해, 원위에서의 표면 전류 $|J_2|$ 의 위상이 근위에서의 표면 전류 $|J_1|$ 의 위상과 $e^{-j\beta(\rho_2-\rho_1)}$ 에 대응하는 전파 위상 + 대략 45도 또는 225도의 상수만큼 상이해야만 한다. 이러한 이유는 $\sqrt{\gamma}$ 에 대한 2개의 근(root)이 하나는 $\pi/4$ 근방에 그리고 하나는 $5\pi/4$ 근방에 있기 때문이다. 적절하게 조절된 방사상 표면 전류는 수학식 92이다.

[0396] [수학식 92]

[0397]
$$J_\rho(\rho, \phi, 0) = \frac{I_o \gamma}{4} H_1^{(2)}(-j\gamma\rho)$$

[0398] 이것이 수학식 17과 부합한다는 것에 유의한다. Maxwell의 방정식들에 의해, 이러한 $J(\rho)$ 표면 전류는 수학식 93 내지 수학식 95에 부합하는 필드들을 자동으로 생성한다.

[0399] [수학식 93]

[0400]
$$H_\phi = \frac{-\gamma I_o}{4} e^{-u_2 z} H_1^{(2)}(-j\gamma\rho)$$

[0401] [수학식 94]

[0402]
$$E_\rho = \frac{-\gamma I_o}{4} \left(\frac{u_2}{j\omega\epsilon_o} \right) e^{-u_2 z} H_1^{(2)}(-j\gamma\rho)$$

[0403] [수학식 95]

[0404]
$$E_z = \frac{-\gamma I_o}{4} \left(\frac{-\gamma}{\omega\epsilon_o} \right) e^{-u_2 z} H_0^{(2)}(-j\gamma\rho)$$

[0405] 따라서, 매칭되어야 하는 유도 표면파 모드에 대한 원위에서의 표면 전류 $|J_2|$ 와 근위에서의 표면 전류 $|J_1|$ 사이의 위상차는, 수학식 1 내지 수학식 3과 부합하는, 수학식 93 내지 수학식 95 내의 Hankel 함수들의 특성들로 인한 것이다. 수학식 1 내지 수학식 6 및 수학식 17과 수학식 92 내지 수학식 95에 의해 표현되는 필드들이, 지상파 전파와 연관되어 있는 방사 필드들이 아닌, 손실형 계면에 속박된 전송 라인 모드의 특성을 갖는다는 것을 인식하는 것이 중요하다.

[0406] 주어진 위치에서 유도 표면 도파로 프로브(200e)의 주어진 설계에 대한 적절한 전압 크기들 및 위상들을 획득하기 위해, 반복적 접근법이 사용될 수 있다. 구체적으로는, 생성된 방사상 표면 전류 밀도를 결정하기 위해 단자들(T_1 및 T_2)에의 공급 전류들, 충전 단자들(T_1 및 T_2) 상의 전하들, 및 손실형 전도성 매체(203)에서의 그들의 이미지들을 고려하여, 유도 표면 도파로 프로브(200e)의 주어진 여기 및 구성의 분석이 수행될 수 있다. 이 프로세스는 주어진 유도 표면 도파로 프로브(200e)에 대한 최적의 구성 및 여기가 원하는 파라미터들에 기초하여 결정될 때까지 반복적으로 수행될 수 있다. 주어진 유도 표면 도파로 프로브(200e)가 최적 레벨에서 동작하는지 여부를 결정하는 데 도움을 주기 위해, 유도 필드 강도 곡선(103)(도 1)이 유도 표면 도파로 프로브(200e)의 위치에서의 영역 1의 전도율(σ_1) 및 영역 1의 유전율(ϵ_1)에 대한 값들에 기초하여 수학식 1 내지 수학식 12를 사용하여 생성될 수 있다. 이러한 유도 필드 강도 곡선(103)은, 최적의 전송이 달성되었는지를 결정하기 위해, 측정된 필드 강도들이 유도 필드 강도 곡선(103)에 의해 표시되는 크기들과 비교될 수 있도록 동작에 대한 벤치마크를 제공할 수 있다.

[0407] 최적화된 조건에 도달하기 위해, 유도 표면 도파로 프로브(200e)와 연관된 다양한 파라미터들이 조절될 수 있다. 유도 표면 도파로 프로브(200e)를 조절하기 위해 변화될 수 있는 하나의 파라미터는 손실형 전도성 매체(203)의 표면에 대한 충전 단자들(T_1 및/또는 T_2) 중 하나 또는 둘 다의 높이이다. 그에 부가하여, 충전 단자

(T_1)와 충전 단자(T_2) 사이의 거리 또는 간격이 또한 조절될 수 있다. 그렇게 할 때, 인지될 수 있는 바와 같이, 충전 단자들(T_1 및 T_2)과 손실형 전도성 매체(203) 사이의 상호 정전용량(C_M) 또는 임의의 속박 정전용량들을 최소화하거나 다른 방식으로 변경할 수 있다. 각자의 충전 단자들(T_1 및/또는 T_2)의 크기가 또한 조절될 수 있다. 충전 단자들(T_1 및/또는 T_2)의 크기를 변화시키는 것에 의해, 인지될 수 있는 바와 같이, 각자의 자기 정전용량들(C_1 및/또는 C_2) 및 상호 정전용량(C_M)을 변경할 것이다.

[0408] 게다가, 조절될 수 있는 다른 파라미터는 유도 표면 도파로 프로브(200e)와 연관된 공급 네트워크(209)이다. 이것은 공급 네트워크(209)를 구성하는 유도성 및/또는 용량성 리액턴스들의 크기를 조절하는 것에 의해 달성될 수 있다. 예를 들어, 이러한 유도성 리액턴스들이 코일들을 포함하는 경우, 이러한 코일들 상의 턴 수가 조절될 수 있다. 궁극적으로, 공급 네트워크(209)의 전기적 길이를 변경함으로써 충전 단자들(T_1 및 T_2) 상의 전압 크기들 및 위상들에 영향을 주기 위해 공급 네트워크(209)에 대한 조절들이 행해질 수 있다.

[0409] 인지될 수 있는 바와 같이, 다양한 조절들을 행하는 것에 의해 수행되는 전송의 반복들이 컴퓨터 모델들을 사용하는 것에 의해 또는 물리적 구조물들을 조절하는 것에 의해 구현될 수 있다는 것에 유의한다. 상기 조절들을 행하는 것에 의해, 앞서 기재된 수학적 90 및 수학적 91에 명시된 유도 표면과 모드의 동일한 전류들($J(\rho)$)을 근사화하는 대응하는 "근위" 표면 전류(J_1) 및 "원위" 표면 전류(J_2)를 생성할 수 있다. 그렇게 할 때, 결과적인 전자기 필드들이 손실형 전도성 매체(203)의 표면 상의 유도 표면과 모드에 실질적으로 또는 대략적으로 모드-매칭될 것이다.

[0410] 도 16의 예에 도시되어 있지 않지만, 유도 표면 도파로 프로브(200e)의 동작이 유도 표면 도파로 프로브(200)와 연관된 동작 조건들의 변동들에 맞춰 조절되도록 제어될 수 있다. 예를 들어, 도 12에 도시된 프로브 제어 시스템(230)은 유도 표면 도파로 프로브(200e)의 동작을 제어하기 위해 공급 네트워크(209) 및/또는 충전 단자들(T_1 및/또는 T_2)의 위치선정 및/또는 크기를 제어하는 데 사용될 수 있다. 동작 조건들은 손실형 전도성 매체(203)의 특성들(예컨대, 전도율(σ) 및 상대 유전율(ϵ_r))의 변동들, 필드 강도의 변동들 및/또는 유도 표면 도파로 프로브(200e)의 부하의 변동들을 포함할 수 있지만, 이들로 제한되지 않는다.

[0411] 이제 도 17을 참조하면, 여기서는 유도 표면 도파로 프로브(200f)라고 표기된, 도 16의 유도 표면 도파로 프로브(200e)의 일 예가 도시되어 있다. 유도 표면 도파로 프로브(200f)는 손실형 전도성 매체(203)(예컨대, 지구)에 의해 제공되는 평면에 실질적으로 수직인 수직 축(z)을 따라 위치되는 충전 단자들(T_1 및 T_2)을 포함한다. 제2 매체(206)는 손실형 전도성 매체(203) 위쪽에 있다. 충전 단자(T_1)는 자기 정전용량(C_1)을 갖고, 충전 단자(T_2)는 자기 정전용량(C_2)을 갖는다. 동작 동안, 임의의 주어진 순간에 충전 단자들(T_1 및 T_2)에 인가되는 전압들에 의존하는 전하(Q_1)와 전하(Q_2)가 충전 단자(T_1) 및 충전 단자(T_2)에, 각각, 부여된다. 충전 단자(T_1)와 충전 단자(T_2) 사이에 그들 사이의 거리에 의존하는 상호 정전용량(C_M)이 존재할 수 있다. 그에 부가하여, 손실형 전도성 매체(203)에 대한 각자의 충전 단자들(T_1 및 T_2)의 높이들에 의존하는 속박 정전용량들이 각자의 충전 단자들(T_1 및 T_2)과 손실형 전도성 매체(203) 사이에 존재할 수 있다.

[0412] 유도 표면 도파로 프로브(200f)는 충전 단자들(T_1 및 T_2)의 각자의 충전 단자들에 결합되는 한 쌍의 리드들을 갖는 코일(L_{1a})을 포함하는 유도성 임피던스를 포함하는 공급 네트워크(209)를 포함한다. 일 실시예에서, 코일(L_{1a})은 유도 표면 도파로 프로브(200f)의 동작 주파수에서의 파장의 절반(1/2)인 전기적 길이를 갖는 것으로 명시되어 있다.

[0413] 코일(L_{1a})의 전기적 길이가 동작 주파수에서의 파장의 대략 절반(1/2)으로서 명시되어 있지만, 코일(L_{1a})이 다른 값들의 전기적 길이를 갖는 것으로 명시될 수 있다는 것이 이해된다. 일 실시예에 따르면, 코일(L_{1a})이 동작 주파수에서의 파장의 대략 절반의 전기적 길이를 갖는다는 사실은 충전 단자들(T_1 및 T_2)에 최대 전압차가 생성된다는 점에서 장점을 제공한다. 그럼에도 불구하고, 유도 표면과 모드의 최적의 여기를 달성하기 위해 유도 표면 도파로 프로브(200f)를 조절할 때 코일(L_{1a})의 길이 또는 직경이 증가 또는 감소될 수 있다. 코일 길이의 조절은 코일의 한쪽 단부 또는 양쪽 단부들에 위치된 탭들에 의해 제공될 수 있다. 다른 실시예들에서, 유도성

임피던스가 유도 표면 도파로 프로브(200f)의 동작 주파수에서의 파장의 1/2보다 상당히 더 작거나 더 큰 전기적 길이를 갖는 것으로 명시되어 있을 수 있다.

[0414] 여기 소스(212)가 자기 결합에 의해 공급 네트워크(209)에 결합될 수 있다. 구체적으로는, 여기 소스(212)가 코일(L_{1a})에 유도적으로 결합되는 코일(L_p)에 결합된다. 이것은, 인지될 수 있는 바와 같이, 링크 결합, 탭을 갖는 코일(tapped coil), 가변 리액턴스, 또는 다른 결합 접근법에 의해 행해질 수 있다. 이를 위해, 인지될 수 있는 바와 같이, 코일(L_p)은 1차측(primary)으로서 기능하고, 코일(L_{1a})은 2차측(secondary)으로서 기능한다.

[0415] 원하는 유도 표면파의 전송을 위해 유도 표면 도파로 프로브(200f)를 조절하기 위해, 손실형 전도성 매체(203)에 대한 그리고 서로에 대한 각자의 충전 단자들(T₁ 및 T₂)의 높이들이 변경될 수 있다. 또한, 충전 단자들(T₁ 및 T₂)의 크기들이 변경될 수 있다. 그에 부가하여, 턴들을 부가 또는 제거하는 것에 의해 또는 코일(L_{1a})의 어떤 다른 치수를 변화시키는 것에 의해 코일(L_{1a})의 크기가 변경될 수 있다. 코일(L_{1a})은 또한 도 17에 도시된 바와 같이 전기적 길이를 조절하기 위한 하나 이상의 탭을 포함할 수 있다. 어느 하나의 충전 단자(T₁ 또는 T₂)에 연결된 탭의 위치가 또한 조절될 수 있다.

[0416] 다음에 도 18a, 도 18b, 도 18c 및 도 19를 참조하면, 무선 전력 전달 시스템들에서 표면 유도파들을 사용하기 위한 일반화된 수신 회로들의 예들이 도시되어 있다. 도 18a, 도 18b 및 도 18c는, 각각, 선형 프로브(303) 및 튜닝형 공진기(tuned resonator)(306)를 포함한다. 도 19는 본 개시내용의 다양한 실시예들에 따른 자기 코일(309)이다. 다양한 실시예들에 따르면, 선형 프로브(303), 튜닝형 공진기(306), 및 자기 코일(309) 각각은 다양한 실시예들에 따라 손실형 전도성 매체(203)의 표면 상에서 유도 표면파의 형태로 전송되는 전력을 수신하는데 이용될 수 있다. 앞서 언급된 바와 같이, 일 실시예에서, 손실형 전도성 매체(203)는 지상 매체(또는 지구)를 포함한다.

[0417] 특히 도 18a를 참조하면, 선형 프로브(303)의 출력 단자들(312)에서의 개방 회로 단자 전압은 선형 프로브(303)의 유효 높이에 의존한다. 이 때문에, 단자 지점 전압(terminal point voltage)은 수학식 96으로서 계산될 수 있고,

[0418] [수학식 96]

[0419]
$$V_T = \int_0^{h_e} E_{inc} \cdot dl$$

[0420] 여기서, E_{inc}는 미터 당 볼트 단위의 선형 프로브(303) 상에 유도되는 입사 전기 필드의 강도이고, dl은 선형 프로브(303)의 방향을 따른 적분 요소이며, h_e는 선형 프로브(303)의 유효 높이이다. 전기 부하(315)가 임피던스 매칭 네트워크(318)를 통해 출력 단자들(312)에 결합된다.

[0421] 선형 프로브(303)에 앞서 기술된 바와 같은 유도 표면파가 인가될 때, 출력 단자들(312)에 걸쳐 전압이 발생하며, 이 전압이 경우에 따라 켈레 임피던스 매칭 네트워크(318)를 통해 전기 부하(315)에 인가될 수 있다. 전기 부하(315)로의 전력의 흐름을 용이하게 하기 위해, 전기 부하(315)는 이하에서 기술될 것인 바와 같이 선형 프로브(303)에 실질적으로 임피던스 매칭되어야만 한다.

[0422] 도 18b를 참조하면, 유도 표면파의 파 경사와 동일한 위상 시프트를 갖는 접지 전류 여기 코일(ground current excited coil)(306a)은 손실형 전도성 매체(203) 위쪽에 상승되어 있는(또는 부유되어 있는) 충전 단자(T_R)를 포함한다. 충전 단자(T_R)는 자기 정전용량(C_R)을 갖는다. 그에 부가하여, 손실형 전도성 매체(203)로부터의 충전 단자(T_R)의 높이에 따라 충전 단자(T_R)와 손실형 전도성 매체(203) 사이에 속박 정전용량(도시되지 않음)이 또한 존재할 수 있다. 속박 정전용량은 실행가능한 한 많이 최소화되는 것이 바람직하지만, 이것이 모든 경우에서 전적으로 필요한 것은 아닐 수 있다.

[0423] 튜닝형 공진기(306a)는 위상 시프트(Φ)를 갖는 코일(L_R)을 포함하는 수신기 네트워크를 또한 포함한다. 코일(L_R)의 한쪽 단부는 충전 단자(T_R)에 결합되고, 코일(L_R)의 다른 쪽 단부는 손실형 전도성 매체(203)에 결합된다. 수신기 네트워크는 코일(L_R)을 충전 단자(T_R)에 결합시키는 수직 공급 라인 전도체를 포함할 수 있다. 이를 위해, 코일(L_R)(튜닝형 공진기(L_R-C_R)라고도 지칭될 수 있음)은 직렬-조절형 공진기(series-

adjusted resonator)를 충전 단자(C_R)로서 포함하며, 코일(L_R)은 직렬로 배치된다. 구조물의 위상(Φ)이 파 경사각(Ψ)과 실질적으로 동일하게 되도록 충전 단자(T_R)의 크기 및/또는 높이를 변화시키는 것 및/또는 코일(L_R)의 크기를 조절하는 것에 의해 코일(L_R)의 위상 지연이 조절될 수 있다. 수직 공급 라인의 위상 지연이 또한, 예컨대, 전도체의 길이를 변화시키는 것에 의해 조절될 수 있다.

[0424] 예를 들어, 자기 정전용량(C_R)에 의해 제공되는 리액턴스는 $1/j\omega C_R$ 로서 계산된다. 구조물(306a)의 총 정전용량이 또한 충전 단자(T_R)와 손실형 전도성 매체(203) 사이의 정전용량을 포함할 수 있고, 여기서 구조물(306a)의 총 정전용량은, 인지될 수 있는 바와 같이, 자기 정전용량(C_R) 및 임의의 속박 정전용량 둘 다로부터 계산될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 임의의 속박 정전용량을 실질적으로 감소시키거나 제거하기 위해 충전 단자(T_R)가 어떤 높이로 상승될 수 있다. 속박 정전용량의 존재는, 이전에 논의된 바와 같이, 충전 단자(T_R)와 손실형 전도성 매체(203) 사이의 정전용량 측정들로부터 결정될 수 있다.

[0425] 이산 요소 코일(discrete-element coil)(L_R)에 의해 제공되는 유도성 리액턴스는 $j\omega L$ 로서 계산될 수 있고, 여기서 L 은 코일(L_R)의 집중 요소 인덕턴스(lumped-element inductance)이다. 코일(L_R)이 분산 요소(distributed element)인 경우, 그의 등가 단자 지점 유도성 리액턴스는 종래의 접근법들에 의해 결정될 수 있다. 구조물(306a)을 튜닝하기 위해, 동작 주파수에서 표면 도파로에 모드-매칭시킬 목적으로 위상 지연이 파 경사와 동일하도록 조절을 수행할 것이다. 이 조건 하에서, 수신 구조물이 표면 도파로와 "모드-매칭되는" 것으로 간주될 수 있다. 구조물 주변의 변압기 링크(transformer link) 및/또는 임피던스 매칭 네트워크(324)가 부하에 전력을 결합시키기 위해 프로브와 전기 부하(327) 사이에 삽입될 수 있다. 임피던스 매칭 네트워크(324)를 프로브 단자들(321)과 전기 부하(327) 사이에 삽입하는 것은 전기 부하(327)로의 최대 전력 전송을 위한 켈레 매칭 조건(conjugate-match condition)을 달성할 수 있다.

[0426] 동작 주파수들에서 표면 전류들이 존재할 때, 전력이 표면 유도파부터 전기 부하(327)에게 전달될 것이다. 이를 위해, 전기 부하(327)가 자기 결합(magnetic coupling), 용량성 결합(capacitive coupling), 또는 전도성(직접 탭(direct tap)) 결합을 통해 구조물(306a)에 결합될 수 있다. 결합 네트워크의 요소들은, 인지될 수 있는 바와 같이, 집중 컴포넌트(lumped component)들 또는 분산 요소들일 수 있다.

[0427] 도 18b에 도시된 실시예에서, 변압기 1차측으로서 기능하는 코일(L_R)에 대해 코일(L_S)이 2차측으로서 배치되는 자기 결합이 이용된다. 인지될 수 있는 바와 같이, 코일을 동일한 코어 구조물 주위에 기하학적으로 권취하고 결합 자속(coupled magnetic flux)을 조절하는 것에 의해 코일(L_S)이 코일(L_R)에 링크-결합(link-couple)될 수 있다. 그에 부가하여, 수신 구조물(306a)이 직렬 튜닝형 공진기(series-tuned resonator)를 포함하지만, 병렬 튜닝형 공진기(parallel-tuned resonator) 또는 심지어는 적절한 위상 지연의 분산-요소 공진기(distributed-element resonator)가 또한 사용될 수 있다.

[0428] 전자기 필드 속에 놓여 있는 수신 구조물이 필드들로부터의 에너지를 결합시킬 수 있지만, 이 결합을 최대화하는 것에 의해 편파 매칭된 구조물(polarization-matched structure)들이 최상으로 작동할 수 있으며, 도파로 모드들에의 프로브 결합(probe-coupling)에 대한 종래의 규칙들이 준수되어야만 한다는 것이 인지될 수 있다. 예를 들어, TE_{20} (횡방향 전기 모드(transverse electric mode)) 도파로 프로브는 TE_{20} 모드에서 여기된 종래의 도파로로부터 에너지를 추출하는 데 최적일 수 있다. 이와 유사하게, 이 경우들에서, 모드-매칭되고 위상-매칭된 수신 구조물은 표면 유도파부터의 전력을 결합시키도록 최적화될 수 있다. 손실형 전도성 매체(203)의 표면 상에 유도 표면 도파로 프로브(200)에 의해 여기되는 유도 표면파는 개방형 도파로(open waveguide)의 도파로 모드인 것으로 간주될 수 있다. 도파로 손실들을 제외하고, 소스 에너지가 완전히 회수될 수 있다. 유용한 수신 구조물들은 E-필드 결합되거나, H-필드 결합되거나, 표면-전류 여기될 수 있다.

[0429] 수신 구조물이 수신 구조물 근방에 있는 손실형 전도성 매체(203)의 국지적 특성들에 기초하여 유도 표면파와의 결합을 증가 또는 최대화하도록 조절될 수 있다. 이것을 달성하기 위해, 수신 구조물의 위상 지연(Φ)이 수신 구조물에서의 표면 진행파의 파 경사각(Ψ)과 매칭하도록 조절될 수 있다. 적절하게 구성된 경우, 수신 구조물은 복소 깊이 $z = -d/2$ 에 있는 완전 전도성 이미지 접지 평면과 관련하여 공진하도록 튜닝될 수 있다.

[0430] 예를 들어, 코일(L_R) 및 코일(L_R)과 충전 단자(T_R) 사이에 연결된 수직 공급 라인을 포함하는, 도 18b의 튜닝형 공진기(306a)를 포함하는 수신 구조물을 고려한다. 충전 단자(T_R)가 손실형 전도성 매체(203)로부터 어떤 정의

된 높이에 위치된 경우, 코일(L_R) 및 수직 공급 라인의 총 위상 시프트(Φ)가 튜닝형 공진기(306a)의 위치에서의 파 경사각(Ψ)과 매칭될 수 있다. 수학식 22로부터, 파 경사가 점근적으로 수학식 97로 되는 것을 알 수 있고,

[0431] [수학식 97]

$$W = |W|e^{j\Psi} = \frac{E_\rho}{E_z} \xrightarrow{\rho \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r - j\frac{\sigma_1}{\omega\epsilon_0}}}$$

여기서 ϵ_r 은 상대 유전율을 포함하고, σ_1 은 수신 구조물의 위치에서의 손실형 전도성 매체(203)의 전도율이며, ϵ_0 는 자유 공간의 유전율이고, $\omega = 2\pi f$ 이며, 여기서 f 는 여기 주파수이다. 따라서, 파 경사각(Ψ)은 수학식 97로부터 결정될 수 있다.

튜닝형 공진기(306a)의 총 위상 시프트($\Phi = \Theta_c + \Theta_y$)는 코일(L_R)을 통한 위상 지연(Θ_c)과 수직 공급 라인의 위상 지연(Θ_y) 둘 다를 포함한다. 수직 공급 라인의 전도체 길이(l_w)를 따른 공간적 위상 지연은 $\Theta_y = \beta_w l_w$ 에 의해 주어질 수 있고, 여기서 β_w 는 수직 공급 라인 전도체에 대한 전파 위상 상수이다. 코일(또는 나선형 지연 라인)로 인한 위상 지연은, 물리적 길이가 l_c 이고 전파 인자가 수학식 98인 경우, $\Theta_c = \beta_p l_c$ 이며,

[0435] [수학식 98]

$$\beta_p = \frac{2\pi}{\lambda_p} = \frac{2\pi}{v_f \lambda_0}$$

여기서 v_f 는 구조물 상의 속도 인자이고, λ_0 는 공급된 주파수에서의 파장이며, λ_p 는 속도 인자 v_f 로부터 얻어지는 전파 파장이다. 위상 시프트(Φ)를 파 경사각(Ψ)에 매칭시키기 위해 위상 지연들($\Theta_c + \Theta_y$) 중 하나 또는 둘 다가 조절될 수 있다. 예를 들어, 총 위상 시프트를 파 경사각에 매칭시키도록($\Phi = \Psi$) 코일 위상 지연(Θ_c)을 조절하기 위해 도 18b의 코일(L_R) 상에서의 탭 위치가 조절될 수 있다. 예를 들어, 코일의 일부분이 도 18b에 예시되는 바와 같이 탭 연결에 의해 바이패스(bypass)될 수 있다. 수직 공급 라인 전도체가 또한 탭을 통해 코일(L_R)에 연결될 수 있고, 코일 상에서의 탭의 위치가 총 위상 시프트를 파 경사각에 매칭시키도록 조절될 수 있다.

튜닝형 공진기(306a)의 위상 지연(Φ)이 조절되었으면, 충전 단자(T_R)의 임피던스가 복소 깊이($z = -d/2$)에 있는 완전 전도성 이미지 접지 평면과 관련하여 공진으로 튜닝되도록 조절될 수 있다. 이것은 코일(L_R) 및 수직 공급 라인의 진행과 위상 지연들을 변화시키지 않으면서 충전 단자(T_1)의 정전용량을 조절하는 것에 의해 달성될 수 있다. 이 조절들은 도 9a 및 도 9b와 관련하여 기술된 것들과 유사하다.

손실형 전도성 매체(203) 안쪽으로 복소 이미지 평면까지 "내려다볼 때" 보이는 임피던스는 수학식 99에 의해 주어지며:

[0440] [수학식 99]

$$Z_{in} = R_{in} + jX_{in} = Z_o \tanh(j\beta_o(d/2))$$

여기서 $\beta_o = \omega\sqrt{\mu_o\epsilon_o}$ 이다. 지구 위쪽에 있는 수직 편파 소스들에 대하여, 복소 이미지 평면의 깊이는 수학식 100에 의해 주어질 수 있고:

[0443] [수학식 100]

$$d/2 \approx 1/\sqrt{j\omega\mu_1\sigma_1 - \omega^2\mu_1\epsilon_1}$$

여기서 μ_1 은 손실형 전도성 매체(203)의 투자율이고, $\epsilon_1 = \epsilon_r\epsilon_o$ 이다.

[0446] 튜닝형 공진기(306a)의 베이스에서, 수신 구조물 안쪽으로 "올려다볼 때" 보이는 임피던스는 도 9a에 예시된 바와 같이 $Z_{\uparrow} = Z_{base}$ 이다. 단자 임피던스가 수학식 101:

[0447] [수학식 101]

$$[0448] Z_R = \frac{1}{j\omega C_R}$$

[0449] - C_R 은 충전 단자(T_R)의 자기 정전용량임 - 인 경우, 튜닝형 공진기(306a)의 수직 공급 라인 전도체 안쪽으로 "올려다볼 때" 보이는 임피던스는 수학식 102에 의해 주어지고:

[0450] [수학식 102]

$$[0451] Z_2 = Z_W \frac{Z_R + Z_W \tanh(j\beta_W h_W)}{Z_W + Z_R \tanh(j\beta_W h_W)} = Z_W \frac{Z_R + Z_W \tanh(j\theta_y)}{Z_W + Z_R \tanh(j\theta_y)}$$

[0452] 튜닝형 공진기(306a)의 코일(L_R) 안쪽으로 "올려다볼 때" 보이는 임피던스는 수학식 103에 의해 주어진다:

[0453] [수학식 103]

$$[0454] Z_{base} = R_{base} + jX_{base} = Z_R \frac{Z_2 + Z_R \tanh(j\beta_p H)}{Z_R + Z_2 \tanh(j\beta_p H)} = Z_c \frac{Z_2 + Z_R \tanh(j\theta_c)}{Z_R + Z_2 \tanh(j\theta_c)}$$

[0455] 손실형 전도성 매체(203) 안쪽으로 "내려다볼 때" 보이는 무효 성분(X_{in})을 튜닝형 공진기(306a) 안쪽으로 "올려다볼 때" 보이는 무효 성분(X_{base})과 매칭시키는 것에 의해, 유도 표면 도파로 모드에의 결합이 최대화될 수 있다.

[0456] 다음에 도 18c를 참조하면, 수신 구조물의 상단에 충전 단자(T_R)를 포함하지 않는 튜닝형 공진기(306b)의 일 예가 도시되어 있다. 이 실시예에서, 튜닝형 공진기(306b)는 코일(L_R)과 충전 단자(T_R) 사이에 결합되는 수직 공급 라인을 포함하지 않는다. 따라서, 튜닝형 공진기(306b)의 총 위상 시프트(Φ)는 코일(L_R)을 통한 위상 지연(θ_c)만을 포함한다. 도 18b의 튜닝형 공진기(306a)에서와 같이, 코일 위상 지연(θ_c)이 수학식 97로부터 결정된 파 경사각(Ψ)과 매칭하도록 - 그 결과 $\Phi = \Psi$ 임 - 조절될 수 있다. 수신 구조물이 표면 도파로 모드에 결합된 경우에 전력 추출이 가능하지만, 충전 단자(T_R)에 의해 제공되는 가변 무효 부하(variable reactive load) 없이 유도 표면파와의 결합을 최대화하도록 수신 구조물을 조절하는 것은 어렵다.

[0457] 도 18d를 참조하면, 손실형 전도성 매체(203)의 표면 상의 유도 표면 도파로 모드에 실질적으로 모드-매칭되도록 수신 구조물을 조절하는 것의 일 예를 예시하는 플로차트(180)가 도시되어 있다. 181에서 시작하여, 수신 구조물이 (예컨대, 도 18b의 튜닝형 공진기(306a)의) 충전 단자(T_R)를 포함하는 경우, 184에서 충전 단자(T_R)가 손실형 전도성 매체(203)로부터 어떤 정의된 높이에 위치된다. 표면 유도파가 유도 표면 도파로 프로브(200)에 의해 확립되어 있기 때문에, 충전 단자(T_R)의 물리적 높이(h_p)는 유효 높이보다 아래에 있을 수 있다. 이 물리적 높이는 충전 단자(T_R) 상의 속박 전하를 감소시키거나 최대화하도록 선택될 수 있다(예컨대, 충전 단자의 구체 직경의 4배). 수신 구조물이 (예컨대, 도 18c의 튜닝형 공진기(306b)의) 충전 단자(T_R)를 포함하지 않는 경우, 흐름은 187로 진행된다.

[0458] 187에서, 수신 구조물의 전기적 위상 지연(Φ)이 손실형 전도성 매체(203)의 국지적 특성들에 의해 정의되는 복소 파 경사각(Ψ)에 매칭된다. Φ 를 파 경사(W)의 각도(Ψ)와 동일하도록 하기 위해 나선형 코일의 위상 지연(θ_c) 및/또는 수직 공급 라인의 위상 지연(θ_y)이 조절될 수 있다. 파 경사각(Ψ)이 수학식 86으로부터 결정될 수 있다. 전기적 위상(Φ)이 이어서 파 경사각에 매칭될 수 있다. 예를 들어, 코일(L_R)의 기하학적 파라미터들 및/또는 수직 공급 라인 전도체의 길이(또는 높이)를 변화시키는 것에 의해 전기적 위상 지연($\Phi = \theta_c + \theta_y$)이 조절될 수 있다.

[0459] 다음에 190에서, 충전 단자(T_R)의 부하 임피던스가 튜닝형 공진기(306a)의 등가 이미지 평면 모델을 공진시키도록 튜닝될 수 있다. 수신 구조물로부터의 전도성 이미지 접지 평면(139)(도 9a)의 깊이($d/2$)는 수학식 100 및, 국지적으로 측정될 수 있는, 수신 구조물에 있는 손실형 전도성 매체(203)(예컨대, 지구)의 값들을 사용하여 결정될 수 있다. 그 복소 깊이를 사용하여, 손실형 전도성 매체(203)의 물리적 경계(136)와 이미지 접지 평면(139)(도 9a) 사이의 위상 시프트(θ_d)는 $\theta_d = \beta \cdot d/2$ 를 사용하여 결정될 수 있다. 손실형 전도성 매체(203) 안쪽으로 "내려다볼 때" 보이는 임피던스(Z_{in})가 이어서 수학식 99를 사용하여 결정될 수 있다. 유도 표면파들과의 결합을 최대화하기 위해 이러한 공진 관계가 고려될 수 있다.

[0460] 코일(L_R)의 조절된 파라미터들 및 수직 공급 라인 전도체의 길이에 기초하여, 코일(L_R) 및 수직 공급 라인의 속도 인자, 위상 지연, 및 임피던스가 결정될 수 있다. 그에 추가하여, 충전 단자(T_R)의 자기 정전용량(C_R)이, 예컨대, 수학식 24를 사용하여 결정될 수 있다. 코일(L_R)의 전파 인자(β_p)는 수학식 98를 사용하여 결정될 수 있고, 수직 공급 라인에 대한 전파 위상 상수(β_w)는 수학식 49를 사용하여 결정될 수 있다. 코일(L_R) 및 수직 공급 라인의 결정된 값들 및 자기 정전용량을 사용하여, 코일(L_R) 안쪽으로 "올려다볼 때" 보이는 튜닝형 공진기(306a)의 임피던스(Z_{base})가 수학식 101, 수학식 102, 및 수학식 103을 사용하여 결정될 수 있다.

[0461] 도 9a의 등가 이미지 평면 모델이 또한 도 18b의 튜닝형 공진기(306a)에 적용된다. Z_{base} 의 리액턴스 성분 X_{base} 가 Z_{in} 의 X_{in} 의 리액턴스 성분을 소거하도록, 또는 $X_{base} + X_{in} = 0$ 이도록 충전 단자(T_R)의 부하 임피던스(Z_R)를 조절하는 것에 의해, 튜닝형 공진기(306a)가 복소 이미지 평면과 관련하여 공진으로 튜닝될 수 있다. 따라서, 튜닝형 공진기(306a)의 코일 안쪽으로 "올려다볼 때의" 물리적 경계(136)(도 9a)에서의 임피던스는 손실형 전도성 매체(203) 안쪽으로 "내려다볼 때의" 물리적 경계(136)에서의 임피던스의 켤레이다. 충전 단자(T_R)에게 보이는 전기적 위상 지연($\Phi = \theta_c + \theta_y$)을 변화시키지 않으면서 충전 단자(T_R)의 정전용량(C_R)을 변화시킴으로써 부하 임피던스(Z_R)가 조절될 수 있다. 전도성 이미지 접지 평면(139)과 관련하여 등가 이미지 평면 모델을 공진시키도록 부하 임피던스(Z_R)를 튜닝하기 위해 반복적 접근법이 취해질 수 있다. 이러한 방식으로, 전기 필드를 손실형 전도성 매체(203)(예컨대, 지구)의 표면을 따른 유도 표면 도파로 모드에 결합시키는 것이 항상 및/또는 최대화될 수 있다.

[0462] 도 19를 참조하면, 자기 코일(309)은 임피던스 매칭 네트워크(333)를 통해 전기 부하(336)에 결합되는 수신 회로를 포함한다. 유도 표면파로부터의 전력의 수신 및/또는 추출을 용이하게 하기 위해, 유도 표면파의 자속(H_ϕ)이 자기 코일(309)을 통과하도록 자기 코일(309)이 위치될 수 있으며, 그에 의해 자기 코일(309)에 전류를 유도(induce)하고 그의 출력 단자들(330)에 단자 지점 전압을 생성한다. 단일 턴 코일(single turn coil)에 결합되는 유도 표면파의 자속은 수학식 104에 의해 표현되고,

[0463] [수학식 104]

$$\mathcal{F} = \iint_{A_{CS}} \mu_r \mu_o \vec{H} \cdot \hat{n} dA$$

[0464]

[0465] 여기서 $\mathcal{F}$ 는 결합 자속이고, μ_r 은 자기 코일(309)의 코어의 유효 상대 투자율이며, μ_o 는 자유 공간의 투자율이고, $\vec{H}$ 는 입사 자기 필드 강도 벡터이며, $\hat{n}$ 은 턴들의 단면 영역(cross-sectional area)에 수직인 단위 벡터이고, A_{CS} 는 각각의 루프에 의해 둘러싸인 영역이다. 자기 코일(309)의 단면 영역에 걸쳐 균일한 입사 자기 필드에서의 최대 결합을 위해 배향된 N-턴(N-turn) 자기 코일(309)에 대해, 자기 코일(309)의 출력 단자들(330)에 나타나는 개방-회로 유도 전압은 수학식 105이고,

[0466] [수학식 105]

$$V = -N \frac{d\mathcal{F}}{dt} \approx -j\omega \mu_r \mu_o N H A_{CS}$$

[0467]

[0468] 여기서 변수들은 앞서 정의되어 있다. 자기 코일(309)은, 경우에 따라, 분산형 공진기로서 또는 그의 출력 단자들(330) 사이에 있는 외부 커패시터에 의해 유도 표면파 주파수로 튜닝될 수 있고, 이어서 켤레 임피던스 매

칭 네트워크(333)를 통해 외부 전기 부하(336)에 임피던스 매칭될 수 있다.

- [0469] 자기 코일(309) 및 전기 부하(336)에 의해 제공되는 결과적인 회로가, 임피던스 매칭 네트워크(333)를 통해, 적절하게 조절되어 켈레 임피던스 매칭된다고 가정하면, 자기 코일(309)에 유도되는 전류는 전기 부하(336)에 최적으로 전력을 공급하는 데 이용될 수 있다. 자기 코일(309)에 의해 제공되는 수신 회로는 접지에 물리적으로 연결될 필요가 없다는 점에서 장점을 제공한다.
- [0470] 도 18a, 도 18b, 도 18c 및 도 19를 참조하면, 선형 프로브(303), 모드-매칭된 구조물(306), 및 자기 코일(309)에 의해 제공되는 수신 회로들 각각은 앞서 기술된 유도 표면 도파로 프로브들(200)의 실시예들 중 임의의 것으로부터 전송되는 전력을 수신하는 것을 용이하게 한다. 이를 위해, 수신된 에너지는, 인지될 수 있는 바와 같이, 켈레 매칭 네트워크를 통해 전기 부하(315/327/336)에게 전력을 공급하는 데 사용될 수 있다. 이것은 방사 전자기 필드의 형태로 전송된, 수신기에서 수신될 수 있는 신호들과 대조적이다. 이러한 신호들은 매우 낮은 가용 전력을 갖고, 이러한 신호들의 수신기들은 송신기들에 대해 부하로 작용하지 않는다.
- [0471] 선형 프로브(303), 모드-매칭된 구조물(306), 및 자기 코일(309)에 의해 제공되는 수신 회로들이 유도 표면 도파로 프로브(200)에 인가되는 여기 소스(212)(예컨대, 도 3, 도 12 및 도 16)에 대해 부하로 작용할 것이고, 그에 의해 이러한 수신 회로들에 인가되는 유도 표면파를 생성하는 것이 또한 앞서 기술된 유도 표면 도파로 프로브들(200)을 사용하여 생성되는 본 유도 표면파들의 특징이다. 이것은 앞서 기술된 주어진 유도 표면 도파로 프로브(200)에 의해 생성되는 유도 표면파가 전송 라인 모드를 포함한다는 사실을 반영한다. 이와 달리, 방사 전자기파를 생성하는 방사 안테나를 구동하는 전원에 대해서는, 이용되는 수신기들의 개수에 관계없이, 수신기들이 부하로 작용하지 않는다.
- [0472] 따라서, 선형 프로브(303) 형태의 하나 이상의 수신 회로 및 하나 이상의 유도 표면 도파로 프로브(200)와 함께, 튜닝형 모드-매칭된 구조물(306) 및/또는 자기 코일(309)은 무선 분배 시스템(wireless distribution system)을 구성할 수 있다. 앞서 기재된 바와 같은 유도 표면 도파로 프로브(200)를 사용하는 유도 표면파의 전송의 거리가 주파수에 의존하는 경우, 무선 전력 분배가 넓은 영역들에 걸쳐 그리고 심지어 전 세계적으로 달성될 수 있는 것이 가능하다.
- [0473] 오늘날 광범위하게 연구되는 종래의 무선 전력 전송/분배 시스템들은 방사 필드들로부터의 "에너지 하베스팅(energy harvesting)" 그리고 또한 유도성 또는 리액티브 근거리 필드(near-field)들에의 센서 결합을 포함한다. 이와 달리, 본 무선 전력 시스템은, 인터셉트되지 않으면, 영원히 손실되는 방사의 형태로 전력을 낭비하지 않는다. 여기 개시되는 무선 전력 시스템은 종래의 상호 리액턴스 결합 근거리 필드 시스템(mutual-reactance coupled near-field system)들에서와 같이 극히 짧은 범위들로 제한되지도 않는다. 본원에 개시되는 무선 전력 시스템은 신규의 표면 유도 전송 라인 모드에 프로브 결합(probe-couple)하며, 이는 도파로에 의해 부하에 또는 멀리 떨어진 발전기에 직접 결선된 부하에 전력을 전달하는 것과 등가이다. 전송 필드 강도를 유지하는 데 요구된 전력 및, 극히 낮은 주파수들에서는 60 Hz에서의 종래의 고압 전력 라인들에서의 전송 손실들에 비해 사소한, 표면 도파로에서 소실되는 전력을 제외하고는, 발전기 전력 전부가 원하는 전기 부하로만 간다. 전기 부하 수요(electrical load demand)가 종료될 때, 소스 전력 생성(source power generation)은 비교적 무부하(idle)이다.
- [0474] 다음으로 도 20a 내지 도 20e를 참조하면, 다음의 설명에 대한 참조로 사용되는 다양한 도식 기호들의 예들이 도시되어 있다. 특히 도 20a를 참조하면, 유도 표면 도파로 프로브들(200a, 200b, 200c, 200e, 200d 또는 200f) 중 임의의 하나 또는 그 임의의 변형들을 나타내는 기호가 도시되어 있다. 이하의 도면들과 설명에서, 이 기호의 서술은 유도 표면 도파로 프로브(P)로서 언급될 것이다. 이하의 설명에서 간결성을 위해, 유도 표면 도파로 프로브(P)에 대한 임의의 언급은 유도 표면 도파로 프로브들(200a, 200b, 200c, 200e, 200d 또는 200f) 중 임의의 하나 또는 그 변형들에 대한 언급이다.
- [0475] 유사하게, 도 20b를 참조하면, 선형 프로브(303)(도 18a), 튜닝형 공진기(306)(도 18b 및 도 18c) 또는 자기 코일(309)(도 19) 중 임의의 하나를 포함할 수 있는 유도 표면파 수신 구조물을 나타내는 기호가 도시되어 있다. 이하의 도면들과 설명에서, 이 기호의 서술은 유도 표면파 수신 구조물(R)로서 언급될 것이다. 이하의 설명의 간결성을 위해, 유도 표면파 수신 구조물(R)에 대한 임의의 언급은 선형 프로브(303), 튜닝형 공진기(306) 또는 자기 코일(309) 중 임의의 하나 또는 그 변형들에 대한 언급이다.
- [0476] 또한, 도 20c를 참조하면, 선형 프로브(303)(도 18a)를 특정하게 나타내는 기호가 도시되어 있다. 이하의 도면들과 설명에서, 이 기호의 서술은 유도 표면파 수신 구조물(R_p)로서 언급될 것이다. 이하의 설명의 간결성을

위해, 유도 표면과 수신 구조물(R_p)에 대한 임의의 언급은 선형 프로브(303) 또는 그 변형들에 대한 언급이다.

[0477] 또한, 도 20d를 참조하면, 튜닝형 공진기(306)(도 18b 및 도 18c)를 특정하게 나타내는 기호가 도시되어 있다. 이하의 도면들 및 설명에서, 이 기호의 서술은 유도 표면과 수신 구조물(R_R)로서 언급될 것이다. 이하의 설명의 간결성을 위해, 유도 표면과 수신 구조물(R_R)에 대한 임의의 언급은 튜닝형 공진기(306) 또는 그 변형들에 대한 언급이다.

[0478] 또한, 도 20e를 참조하면, 자기 코일(309)(도 19)을 특정하게 나타내는 기호가 도시되어 있다. 이하의 도면들 및 설명에서, 이 기호의 서술은 유도 표면과 수신 구조물(R_M)로서 언급될 것이다. 이하의 설명의 간결성을 위해, 유도 표면과 수신 구조물(R_M)에 대한 임의의 언급은 자기 코일(309) 또는 그 변형들에 대한 언급이다.

[0479] 예시적인 동작에서, 전력 서비스 제공자는 유도 표면과 수신 장비를 유도 표면과 서비스의 가입자에게 팔거나 임대할 수 있다. 유도 표면과 처리하고 보조 서비스들(예를 들어, 인증 서비스들)을 제공할 때 사용하기 위한 보조 컴퓨팅 디바이스와 같은 그러한 유도 표면과 수신 장비는 전술한 바와 같이 유도 표면 도파로 프로브들(P)과 함께 동작하도록 구성될 수 있다. 이에 따라, 유도 표면과 서비스의 현재 가입자들이 아닌 사람들과 같은 비허가 사용자에게 대해 유도 표면과 수신 장비의 기능성을 제한하는 것이 바람직할 수 있다. 예를 들어, 유도 표면과 수신 장비의 비허가된 판매 또는 유도 표면과 수신 장비의 도난은 전력 서비스 제공자에 대한 배상 없이 전력의 소비로부터 이익을 받으려고 하는 사람들에게 의해 시도될 수 있다. 따라서, 본 개시내용의 실시예들은 유도 표면과 수신 장비의 기능을 비허가된 사용자에게 제한할 수 있다.

[0480] 도 21을 참조하면, 여기 소스(212)에 결합된 변조 회로 또는 애플리케이션 모듈(2110)을 포함하여, 도 14에 나타낸 것과 같은, 유도 표면 도파로 프로브(2100)의 일 예의 그래픽 표현이 도시되어 있다. 유도 표면 도파로 프로브(2100)는 본 개시내용의 다양한 실시예들을 예시하기 위한 일 예로서 도시된다는 점 및 본 명세서에 설명되는 유도 표면 도파로 프로브들의 다른 실시예들이 사용될 수 있다는 점이 이해된다.

[0481] 다양한 실시예들에서, 암호화된 또는 암호화되지 않은 유효 키 코드 데이터(2130)는 프로브(2100)에 결합된 유도 표면과 제어기 디바이스(2120)에 의해 공급될 수 있고 변조 회로/모듈(2110)을 사용하여 유도 표면과 임베딩될 수 있다. 예를 들어, 코일(215)에 인가된 신호(V_1)의 일부는 키 코드 데이터(2130)를 전달하는 데이터 신호를 전달하기 위해 주파수, 위상 및/또는 진폭이 변할 수 있다. 이에 따라, 유효 키 코드 데이터(2130)는 대역 내 통신의 형태로서 유도 표면과 내에 임베딩되는 데이터로서 전력 서비스의 가입자의 유도 표면과 수신 구조물(R)에 공급될 수 있다. 이에 대응하여, 전력 서비스를 위한 제어기 디바이스(2120)는 네트워크(2150)를 통해 셀룰러 전송, 인터넷 통신, 암호화된 네트워크 채널 또는 터널 등과 같은 별개의 대역 외 통신 채널에서 가입자 또는 허가된 사용자의 유도 표면과 수신 구조물(R)에 사용자 키 코드 데이터(2140)를 송신할 수 있다.

[0482] 유도 표면과 수신 장비(2160)는 예약되고 보호된 메모리 영역과 같은 그러나 이에 제한되지 않는 메모리 영역에 수신된 사용자 키 코드(2140)를 저장할 수 있다. 일 실시예에서, 예약된 메모리 영역(2167)(도 22)은 유도 표면과 수신 장비(2160)의 인증 애플리케이션(2163) 외부의 외부 시스템 또는 애플리케이션에 의해 판독가능하지 않다. 이에 따라, 일 실시예에서, 유도 표면과 수신 장비(2160)의 프로세서(2503)(도 26)는 인증 애플리케이션(2163)에 의해 개시되는 판독 또는 기입 커맨드들만을 예약된 메모리 영역(2167)에 수용한다.

[0483] 다양한 실시예들에서, 사용자 키 코드(2140)는 수신된 유도 표면과로부터 획득된 유효 키 코드(2130)에 대해 체크될 새로운 값들로 주기적으로 또는 일상적으로 갱신될 수 있다. 이에 따라, 다양한 실시예들에서, 전력 서비스의 가입자 또는 허가된 사용자에게 사용자 키 코드(2140)에 대한 갱신들이 제공된다. 따라서, 현재 가입자의 유도 표면과 수신 구조물(R)은 일 실시예에서, 그 예약된 메모리 영역(2167)에서 가장 최근에 갱신된 사용자 키 코드(2140)- 사용자 키 코드는 수신된 유도 표면과로 수신되거나 이로부터 획득되는 유효 키 코드(2130)에 대해 검증되어야 함 -를 가질 것이다. 저장되는 사용자 키 코드(2140)가 유효 키 코드(2130)에 대해 성공적으로 검증되는 경우, 유도 표면과 수신 장비(2160)의 기능성이 인에이블되고 유도 표면과 수신 장비(2160)가 유도 표면과에 의해 제공된 전기 에너지를 처리하고, 인가된 전기 부하(315/527/336)에 에너지를 전달하도록 동작할 수 있다. 그렇지 않으면, 저장되는 사용자 키 코드(2140)가 유효 키 코드(2130)에 대해 검증되지 않으면, 유도 표면과 수신 장비(2160)의 기능성은 유도 표면과 수신 장비(2160)가 유도 표면과로부터의 전기 에너지를 인가된 부하(315/527/336)로 전달하는 것을 방지하도록 디스에이블된다. 일 실시예에서, 저장되는 사용자 키 코드는 지정된 시간 기간 후에 만료된다. 따라서, 그 만료 후에, 저장되는 사용자 키 코드(2140)는 더 이상 유도 표면과 수신 장비(2160)의 허가에 사용하기에 유효하지 않다.

- [0484] 다양한 검증 기술들이 상이한 실시예들에서 사용될 수 있다. 예를 들어, 각각의 키 코드들(2130, 2140)은 일 실시예에서 이들이 정합하는지를 결정하기 위해 비교될 수 있다. 또한, 해시 함수 $h(x)$ 는 일부 실시예에서 키 코드들의 호환성을 결정하기 위한 비교 지점으로서 사용될 수 있다. 유효 키 코드(2130)의 해시 함수가 계산되고 수신 장비(2160)의 일 실시예에서 저장되는 사용자 키 코드(2140)에 대해 비교될 수 있다는 것을 고려한다. 이에 따라, 해시 함수 값이 저장되는 사용자 키 코드(2140)에 대응하면, 사용자 키 코드(2140)는 유효한 것으로 간주될 수 있다. 대안적으로, 일 실시예에서, 해시 함수 값을 결정하기 위해 해시 함수 $h(x) = (K, \text{사용자 키 코드})$ 가 사용될 수 있고, K 는 수신 장비(2160)의 메모리 영역(예를 들어, 예약된 메모리 영역(2167))에 저장되는 비밀 키 또는 값이다. 따라서, 그 후 해시 함수 값은 유효 키 코드(2130)에 대해 비교되어 사용자 키 코드(2140)가 유효한지를 결정할 수 있다. 다른 실시예에서, 사용자 키 코드(2140)가 유효한지를 결정하기 위해, 해시 함수 $h(x) = (K, \text{유효 키 코드})$ 가 유사한 방식으로 사용되고 사용자 키 코드(2140)에 대해 비교될 수 있다. 본 기술분야의 통상의 기술자에게 알려진 바와 같이, 다른 인증 기술들이 또한 다양한 실시예들에서 사용될 수 있다.
- [0485] 다음으로 도 22를 참조하면, 본 개시내용의 다양한 실시예들에 따른 인증 제어 환경(2200)이 도시되어 있다. 인증 제어 환경(2200)은 네트워크(2150) 및 유도 표면과 통신(2210)을 통해 서로 데이터 통신하는 유도 표면과 제어기 디바이스(2120), 유도 표면과 수신 장비(2160) 및 잠재적으로 다른 디바이스들을 포함한다. 네트워크(2150)는, 예를 들어 인터넷, 인트라넷들, 엑스트라넷들, 광역 네트워크(WAN)들, 로컬 영역 네트워크(LAN)들, 유선 네트워크들, 무선 네트워크들, 또는 다른 적합한 네트워크들 등, 또는 대역 외 시그널링을 위한 2개 이상의 그러한 네트워크의 임의의 조합을 포함한다. 그러한 네트워크들은 위성 네트워크들, 케이블 네트워크들, 이더넷 네트워크들 및 다른 유형의 네트워크들을 포함할 수 있다. 대역 내 통신(2210)은 또한 유도 표면과를 사용하여 표면 도파로 프로브(P)와 유도 표면과 수신 구조물(R) 사이에서 수행될 수 있다. 이에 따라, 대역 내 통신(2210)은 하나 이상의 유도 표면과 도파로 프로브(P)와 하나 이상의 유도 표면과 도파로 수신 구조물(R) 사이의 유도 표면과들을 통해 전송되는 디지털 인코딩된 데이터를 포함할 수 있다.
- [0486] 이러한 구현예들에서, 개방형 시스템 상호 접속(OSI) 모델에 의해 지정된 다양한 계층 1 및/또는 계층 2 프로토콜들의 다양한 버전들과 같은 다양한 네트워크 프로토콜들이 사용될 수 있다. 예를 들어, 유도 표면과 도파로 프로브들(P)과 유도 표면과 도파로 수신 구조물들(R) 사이에서 디지털 인코딩된 데이터의 전송을 용이하게 하기 위해 이더넷 프로토콜 또는 유사한 프로토콜들이 채택될 수 있다. 다양한 네트워킹 기술들이 또한 네트워크(2150)에 의해 제공된 대역폭을 관리하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 시분할 다중화 기술들, 주파수-분할 다중화 기술들, 및/또는 다른 유사한 접근법들 또는 기술들이 사용될 수 있다. 유도 표면과 제어기 디바이스(2120)는 네트워크 인터페이스(2124)(예를 들어, 네트워크 인터페이스 통신 모듈)를 이용하여 네트워크(2150)를 통해 메시지들을 송신 및 수신할 수 있다.
- [0487] 유도 표면과 제어기 디바이스(2120)는 예를 들어 컴퓨팅 능력을 제공하는 서버 컴퓨터 또는 임의의 다른 시스템을 포함할 수 있다. 대안적으로, 제어기 디바이스(2120)는 예를 들어 하나 이상의 서버 뱅크 또는 컴퓨터 뱅크 또는 다른 배열에 배열될 수 있는 복수의 컴퓨팅 디바이스를 사용할 수 있다. 이러한 컴퓨팅 디바이스들은 단일 설비에 배치되거나 많은 상이한 지리적 위치 사이에 분산될 수 있다. 예를 들어, 제어기 디바이스(2120)는 호스팅된 컴퓨팅 자원, 그리드 컴퓨팅 자원 및/또는 임의의 다른 분산형 컴퓨팅 배열을 함께 포함할 수 있는 복수의 컴퓨팅 디바이스를 포함할 수 있다. 일부 경우에서, 제어기 디바이스가 처리, 네트워크, 스토리지, 또는 다른 컴퓨팅 관련 자원들의 할당 용량이 시간의 경과에 따라 변할 수 있는 탄력적인 컴퓨팅 자원에 대응할 수 있다.
- [0488] 키 생성기 기능성, 모듈, 또는 애플리케이션(2126) 및 사용자 인증 기능성/모듈/애플리케이션(2128)과 같이, 다양한 애플리케이션들 및/또는 다른 기능성이 다양한 실시예들에 따라 유도 표면과 제어기 디바이스(2120)에서 실행될 수 있다. 키 생성기(2126)는 유효 키 코드(2140) 및/또는 사용자 키 코드(2130) 중 어느 하나로서 사용되는 키 코드들을 생성하도록 구성된다. 또한, 다양한 데이터가 제어기 디바이스(2120)에 액세스가능한 데이터 저장소(2408)(도 25)에 저장될 수 있다. 저장되는 데이터는 예를 들어, 사용자에게 할당된 유도 표면과 수신 장비(2160)(예를 들어, 네트워크 인터페이스 통신 모듈)의 네트워크 인터페이스(2164)의 사용자 프로파일 및 매체 액세스 제어(MAC) 주소 및/또는 다른 고유 식별자들을 포함할 수 있다.
- [0489] 유도 표면과 수신 장비(2160)는 예를 들어, 유도 표면과 수신 구조물(R)을 포함하는 임의의 디바이스, 시스템 또는 장치를 포함할 수 있다. 또한, 유도 표면과 수신 장비(2160)는 인증 검증 서비스들을 처리하고/하거나, 유도 표면과 수신 장비(2160)의 비허가 사용의 검출에 적어도 부분적으로 기초하여 일부 액션을 취하기 위해 필요한 컴퓨팅 능력들, 예컨대 본 명세서에서 설명된 것과 같은 프로세서, 메모리 및 다른 회로를 포함할 수

있다. 유도 표면과 수신 구조물(R) 및 컴퓨팅 회로는 유도 표면과 수신 장비(2160)에 통합될 수 있거나 유도 표면과 수신 장비(2160)에 부가되거나 부착될 수 있다. 예를 들어, 유도 표면과 수신 장비(2160)는 데스크톱 컴퓨터, 랩톱 컴퓨터, 셋톱 박스, 또는 유사한 능력을 갖는 다른 디바이스들의 형태로 구현될 수 있다.

[0490] 유도 표면과 수신 장비(2160)는 복조/복호화 애플리케이션(들)(2166), 인증 애플리케이션(들)(2163) 및/또는 유도 표면과 수신 장비(2160)에 구현되는 전력의 전달과 관련된 다른 애플리케이션들 또는 기능성들과 같은 다양한 애플리케이션들을 실행하도록 구성될 수 있다. 다양한 애플리케이션들은 예를 들어, 하나 이상의 액션을 수행하기 위해, 유도 표면과 수신 장비(2160)의 프로세서(2503)(도 26)에 의해 실행될 수 있다. 예를 들어, 유효 키 코드(2130)가 (네트워크 인터페이스(2163) 및 복조/복호화 애플리케이션 또는 모듈(2166)을 통해) 대역 외 통신(2210)으로부터 획득될 수 있고, 사용자 키 코드(2140)를 유효 키 코드(2130)에 대해 확인하는 것(예를 들어, 호환성을 결정하는 것 등)에 의해 예약된 메모리 영역(2167)에 저장되는 사용자 키 코드(2140)가 검증되는지를 결정하도록 처리될 수 있다.

[0491] 일 실시예에서, 특정 양의 비휘발성 메모리가 인증 애플리케이션(2163)에 의해 내부 용도로 예약되고; 메모리(2168)의 제2 부분은 유도 표면과 수신 장비(2160)에 의한 데이터 저장 및 검색을 위해 이용가능하다. 비휘발성 메모리의 예약된 부분(2167)은 그 내부에 사용자 키 코드(2140)를 저장하도록 적응되는 사용자 키 저장 영역을 포함한다. 사용자 키 코드(2140) 및/또는 유효 키 코드(2130)는 일 실시예에서 다수의 바이트의 정보를 포함할 수 있고, 약 8 바이트로부터 약 16 바이트까지 포함할 수 있다.

[0492] 성공적인 검증을 위해, 유도 표면과 수신 장비(2160)의 인증 애플리케이션(2163)은 다양한 실시예들에서, 수신된 유도 표면과 수신 장비(2160)로부터의 전력의 전달과 관련된 유도 표면과 수신 장비(2160)의 기능성이 인에이블되게 할 수 있다(또는 동작을 계속하도록 허용되게 할 수 있다). 그러나, 성공적이지 않은 검증(즉, 무효화)을 위해, 인증 애플리케이션(2163)은 수신된 유도 표면과 수신 장비(2160)의 전력의 전달과 관련된 유도 표면과 수신 장비(2160)의 기능성을 디스에이블되게 할 수 있다.

[0493] 다양한 실시예들에서, 유도 표면과 수신 장비(2160)의 유도 표면과 수신 구조물(R)은 일부 경우에서, 유도 표면과 수신 장비(2160) 또는 그 일부를 충전하거나 그렇지 않으면 전력공급하도록 또한 동작할 수 있는 유도 표면과 수신 장비(2160)이다. 유도 표면과 수신 구조물(R)이 유도 표면과 수신 장비(2160)에 임베딩된 사용자 키 코드 데이터(2140)를 검출하면, 인증 애플리케이션(2163)은 어떤 액션이, 만약 있다면, 응답으로 수행되어야 하는지를 결정하기 위해 사용자 키 코드(2140)가 예약된 메모리 영역(2167)으로부터 검색되도록 요청할 수 있다. 그 후, 인증 애플리케이션(2163)은 유도 표면과 수신 장비(2160)에 임베딩된 유효 키 코드(2130)와 저장되는 사용자 키 코드(2140)의 비교의 결과로 특정 수신 기능성/회로(2161)가 디스에이블되거나 인에이블되게 할 수 있다.

[0494] 이에 따라, 다양한 실시예들에서, 전력 신호를 수신하는 유효 키 코드(2130)는 유도 표면과 수신 장비(2160)의 의도된 동작 또는 현재의 사용자를 확인 또는 인증하기 위해 유도 표면과 수신 장비(2160)의 통신 채널에서 개별적으로 획득된 사용자 키 코드(2140)를 검증하기 위해 사용될 수 있다. 대안적으로, 일부 실시예에서, 유효 키 코드는 (예를 들어, 네트워크(2150)를 통한 셀룰러 전송, 인터넷 통신, 암호화된 네트워크 채널 또는 터널 등을 통해) 유도 표면과 수신 장비(2160)에 동시에 대역 외로 제공될 수 있다.

[0495] 본 개시내용의 다양한 실시예들에서, 하나 이상의 액션과 같은 데이터의 일부는 메모리(2168) 또는 유도 표면과 수신 장비(2160)에 대한 다른 형태의 데이터 스토리지에 저장될 수 있다. 액션들의 일부 예들은 유도 표면과 수신 장비(2160)를 전원 오프(powering off)하는 것, 비허가된 사용을 방지하기 위해 유도 표면과 수신 장비(2160)의 특정 피쳐들, 기능성, 또는 서브컴포넌트들(2161)을 디스에이블하는 것, 설정된 기간 동안 특정 피쳐들에 대해 슬립 모드를 인에이블하는 것 등을 포함한다. 이에 따라, 일부 경우에서, 액션은 유도 표면과 수신 장비(2160)의 기능 또는 능력이 디스에이블되는 것으로 지정할 수 있다. 또한, 키 코드들의 쌍이 호환가능하지 않는 경우, 예약된 메모리 영역(2167)에 대한 액세스가 제한될 수 있다. 일부 실시예에서, 예약된 메모리 영역(2167)은 방화 디바이스들 또는 다른 디바이스들을 포함하는 다양한 기술들을 사용하여 파괴될 수 있다.

[0496] 네트워크 인터페이스(2164)는 네트워크(2150)와 같은 하나 이상의 컴퓨터 네트워크에 접속하도록 구성될 수 있다. 네트워크 인터페이스(2164)는 유선 또는 무선 인터페이스에 대응할 수 있다. 예를 들어, 네트워크 인터페이스(2164)는 Bluetooth[®] 인터페이스, IEEE 802.11 무선 네트워크(Wi-Fi[®]) 인터페이스, 셀룰러 라디오 송신기 및 수신기, 또는 유사한 네트워크 인터페이스에 대응할 수 있다.

[0497] 그 후, 유도 표면과 수신 장비(2160)는 대역 외 통신 내에서 새로운 또는 갱신된 사용자 키 코드(2140)를 계속 모니터링할 수 있다. 예를 들어, 갱신된 사용자 키 코드(2140)가 수신되고 유도 표면과 수신 장비(2160)로부터 획득된 유효 키

코드(2130)에 대해 검증되는 경우, 인증 애플리케이션(2163)은 유도 표면과 수신 장비(2160)의 프로세서(2503)(도 26)가 디스플레이된 피쳐들을 재개하게 할 수 있다. 다양한 실시예들에서, 인증 애플리케이션(2163)은 유도 표면과 수신 장비(2160)의 시동(start-up)시 또는 주기적인 간격들로 갱신된 사용자 키 코드(2140)를 체크하도록 구성될 수 있다. 갱신된 사용자 키 코드(2140)를 획득하기 위해, 인증 애플리케이션(2163)은 유도 표면과 수신 장비(2160)와 연관된 사용자 ID 및/또는 패스워드에 대해, 유도 표면과 제어기 디바이스(2120)에서 대응하는 사용자 인증 애플리케이션(2128)에 의해 요청받을 수 있다. 따라서, 제공되는 사용자 ID 및/또는 패스워드 정보가 사용자 인증 애플리케이션(2128)에 의해 검증되면, 갱신된 사용자 키(2140)가 제공되고 유도 표면과 수신 장비(2160)에서 예약된 메모리 영역(2167)에 저장될 수 있다.

[0498] 일부 실시예에서, 유도 표면과 수신 장비(2160)의 전부 또는 일부는 유도 표면과 수신 구조물(R)의 다양한 컴포넌트들을 보호하는 외부 케이스에 둘러싸일 수 있다. 예를 들어, 일부 실시예에서, 유도 표면과 수신 장비(2160)는 단일 쉘 내에 둘러싸인 유도 표면과 수신 구조물(R)을 갖는 휴대용 또는 핸드헬드 유닛일 수 있다.

[0499] 전술한 바와 같이, 유도 표면과 수신 구조물(R)은 유도 표면과 수신할 수 있는 하나 이상의 구조물에 대응할 수 있다. 유도 표면과 수신 구조물(R)은, 예를 들어 전술한 바와 같이, 선형 프로브, 튜닝형 공진기, 자기 코일 및/또는 유도 표면과 수신하기 위한 유사한 구조물들을 포함할 수 있다. 일부 실시예에서, 유도 표면과 수신 구조물(R)은 복수의 유도 표면과 수신 구조물(R)을 나타낼 수 있고, 유도 표면과 수신 구조물들 각각은 다른 유도 표면과 수신 구조물들(R)과 상이한 주파수에서 유도 표면과 수신하도록 튜닝된다. 다양한 실시예들에서, 유도 표면과 수신 구조물(R)은 상이한 주파수들에서의 다수의 유도 표면과 수신하도록 튜닝되도록 구성될 수 있다. 일부 실시예에서, 유도 표면과 수신 구조물(R)은 제1 주파수에서의 유도 표면과 수신, 수신 및/또는 측정하기 위해 주파수들을 교대로 하고, 그 후 제2 주파수에서의 제2 유도 표면과 수신 검출하기 위해 제2 주파수로 스위칭하도록 구성될 수 있다.

[0500] 이제 도 23a를 참조하면, 사용자 인증을 위해 사용되는 키 코드들을 수신하고 저장하는 것과 관련된 동작들을 예시한 개략도가 제공된다. 대역 외 통신의 경우, 유도 표면 도파로 프로브와 연관된 유도 표면과 제어기 디바이스(2120)에서의 네트워크 인터페이스(2124)는 사용자 키 코드(2140)를 사용자(예를 들어, 유도 표면과 서비스에 대한 현재 가입자)와 연관된 유도 표면과 수신 장비(2160)에 전송할 수 있다. 예를 들어, 사용자 키 코드(2140)는 네트워크(2150)를 통해 사용자 및 연관된 유도 표면과 수신 장비(2160)의 네트워크 인터페이스(2164)로 전송될 수 있다(2310). 사용자 키 코드(2140)는, (예를 들어, 복조/복호화 회로 또는 애플리케이션(2166)에 의해) 대역 외 통신의 수신 및 처리 시에, 후속 검색 및 처리를 위해 유도 표면과 수신 장비(2160)에 대한 메모리의 예약되고 보호된 영역(2167)에 저장될 수 있다(2320).

[0501] 이에 대응하여, 대역 내 통신의 경우, 유도 표면 도파로 프로브(P)에 결합된 변조 회로 또는 애플리케이션 모듈(2110)은 예컨대, 지상 매체와 같은 손실 매체를 가로질러 유도 표면과 수신 장비(2160)로 발진 또는 전송되는 유도 표면과 수신 유효 키 코드를 임베딩할 수 있다(2330). 대안 실시예에서, 유효 키 코드(2130)는 공지된 또는 허가된 유도 표면과 수신 장비(2160)에 또한 제공될 수 있다. 예를 들어, 하나의 예시적인 경우에, 유효 키(2160)는 연관된 사용자 계정이 양호한 상태에 있는 유도 표면과 수신 장비(2160)로 대역 외 통신으로 전송될 수 있고, 과거 서비스들에 대한 비용 지불에 결함이 있는(예를 들어, 그 사용자 계정이 불량한 상태에 있는) 유도 표면과 수신 장비(2160)로 전송되지 않을 수 있다.

[0502] 유도 표면과 수신 장비(2160)에서 복조기 컴포넌트 또는 회로(2166)는 유효 키 코드(2130)를 결정하기 위해 전력 신호를 처리할 수 있다. 그 후, 유효 키 코드(2130)는 유도 표면과 수신 장비(2160)의 인증 애플리케이션(2163)에 의한 추가의 처리를 대기하기 위해 메모리(2168) 또는 캐시에 저장될 수 있다(2340).

[0503] 인증 애플리케이션(2163)은 각각의 키 코드들이 호환가능한지(예를 들어, 동일한 값 또는 기능에 대응하는지)를 결정(2350)하도록 유효 키 코드(2130)를 이용하여 예약된 메모리(2167)에 저장되는 사용자 키 코드(2140)를 검색하도록 적응된다. 각각의 키 코드들이 호환가능하다면, 유도 표면과 수신 장비(2160)로부터 획득된 전기 에너지를 유도 표면과 수신 구조물(R)에 결합된 전기 부하(315/527/336)로 전달하는 것을 허용하도록 유도 표면과 수신 장비(2160)의 기능성(2161)은 인에이블되거나(2170) 유지된다. 예를 들어, 특정 장비 컴포넌트들 또는 피쳐들이 활성화될 수 있다. 반면, 각각의 키 코드들이 호환가능하지 않다면, 유도 표면과 수신 장비(2160)의 기능성(2161)은 유도 표면과 수신 구조물(R)로부터 획득된 전기 에너지를 유도 표면과 수신 구조물(R)에 결합된 전기 부하(315/527/336)로 전달하는 것을 금지/제한하도록 디스플레이되거나(2180) 비활성화된다.

[0504] 다음으로 도 23b를 참조하면, 사용자 인증의 대안 실시예에 관련된 동작들을 예시하기 위한 개략도가 제공된다. 2360에서, 예약된 메모리 영역(2167)은 일련 번호 S/N, 디바이스 식별 번호, 사용자 계정 번호, 비밀 식별 번호

등과 같은 유도 표면과 수신 장비(2160) 및/또는 사용자에게 대한 고유 식별 번호를 유지할 수 있다. 이에 따라, 유도 표면과 수신 장비(2160)는 인증 프로세스의 일부로서, (네트워크(2150)를 통해 수신 장비(2160)의 네트워크 인터페이스(2164)로부터의 제어기 디바이스(2120)의 네트워크 인터페이스(2124)로) 유도 표면 도파로 프로브와 연관된 유도 표면과 제어기 디바이스(2120)에 일련 번호 S/N을 전송할 수 있다. 일 실시예에서, 전송은 보안 네트워크 터널 통신 또는 다른 유형의 보안 통신의 일부로서 이루어질 수 있다. 2370에서, 유도 표면과 제어기 디바이스(2120)에서의 사용자 인증 애플리케이션(2128)은 수신된 유도 표면과 전송들에 대해 유도 표면과 수신 장비(2160)로부터 수신된 일련 번호 S/N이 검증되는지 또는 허가되는지를 결정하기 위해 인증 검증 프로세스를 수행할 수 있다. 이에 따라, 2380에서, 유도 표면과 수신 장비(2160)가 검증되면, 사용자 인증 애플리케이션(2128)은 수신 장비(2160)(예컨대, 기능성 회로(2160) 및/또는 프로세서(2503)(도 26))에 대해 (네트워크(2150)를 통해 제어기 디바이스(2120)의 네트워크 인터페이스(2124)로) 인에이블 커맨드를 송신해서 유도 표면과 수신 장비(2160)의 동작을 인에이블할 수 있다. 그렇지 않으면, 수신 장비(2160)가 무효화되면, 사용자 인증 애플리케이션(2128)은 수신 장비(2160)(예컨대, 기능성 회로(2160) 및/또는 프로세서(2503)(도 26))에 대해 (네트워크(2150)를 통해 제어기 디바이스(2120)의 네트워크 인터페이스(2124)로) 디스에이블 커맨드를 송신해서 유도 표면과 수신 장비(2160)의 동작을 디스에이블할 수 있다.

[0505] 인에이블 커맨드의 수신시, 유도 표면과 수신 장비(2160)의 기능성(2161)은 유도 표면과로부터 획득된 전기 에너지를 유도 표면과 수신 구조물(R)에 결합된 전기 부하(315/527/336)로 전달하는 것을 허용하도록 인에이블되거나 유지된다. 예를 들어, 특정 장비 컴포넌트들 또는 피쳐들이 활성화될 수 있다. 반면, 디스에이블 커맨드의 수신시, 유도 표면과 수신 장비(2160)의 기능성(2161)은 유도 표면과로부터 획득된 전기 에너지를 유도 표면과 수신 구조물(R)에 결합된 전기 부하(315/527/336)로 전달하는 것을 금지/제한하도록 디스에이블되거나 비활성화된다.

[0506] 다음으로 도 24를 참조하면, 다양한 실시예들에 따른 유도 표면과 수신 장비(2160)의 일부의 동작의 일 예를 제공하는 플로차트가 도시되어 있다. 도 24의 플로차트는 본 명세서에 설명된 바와 같이 유도 표면과 수신 장비(2160)(예를 들어, 인증 애플리케이션(2163))의 일부의 동작을 구현하기 위해 사용될 수 있는 많은 상이한 유형의 기능적 배열들의 단지 예를 제공한다는 것이 이해된다. 대안으로서, 도 24의 플로차트는 다양한 실시예들에 따라 유도 표면과 수신 장비(2160)(도 22)에 구현되는 방법의 요소들의 예를 도시하는 것으로 볼 수 있다.

[0507] 박스(2303)로 시작하여, 유도 표면과 수신 장비(2160)(예를 들어, 데이터 변조기(2166))는 유도 표면과 수신 구조물(R)이 유도 표면과를 수신하는지를 결정한다. 유도 표면과 수신 장비(2160)가 유도 표면과 수신 구조물(R)이 현재 유도 표면과를 수신하고 있지 않거나 또는 유도 표면과를 수신하지 않는 것으로 결정하면, 프로세스의 실행은 박스(2313)로 스킵한다. 그러나, 유도 표면과 수신 구조물(R)이 유도 표면과를 수신한다면, 프로세스의 실행은 박스(2306)로 진행한다.

[0508] 박스(2306)로 이동하면, 유도 표면과 수신 장비(2160)는 유도 표면과 수신 장비(2160)의 프로세서(2503)(도 26)로 하여금, 만약 존재한다면, 유도 표면과에 임베딩되거나 그렇지 않으면 인코딩된 유효 키 코드(2130)를 디코딩하거나 복조화하게 한다. 대안 실시예에서, 유효 키 코드(2130)는 대역 외 통신에서 유도 표면과 수신 장비(2160)로 송신될 수 있다. 유효 키 코드(2130)는 유도 표면과 수신 장비(2160)의 예약된 메모리(2167)에 저장되는 사용자 키 코드(2140)를 검증하기 위해 인증 애플리케이션(2163)에 의해 사용될 수 있다.

[0509] 다음으로 박스(2309)를 참조하면, 사용자 인증 애플리케이션(2163)은 유도 표면과 수신 장비(2160)의 프로세서(2503)(도 26)로 하여금 예약된 메모리 영역(2167)으로부터 사용자 키를 검색하게 한다. 그 후, 인증 애플리케이션(2163)은 어떤 액션이, 만약 있다면, 유효 키 코드(2130)를 사용자 키 코드(2140)와 비교하는 것에 응답하여 수행되어야 하는지를 결정한다. 실행은 박스(2311)로 진행한다.

[0510] 일 실시예에서, 사용자 키 코드(2140)를 검색할 때, 유도 표면과 수신 장비(2160)는 갱신된 사용자 키 코드(2140)에 대해 스케줄링된 시간/간격으로 유도 표면과 제어기 디바이스(2120)에서 사용자 인증 애플리케이션(2128)을 폴링(poll)하거나 폴링(pull)하도록 구성될 수 있다. 대안적으로, 다양한 실시예들에서, 유도 표면과 제어기 디바이스(2120)에서의 사용자 인증 애플리케이션(2128)은 유도 표면과 수신 장비(2160)에 대해 등록된 MAC 주소로 유도 표면과 수신 장비(2160)에 갱신된 사용자 키 코드(2140)를 푸싱(push)할 수 있다. 또한, 정의된 시간 기간 후에, 유도 표면과 수신 장비(2160)에서의 저장되는 사용자 키 코드(2140)는 유도 표면과 수신 장비(2160)에 의해 만료된 것으로 간주될 수 있고, 유도 표면과 수신 장비(2160)는 제어기 디바이스(2120)로부터 새로운 갱신된 사용자 키 코드(2140)를 요청하도록 구성될 수 있다. 이에 따라, 제어기 디바이스(2120)는 유도 표면과 수신 장비(2160)가 유효 사용자 ID 및/또는 패스워드와 연관된다는 검증 시에 갱신된 키 코드(2140)를

제공할 수 있다. 이에 대응하여, 유도 표면과 수신 장비(2160)는 저장되는 사용자 키 코드가 유효 키 코드(2130)와 호환되지 않는다는 허가 애플리케이션(2163)으로부터의 통지시 유도 표면과 제어기 디바이스(2120)로부터 새로운 갱신된 사용자 키 코드(2140)를 요청할 수 있다.

[0511] 다음으로 박스(2311)를 참조하면, 인증 애플리케이션(2163)은 유도 표면과 수신 장비(2160)의 프로세서(2503)(도 26)로 하여금 인증 애플리케이션(2163)에 의해 지정되는 액션을 수행하게 한다. 예를 들어, 인증 애플리케이션(2163)은 사용자 키 코드(2140)가 호환가능하지 않거나 또는 유효 키 코드(2130)에 대응하는 경우, 프로세서(2503)(도 26)로 하여금 유도 표면과 수신 장비(2160)의 기능성(2161)을 디스에이블하게 할 수 있다(예를 들어, 하나 이상의 컴포넌트를 디스에이블하게 할 수 있다). 그렇지 않으면, 인증 애플리케이션(2163)은, 사용자 키 코드(2140)가 호환가능하거나 유효 키 코드(2130)에 대응하는 경우, 유도 표면과들로 구현된 전력을 인가된 부하(315/327/336)로 전달하기 위해 프로세서(2503)(도 26)로 하여금 유도 표면과 수신 장비(2160)의 기능성(2161)(예를 들어, 하나 이상의 컴포넌트)을 인에이블하거나 또는 그 기능성의 인에이블먼트(enablement)를 계속하게 할 수 있다.

[0512] 일부 실시예에서, 인증 애플리케이션(2163)은 또한, 전용 액션 회로로 하여금 프로세서(2503)(도 26) 대신 이러한 액션들을 수행하게 할 수 있다. 소프트웨어로 이러한 액션들 중 하나 이상을 수행하기 위해 프로세서(2503)(도 26)를 사용하는 것은 유도 표면과 수신 장비(2160)의 제조를 단순화할 수 있지만, 액션들을 수행하기 위해서, 전용 하드웨어의 사용이 보다 안전할 수 있다. 적절한 액션이 수행된 후, 프로세스의 실행이 종료된다(블록(2313)에서).

[0513] 도 25를 참조하면, 본 개시내용의 실시예에 따른 유도 표면과 제어기 디바이스(2120)의 개략 블록도가 도시되어 있다. 제어기 디바이스(2120)는 예를 들어, 프로세서(2402) 및 메모리(2404)- 그 양자 모두가 로컬 인터페이스(2406)에 결합됨 -를 갖는 적어도 하나의 프로세서 회로를 포함할 수 있다. 로컬 인터페이스(2406)는 이해될 수 있는 바와 같이, 예를 들어 첨부 주소/제어 버스 또는 다른 버스 구조물을 갖는 데이터 버스를 포함할 수 있다.

[0514] 프로세서(2402)에 의해 실행가능한 몇몇 컴포넌트와 데이터 양자 모두는 메모리(2404)에 저장된다. 특히, 사용자 인증 애플리케이션(2128) 및 잠재적으로 다른 애플리케이션들이 메모리(2404)에 저장되고 프로세서(2402)에 의해 실행가능하다. 또한, 데이터 저장소(2408) 및 다른 데이터가 메모리(2404)에 저장될 수 있다. 또한, 운영 체제는 메모리(2404)에 저장되고 프로세서(2402)에 의해 실행가능할 수 있다.

[0515] 이해될 수 있는 바와 같이, 메모리(2404)에 저장되고 프로세서(2402)에 의해 실행가능한 다른 애플리케이션들이 있을 수 있다는 것이 이해된다. 본 명세서에서 논의되는 임의의 컴포넌트가 소프트웨어의 형태로 구현되는 경우, 예를 들어, C, C++, C#, Objective C, Java[®], JavaScript[®], Perl, PHP, Visual Basic[®], Python[®], Ruby, Flash[®], 또는 다른 프로그래밍 언어들과 같은, 다수의 프로그래밍 언어 중 임의의 하나가 이용될 수 있다.

[0516] 다수의 소프트웨어 컴포넌트가 메모리(2404)에 저장되고 프로세서(2402)에 의해 실행가능하다. 이와 관련하여, "실행가능"이라는 용어는 궁극적으로 프로세서(2402)에 의해 실행될 수 있는 형태의 프로그램 파일을 의미한다. 실행가능 프로그램들의 예들은, 예를 들어, 메모리(2404)의 랜덤 액세스 부분에 로딩되고 프로세서(2402)에 의해 실행될 수 있는 포맷의 머신 코드로 번역될 수 있는 컴파일된 프로그램, 메모리(2404)의 랜덤 액세스 부분에 로딩되고 프로세서(2402)에 의해 실행될 수 있는 오브젝트 코드와 같은 적절한 포맷으로 표현될 수 있는 소스 코드, 또는 프로세서(2402)에 의해 실행되도록 메모리(2404)의 랜덤 액세스 부분에 명령어들을 생성하기 위해 다른 실행가능한 프로그램에 의해 해석될 수 있는 소스 코드 등일 수 있다. 실행가능 프로그램은, 예를 들어 랜덤 액세스 메모리(RAM), 판독 전용 메모리(ROM), 하드 드라이브, 고체 상태 드라이브, USB 플래시 드라이브, 메모리 카드, CD(compact disc) 또는 DVD(digital versatile disc)와 같은 광 디스크, 플로피 디스크, 자기 테이프, 플래시 또는 프로그램가능 판독 전용 메모리 칩, 또는 다른 메모리 컴포넌트들을 포함하는 메모리(2404)의 임의의 일부 또는 컴포넌트에 저장될 수 있다.

[0517] 도 26을 참조하면, 본 개시내용의 실시예에 따른 유도 표면과 수신 장비(2160)의 개략 블록도가 도시되어 있다. 유도 표면과 수신 장비(2160)는 예를 들어, 프로세서(2503) 및 메모리(2168)- 그 양자 모두가 로컬 인터페이스(2509)에 결합됨 -를 갖는 적어도 하나의 프로세서 회로를 포함할 수 있다. 로컬 인터페이스(2509)는 이해될 수 있는 바와 같이, 예를 들어 첨부 주소/제어 버스 또는 다른 버스 구조물을 갖는 데이터 버스를 포함할 수 있다.

[0518] 프로세서(2503)에 의해 실행가능한 몇몇 컴포넌트와 데이터 양자 모두는 메모리(2168)에 저장된다. 특히, 인증

애플리케이션(2163) 및 잠재적으로 다른 애플리케이션들이 메모리(2168)에 저장되고 프로세서(2503)에 의해 실행가능하다. 또한, 데이터 저장소(2167)(예를 들어, 예약된 메모리 영역) 및 다른 데이터 또는 캐시와 같은 데이터 저장 영역들이 메모리(2168)에 저장될 수 있다. 또한, 운영 체제는 메모리(2168)에 저장되고 프로세서(2503)에 의해 실행가능할 수 있다.

[0519] 이해될 수 있는 바와 같이, 메모리(2168)에 저장되고 프로세서(2503)에 의해 실행가능한 다른 애플리케이션들이 있을 수 있다는 것이 이해된다. 본 명세서에서 논의되는 임의의 컴포넌트가 소프트웨어의 형태로 구현되는 경우, 예를 들어, C, C++, C#, Objective C, Java[®], JavaScript[®], Perl, PHP, Visual Basic[®], Python[®], Ruby, Flash[®], 또는 다른 프로그래밍 언어들과 같은, 다수의 프로그래밍 언어 중 임의의 하나가 이용될 수 있다.

[0520] 다수의 소프트웨어 컴포넌트가 메모리(2168)에 저장되고 프로세서(2503)에 의해 실행가능하다. 이와 관련하여, "실행가능"이라는 용어는 궁극적으로 프로세서(2503)에 의해 실행될 수 있는 형태의 프로그램 파일을 의미한다. 실행가능 프로그램들의 예들은, 예를 들어, 메모리(2168)의 랜덤 액세스 부분에 로딩되고 프로세서(2503)에 의해 실행될 수 있는 포맷의 머신 코드로 번역될 수 있는 컴파일된 프로그램, 메모리(2168)의 랜덤 액세스 부분에 로딩되고 프로세서(2503)에 의해 실행될 수 있는 오브젝트 코드와 같은 적절한 포맷으로 표현될 수 있는 소스 코드, 또는 프로세서(2503)에 의해 실행되도록 메모리(2168)의 랜덤 액세스 부분에 명령어들을 생성하기 위해 다른 실행가능한 프로그램에 의해 해석될 수 있는 소스 코드 등일 수 있다. 실행가능 프로그램은, 예를 들어 랜덤 액세스 메모리(RAM), 판독 전용 메모리(ROM), 하드 드라이브, 고체 상태 드라이브, USB 플래시 드라이브, 메모리 카드, CD(compact disc) 또는 DVD(digital versatile disc)와 같은 광 디스크, 플로피 디스크, 자기 테이프, 또는 보호 및 예약된 메모리 영역들을 포함하는 다른 메모리 컴포넌트들을 포함하는 메모리(2168)의 임의의 일부 또는 컴포넌트에 저장될 수 있다.

[0521] 도 25 및 도 26을 참조하면, 메모리(2168) 및 메모리(2404)는 본 명세서에서 데이터 저장 컴포넌트들 및 휘발성 및 비휘발성 메모리 양자 모두를 포함하는 것으로서 정의된다. 휘발성 컴포넌트들은 전력 손실시 데이터 값을 보유하지 않는 컴포넌트들이다. 비휘발성 컴포넌트들은 전력 손실시 데이터를 보유하는 컴포넌트들이다. 따라서, 메모리(2168) 및 메모리(2404)는 예를 들어, 랜덤 액세스 메모리(RAM), 판독 전용 메모리(ROM), 하드 디스크 드라이브들, 고체 상태 드라이브들, USB 플래시 드라이브들, 메모리 카드 판독기를 통해 액세스되는 메모리 카드들, 연관 플로피 디스크 드라이브를 통해 액세스되는 플로피 디스크들, 광학 디스크 드라이브를 통해 액세스되는 광학 디스크들, 적절한 테이프 드라이브를 통해 액세스되는 자기 테이프들 및/또는 다른 메모리 컴포넌트들, 또는 이들 메모리 컴포넌트들 중 임의의 2개 이상의 조합을 포함할 수 있다. 또한, RAM은, 예를 들어, SRAM(static random access memory), DRAM(dynamic random access memory), 또는 MRAM(magnetic random access memory) 및 다른 이러한 디바이스들을 포함할 수 있다. ROM은, 예를 들어, PROM(programmable read-only memory), EPROM(erasable programmable read-only memory), EEPROM(electrically erasable programmable read-only memory), 또는 다른 유사한 메모리 디바이스를 포함할 수 있다.

[0522] 또한, 프로세서(2503) 및 프로세서(2402)는 다수의 프로세서 및/또는 다수의 프로세서 코어를 나타낼 수 있고, 메모리(2168, 2404)는 병렬 처리 회로들에서 각각 동작하는 다수의 메모리를 나타낼 수 있다. 그러한 경우, 로컬 인터페이스(2509, 2609)는 다수의 프로세서(2503, 2402) 중 임의의 2개 사이, 임의의 프로세서(2503, 2402)와 메모리들(2168, 2404) 중 임의의 것 사이, 또는 메모리들(2168, 2404) 중 임의의 2개 사이 등에서 통신을 용이하게 하는 적절한 네트워크일 수 있다. 로컬 인터페이스(2509, 2609)는, 예를 들어 부하 밸런싱을 수행하는 것을 포함하여, 이러한 통신을 조정하도록 설계되는 추가의 시스템들을 포함할 수 있다. 프로세서(2503, 2402)는 전기적이거나 일부 다른 이용가능한 구성일 수 있다.

[0523] 본 명세서에서 설명된 사용자 인증 애플리케이션(2128), 인증 애플리케이션(2163) 및 다른 다양한 시스템들은 앞에서 논의된 것과 같이 범용 하드웨어에 의해 실행되는 소프트웨어 또는 코드로 구현될 수 있지만, 대안으로서, 전용 하드웨어 또는 소프트웨어/범용 하드웨어와 전용 하드웨어의 조합으로 동일한 것이 또한 구현될 수 있다. 전용 하드웨어로 구현되는 경우, 각각은 다수의 기술 중 임의의 하나 또는 그 조합을 이용하는 회로 또는 상태 머신으로서 구현될 수 있다. 이러한 기술들은, 이에 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 데이터 신호의 인가시 다양한 로직 기능들을 구현하기 위한 로직 게이트들을 갖는 이산 로직 회로들, 적절한 로직 게이트들을 갖는 ASIC들(application specific integrated circuits), FPGA들(field-programmable gate arrays), 또는 다른 컴포넌트들 등을 포함할 수 있다. 이러한 기술들은 일반적으로 본 기술분야의 통상의 기술자에게 잘 알려져 있으며, 따라서, 본 명세서에서 상세히 기술되지 않는다.

[0524] 도 23 및 도 24의 플로차트들은 구체적인 실행 순서를 도시하지만, 실행 순서가 도시된 것과 상이할 수 있다는

것이 이해된다. 예를 들어, 2개 이상의 블록의 실행 순서는 도시된 순서에 대해 스캐램블링될 수 있다. 또한, 도 23 및 도 24에서 연속으로 도시되는 2개 이상의 블록은 동시에 또는 부분적으로 동시에 실행될 수 있다. 또한, 일부 실시예에서, 도 23 및 도 24에 도시된 하나 이상의 블록은 스킵되거나 생략될 수 있다. 또한, 임의의 수의 카운터들, 상태 변수들, 경고 세마포어들(warning semaphores), 또는 메시지들은, 향상된 유틸리티, 어카운팅(accounting), 성능 측정, 또는 문제 해결 지원들(troubleshooting aids)을 제공하는 것 등의 목적들을 위해, 본 명세서에 설명되는 로직 흐름에 추가될 수 있다. 이러한 모든 변형이 본 개시내용의 범위 내에 있다는 점이 이해된다.

[0525] 또한, 소프트웨어 또는 코드를 포함하는, 사용자 인증 애플리케이션(2128) 및 인증 애플리케이션(2163)을 포함하여, 본 명세서에 설명된 임의의 로직 또는 애플리케이션은 예를 들어, 컴퓨터 시스템 또는 다른 시스템의 프로세서와 같은 명령어 실행 시스템과 관련하여 또는 이 시스템에 의한 사용을 위해, 임의의 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체에서 구현될 수 있다. 이러한 의미에서, 로직은 예를 들어, 컴퓨터 판독가능 매체로부터 폐지되고 명령어 실행 시스템에 의해 실행될 수 있는 명령어들 및 선언들을 포함하는 스테이트먼트들을 포함할 수 있다. 본 개시내용의 맥락에서, "컴퓨터 판독가능 매체"는 명령어 실행 시스템과 관련하여 또는 이 시스템에 의한 사용을 위해 본 명세서에서 설명되는 로직 또는 애플리케이션을 포함, 저장, 또는 유지할 수 있는 임의의 매체일 수 있다.

[0526] 컴퓨터 판독가능 매체는, 예를 들어 자기, 광학 또는 반도체 매체와 같은 많은 물리적 매체 중 임의의 매체를 포함할 수 있다. 적합한 컴퓨터 판독가능 매체의 보다 구체적인 예들은, 이에 제한되는 것은 아니지만, 자기 테이프들, 자기 플로피 디스켓들, 자기 하드 드라이브들, 메모리 카드들, 고체 상태 드라이브들, USB 플래시 드라이브들, 또는 광학 디스크들을 포함할 것이다. 또한, 컴퓨터 판독가능 매체는, 예를 들어, SRAM(static random access memory) 및 DRAM(dynamic random access memory), 또는 MRAM(magnetic random access memory)을 포함하는 RAM(random access memory)일 수 있다. 또한, 컴퓨터 판독가능 매체는 ROM(read-only memory), PROM(programmable read-only memory), EPROM(erasable programmable read-only memory), EEPROM(electrically erasable programmable read-only memory), 또는 다른 유형의 메모리 디바이스일 수 있다.

[0527] 또한, 사용자 인증 애플리케이션(2128) 및 인증 애플리케이션(2163)을 포함하는, 본 명세서에서 설명되는 임의의 로직 또는 애플리케이션은 다양한 방식으로 구현되고 구조화될 수 있다. 예를 들어, 설명된 하나 이상의 애플리케이션은 단일 애플리케이션의 모듈들 또는 컴포넌트들로서 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서에 설명되는 하나 이상의 애플리케이션은 공유된 또는 별개의 컴퓨팅 디바이스들 또는 이들의 조합으로 실행될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에 설명되는 복수의 애플리케이션은 동일한 컴퓨팅 디바이스에서, 동일한 컴퓨팅 환경에서의 다수의 컴퓨팅 디바이스에서, 또는 동일한 사용자 디바이스에서 실행될 수 있다. 추가로, "애플리케이션", "서비스", "시스템", "엔진", "모듈" 등과 같은 용어들은 상호교환가능할 수 있고 제한하려는 의도가 아니라는 점이 이해된다.

[0528] 진술한 것에 부가하여, 본 개시내용의 다양한 실시예들은 이하의 조항들에 기재된 실시예들을 포함하지만, 이들로 제한되지 않는다:

[0529] 조항 1. 유효 키 코드를 수신하도록 적응되는 네트워크 인터페이스; 지상 매체를 따라 이동하는 유도 표면파로부터 전기 에너지를 획득하도록 구성되는 유도 표면파 수신 구조물- 유도 표면파에는 사용자 키 코드가 임베딩됨 -; 유효 키 코드에 대해 사용자 키 코드를 검증하도록 적응되는 처리 회로- 처리 회로는 사용자 키 코드가 무효화되는 것에 응답하여 유도 표면파로부터의 전기 에너지의 전기 부하로의 전달을 디스에이블하도록 적응됨 -; 유도 표면파 수신 구조물에 결합된 전기 부하- 전기 부하는 유도 표면파를 생성하는 유도 표면 도파로 프로브에 결합된 여기 소스에서 부하로서 경험됨 -를 포함하는, 장치.

[0530] 조항 2. 조항 1에 있어서, 유효 키 코드는 전력 서비스 제어기 디바이스로부터 주기적으로 수신되는, 장치.

[0531] 조항 3. 조항 1 또는 조항 2에 있어서, 유효 키 코드를 저장하도록 구성되는 예약된 메모리 부분을 추가로 포함하는, 장치.

[0532] 조항 4. 조항 1 내지 조항 3 중 어느 한 조항에 있어서, 유효 키 코드는 암호화된 네트워크 채널을 통해 수신되는, 장치.

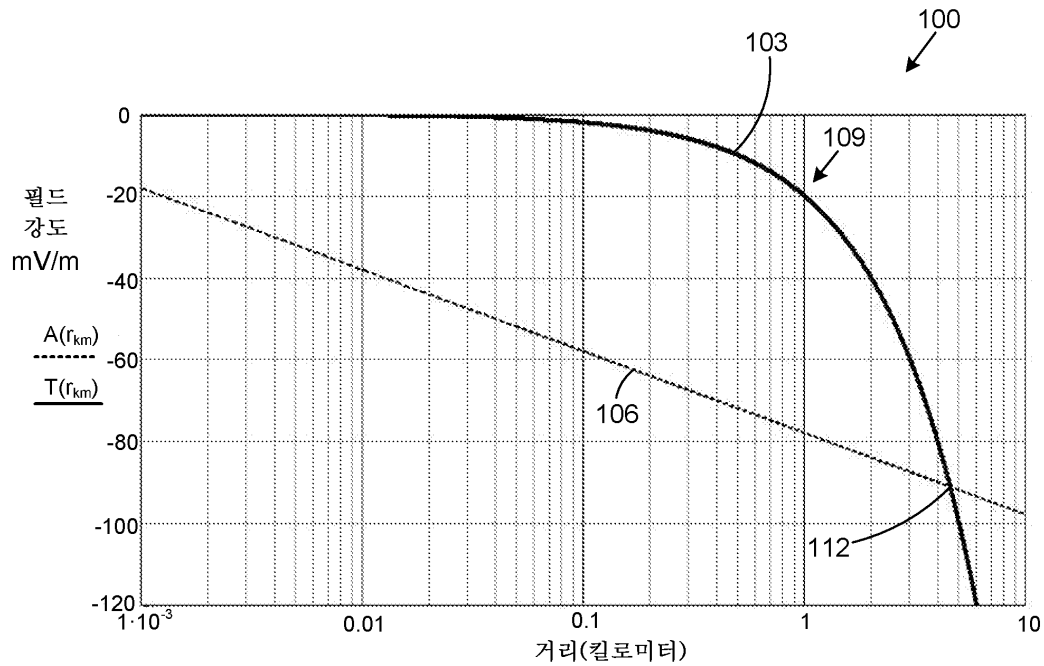
[0533] 조항 5. 조항 1 내지 조항 3 중 어느 한 조항에 있어서, 유효 키 코드는 셀룰러 통신 채널을 통해 수신되는, 장치.

- [0534] 조항 6. 방법으로서, 유도 표면과 수신 구조물에 결합된 처리 회로를 통해 사용자 키 코드를 획득하는 단계; 유도 표면과 수신 구조물을 사용하여 유도 표면과의 형태로 전기 에너지를 수신하는 단계- 전기 에너지에는 유효 키 코드가 임베딩됨 -; 사용자 키 코드를 획득하기 위해 처리 회로를 통해 유도 표면과를 처리하는 단계; 유효 키 코드에 대해 비교하기 위한 사용자 키 코드를 처리 회로를 통해 검증하는 단계- 처리 회로는 사용자 키 코드가 무효화되는 것에 응답하여 유도 표면과로부터의 전기 에너지의 전기 부하로의 전달을 디스에이블하도록 적응됨 -; 및 검증된 사용자 키 코드에 응답하여 유도 표면과 수신 구조물에 결합된 전기 부하에 전기 에너지를 공급하는 단계를 포함하는, 방법.
- [0535] 조항 7. 조항 6에 있어서, 유효 키 코드는 셀룰러 통신 채널을 통해 수신되는, 방법.
- [0536] 조항 8. 조항 6에 있어서, 유효 키 코드는 암호화된 네트워크 채널을 통해 수신되는, 방법.
- [0537] 조항 9. 조항 6 내지 조항 8 중 어느 한 조항에 있어서, 유효 키 코드는 전력 서비스 제어기 디바이스로부터 주기적으로 수신되는, 방법.
- [0538] 조항 10. 조항 6 내지 조항 9 중 어느 한 조항에 있어서, 사용자 키를 휘발성 메모리에 유지하는 단계를 추가로 포함하는, 방법.
- [0539] 조항 11. 조항 6 내지 조항 10 중 어느 한 조항에 있어서, 처리 회로의 기동시 갱신된 사용자 키를 체크하는 단계를 추가로 포함하는, 방법.
- [0540] 조항 12. 조항 6 내지 조항 11 중 어느 한 조항에 있어서, 사용자 키 코드를 획득하기 전에 유도 표면과 수신 구조물과 연관된 사용자를 인증하는 단계를 추가로 포함하는, 방법.
- [0541] 조항 13. 장치로서, 손실형 전도성 매체를 통해 유도 표면과를 발진하도록 구성되는 유도 표면 도파로 프로브; 유도 표면과 내에 유효 키 코드를 임베딩하도록 구성되는 변조 회로; 및 유도 표면과를 수신하도록 구성되는 유도 표면과 수신 장비에 대역 외 통신 채널에서 사용자 키 코드를 전송하도록 추가로 구성되는 제어기 디바이스- 유효 키 코드에 대한 사용자 키 코드의 긍정적인 비교는 유도 표면과로부터 획득된 전기 에너지를 전기 부하로 전달하기 위한 허가를 표시함 -를 포함하는, 장치.
- [0542] 조항 14. 조항 13에 있어서, 유도 표면 도파로 프로브는 손실형 전도성 매체 위쪽으로 상승된 충전 단자를 포함하고, 손실형 전도성 매체의 복소 브루스터의 입사각($\theta_{i,B}$)으로 입사하는 파면을 합성하는 적어도 하나의 결과적인 필드를 생성하도록 구성되는, 장치.
- [0543] 조항 15. 조항 14에 있어서, 충전 단자는 복수의 충전 단자 중 하나인, 장치.
- [0544] 조항 16. 조항 14에 있어서, 충전 단자에 전기적으로 결합되는 공급 네트워크를 추가로 포함하고, 공급 네트워크는 유도 표면 도파로 프로브 부근에서 손실형 전도성 매체와 연관된 복소 브루스터 입사각($\theta_{i,B}$)과 연관된 파경사각(ψ)과 매칭하는 위상 지연(Φ)을 제공하는, 장치.
- [0545] 조항 17. 조항 16에 있어서, 충전 단자는 복수의 충전 단자 중 하나인, 장치.
- [0546] 조항 18. 조항 13 내지 조항 17 중 어느 한 조항에 있어서, 제어기 디바이스는 갱신된 유효 키 코드를 유도 표면과 수신 장비에 주기적으로 송신하는, 장치.
- [0547] 조항 19. 조항 18에 있어서, 갱신된 유효 키 코드는 유도 표면 도파로 프로브에 의해 제공되는 전력 서비스의 현재 가입자의 네트워크 주소로 송신되는, 장치.
- [0548] 조항 20. 조항 13 내지 조항 19 중 어느 한 조항에 있어서, 유효 키 코드를 생성하도록 적응되는 키 생성기 애플리케이션을 추가로 포함하는, 장치.
- [0549] 조항 21. 조항 13 내지 조항 20 중 어느 한 조항에 있어서, 대역 외 통신 채널은 네트워크 암호화된 채널을 포함하는, 장치.
- [0550] 조항 22. 조항 13 내지 조항 20 중 어느 한 조항에 있어서, 대역 외 통신 채널은 셀룰러 통신 채널을 포함하는, 장치.
- [0551] 본 개시내용의 앞서 기술된 실시예들은 단지 본 개시내용의 원리들의 명확한 이해를 위해 기재된 구현들의 가능한 예들이라는 점이 강조되어야 한다. 본 개시내용의 사상 및 원리들로부터 실질적으로 벗어나지 않고 앞서 기술된 실시예(들)에 많은 변형들 및 수정들이 행해질 수 있다. 모든 이러한 수정들 및 변형들은 본원에서 본 개

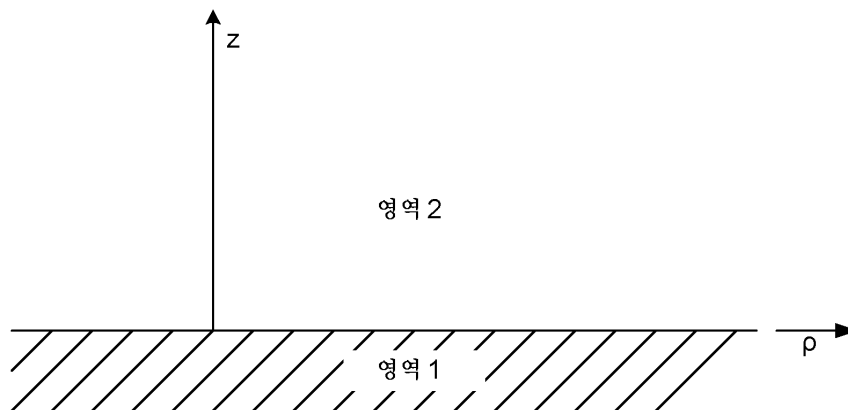
시내용의 범주 내에 포함되고 이하의 청구항들에 의해 보호되는 것으로 의도되어 있다. 그에 부가하여, 기술된 실시예들 및 종속 청구항들의 모든 임의적이고 바람직한 특징들 및 수정들이 본원에 교시되는 개시내용의 모든 양태들에서 사용가능하다. 게다가, 종속 청구항들의 개별적인 특징들은 물론, 기술된 실시예들의 모든 임의적이고 바람직한 특징들 및 수정들이 서로 조합가능하고 상호교환가능하다.

도면

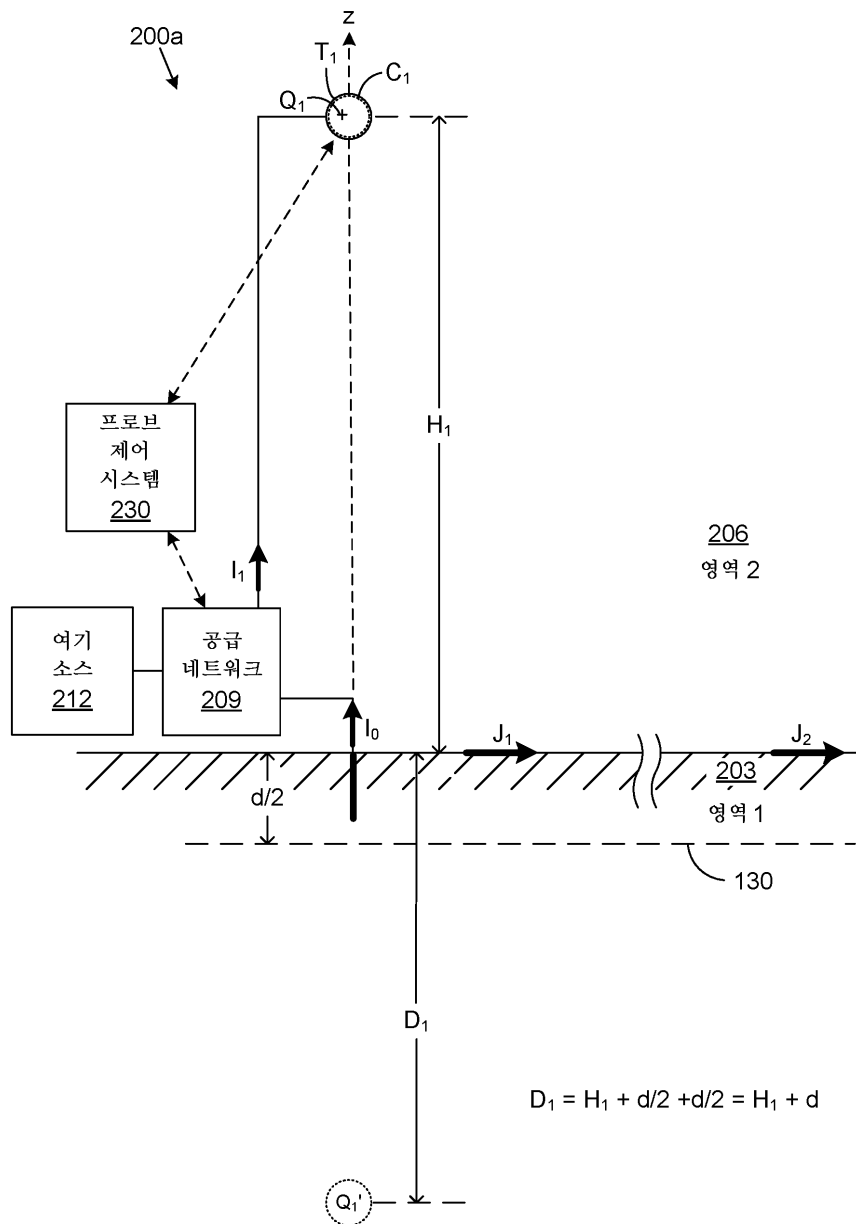
도면1



도면2

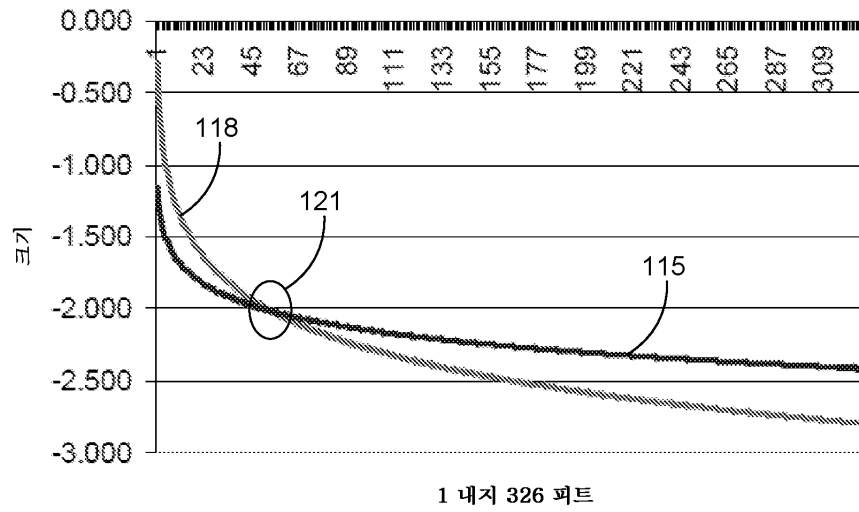


도면3

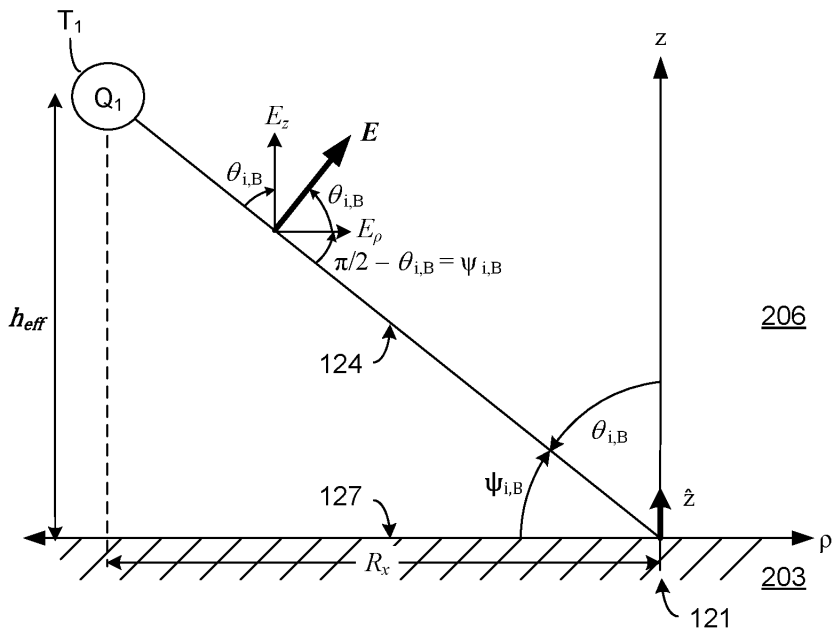


도면4

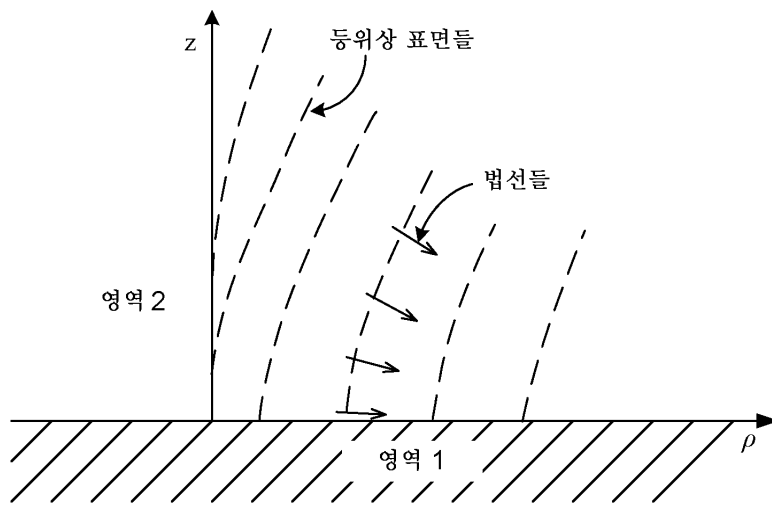
크로스오버 지점까지의 거리



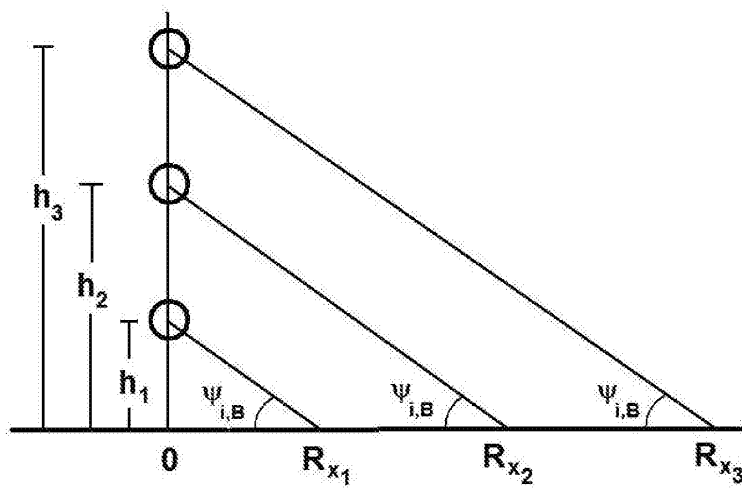
도면5a



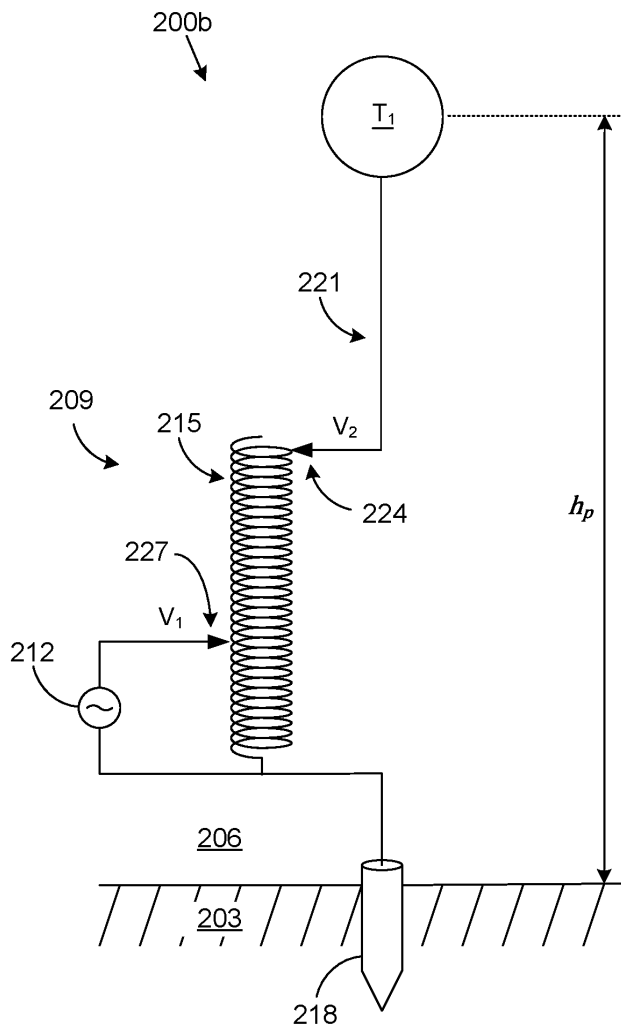
도면5b



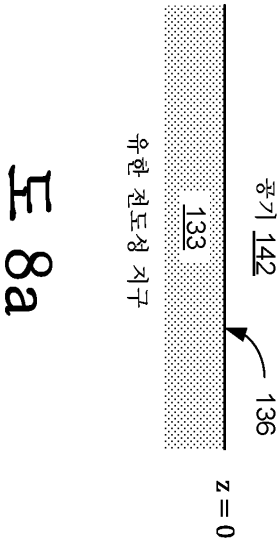
도면6



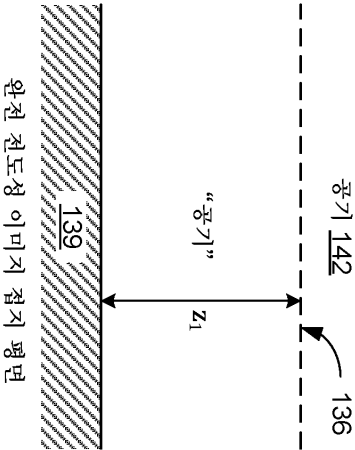
도면7



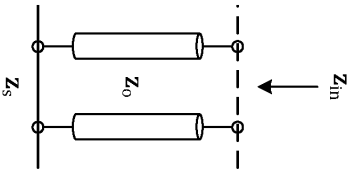
도면8



도 8a

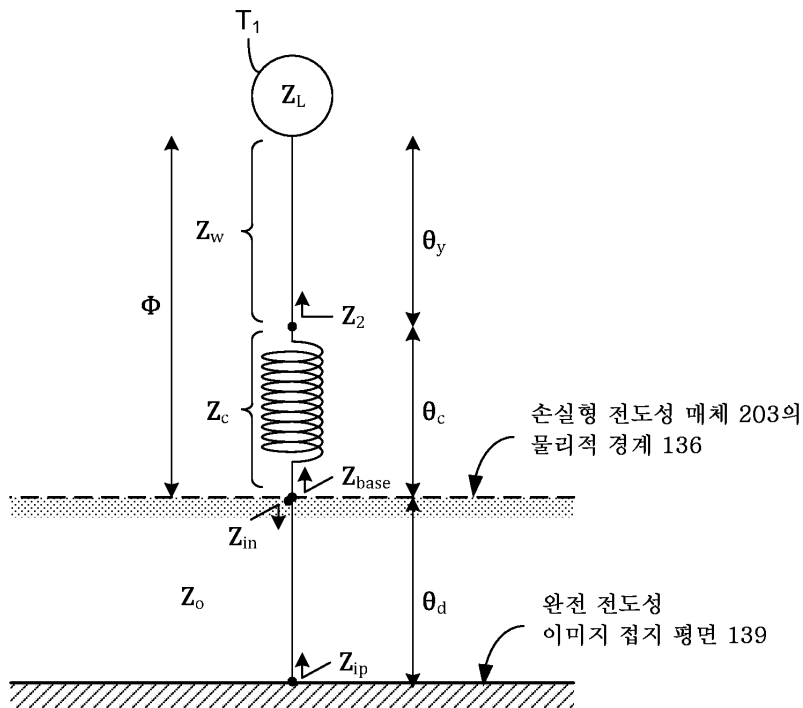


도 8b

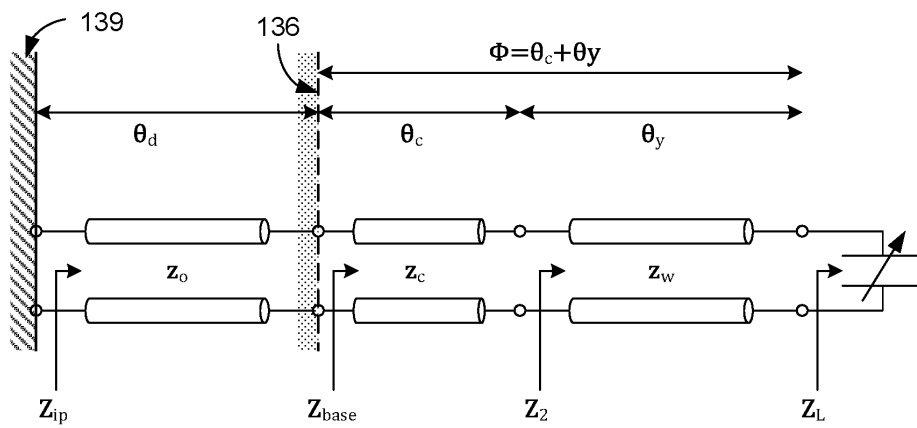


도 8c

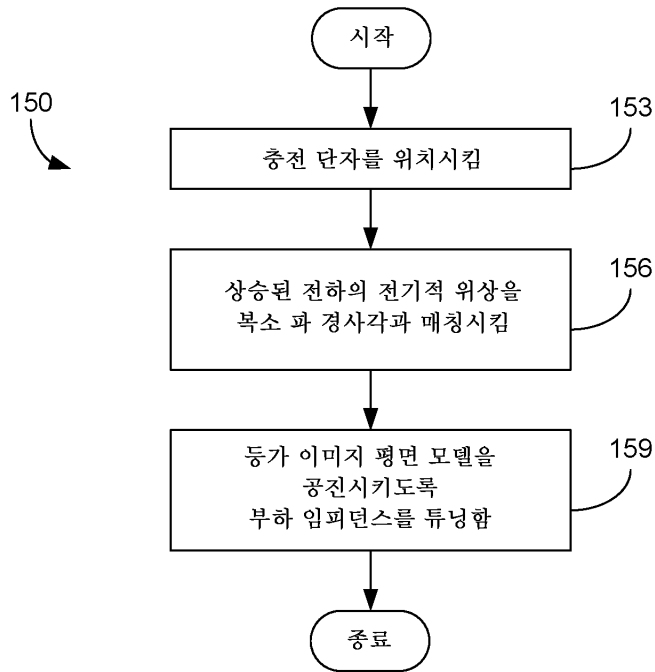
도면9a



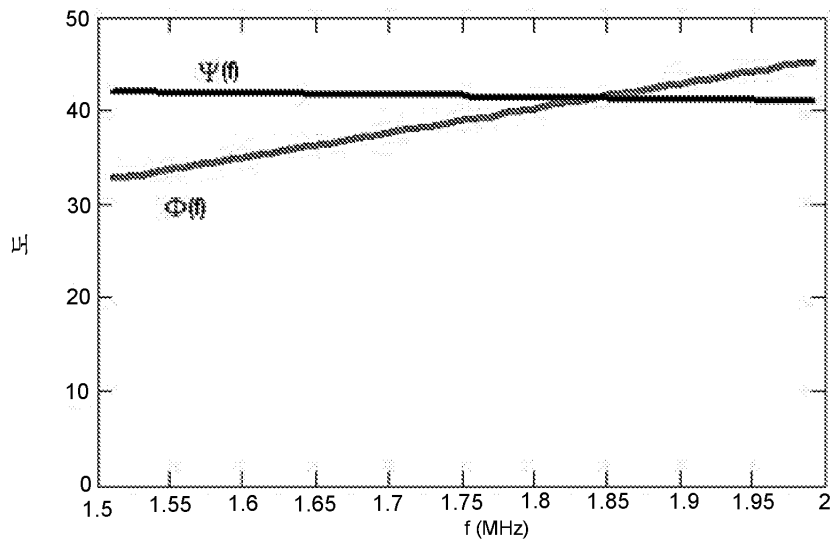
도면9b



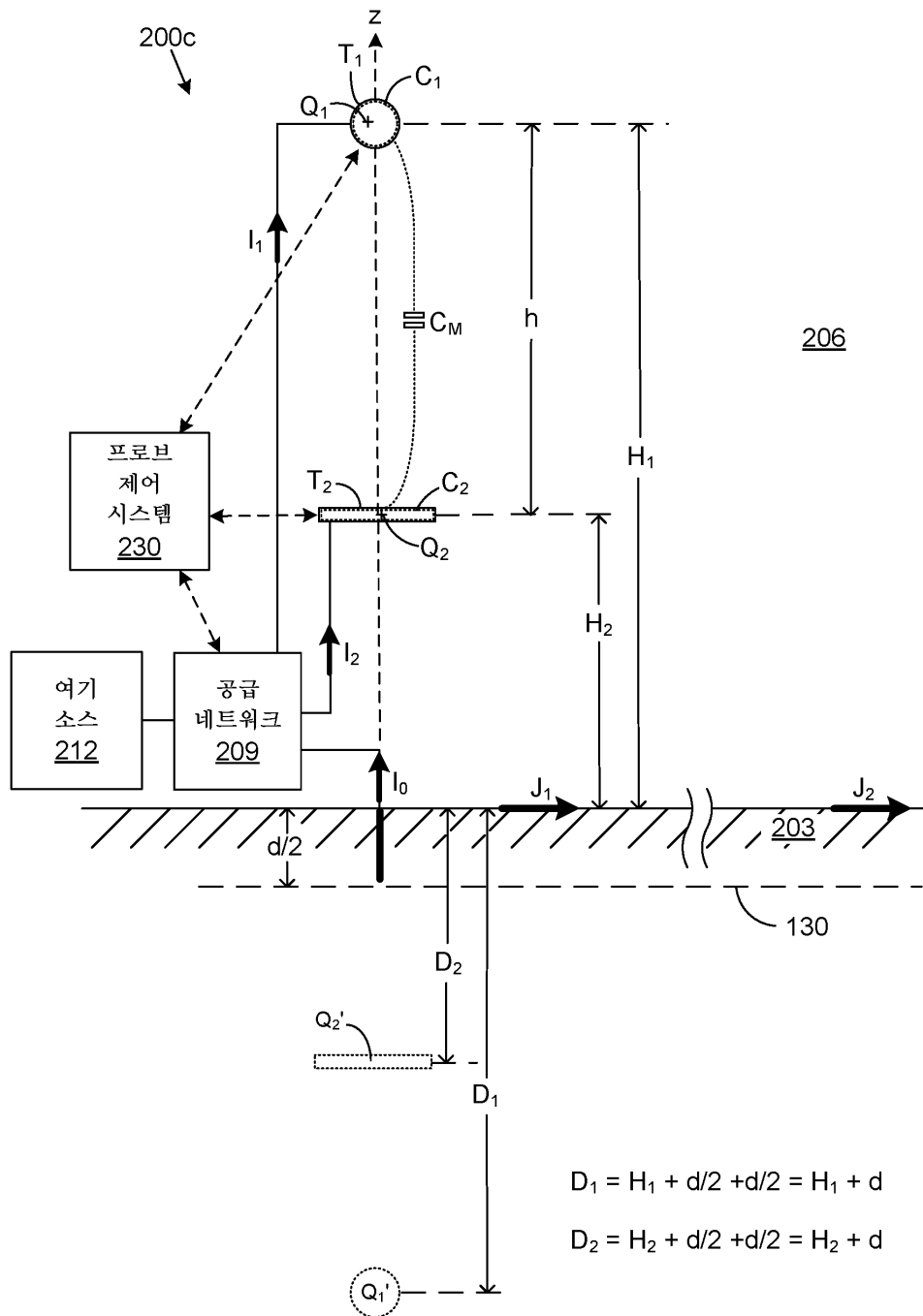
도면10



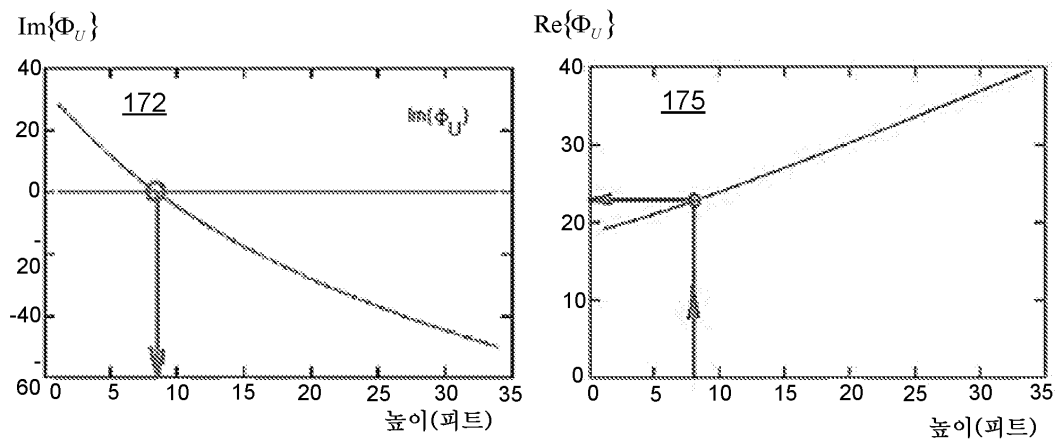
도면11



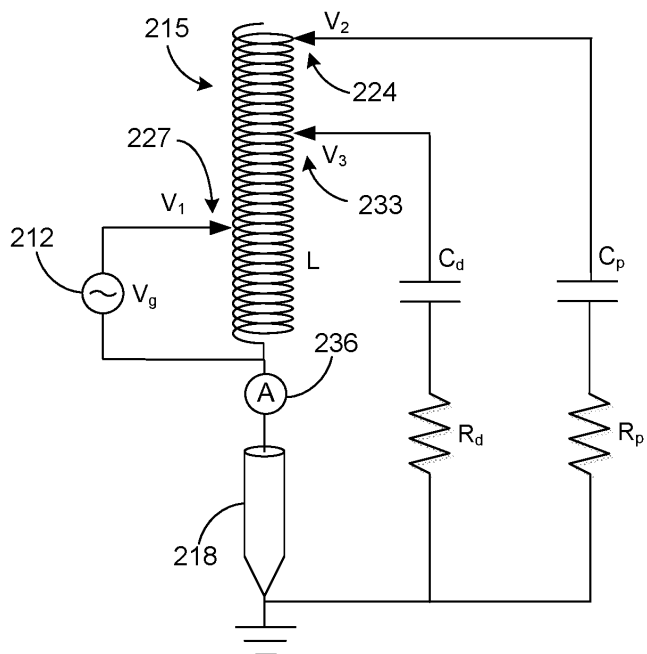
도면12



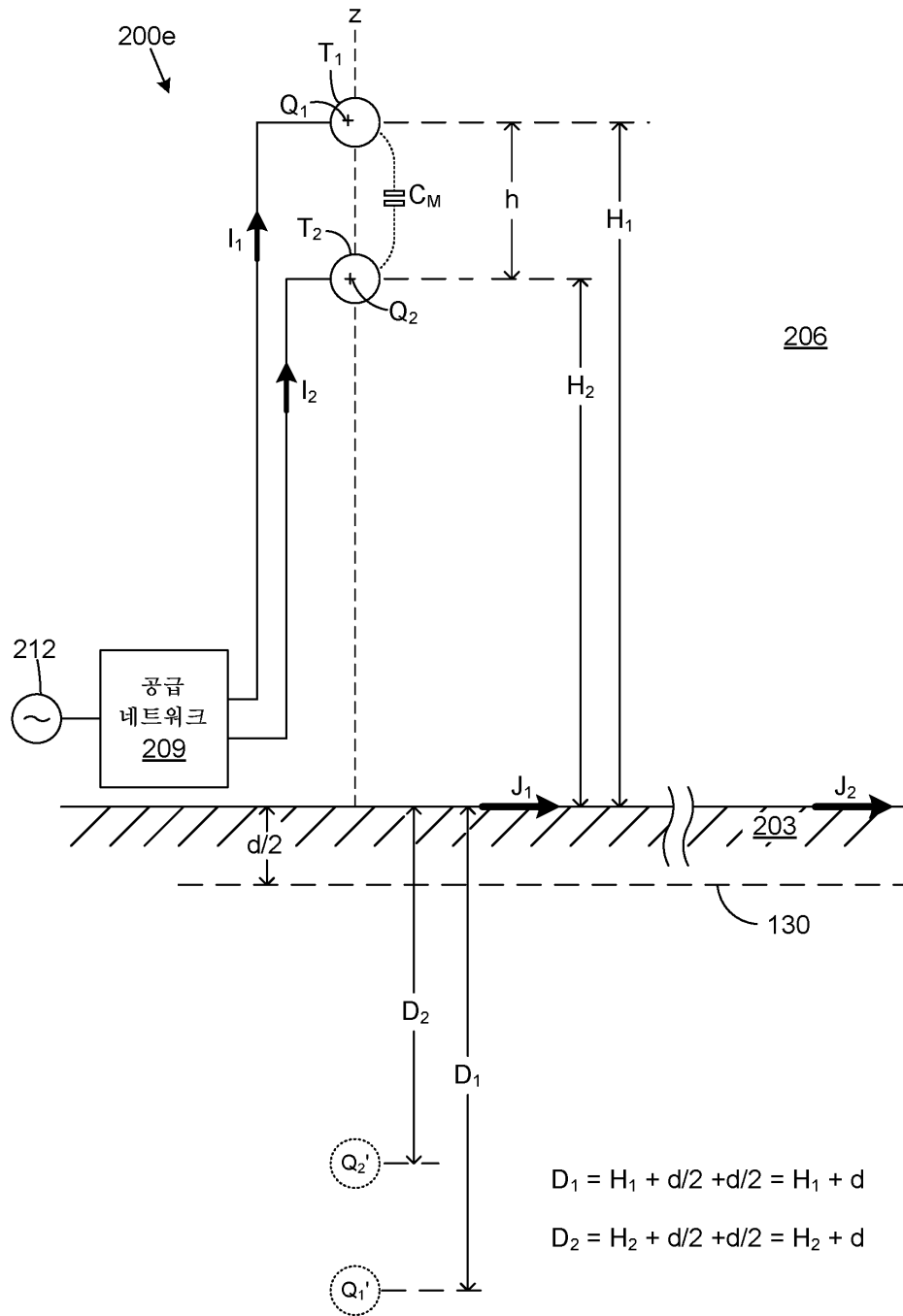
도면15a



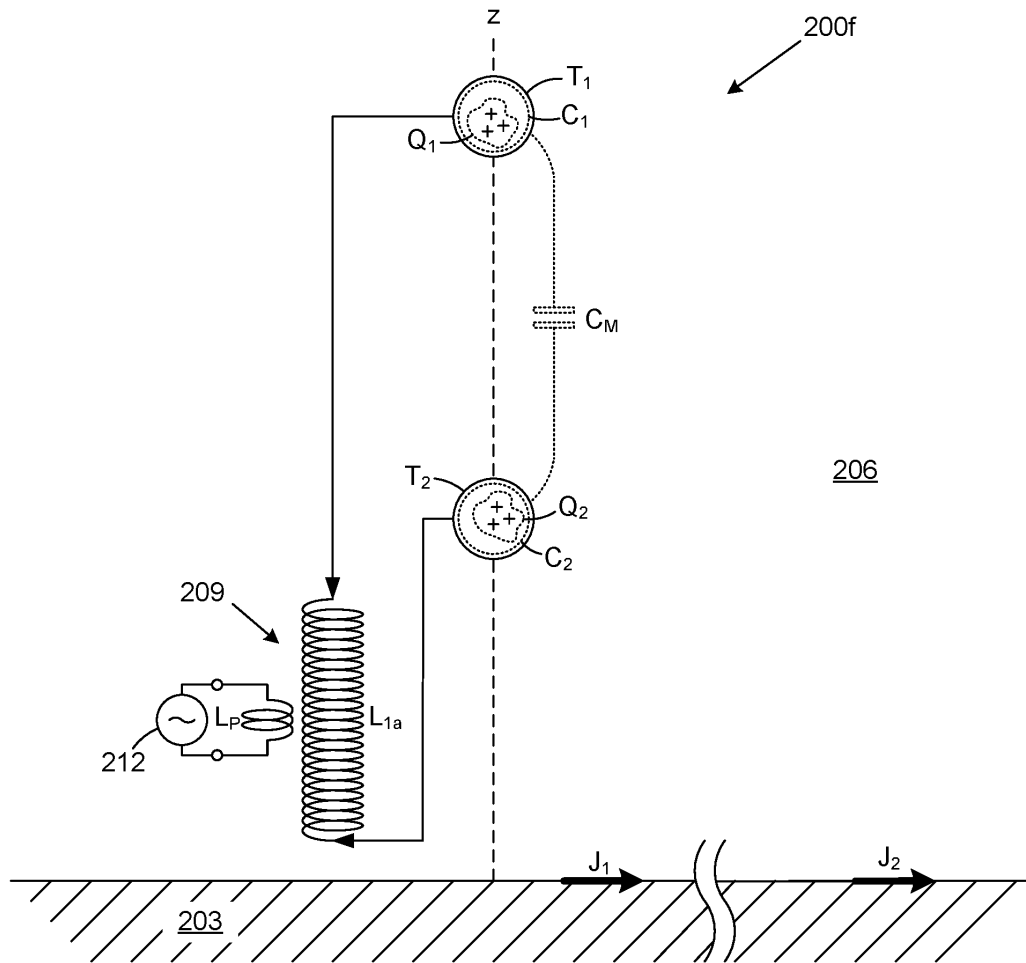
도면15b



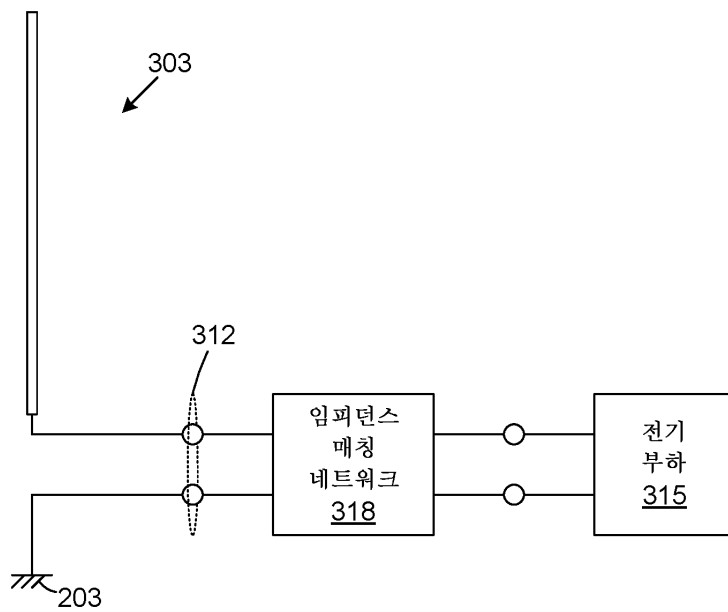
도면16



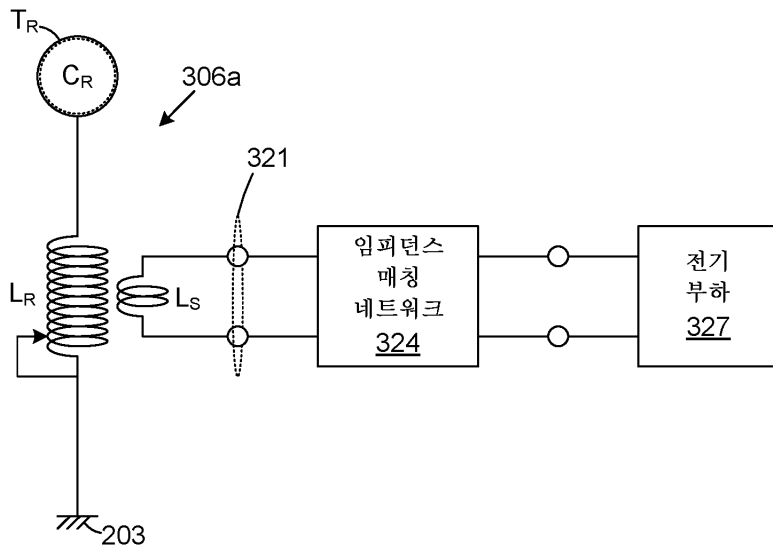
도면17



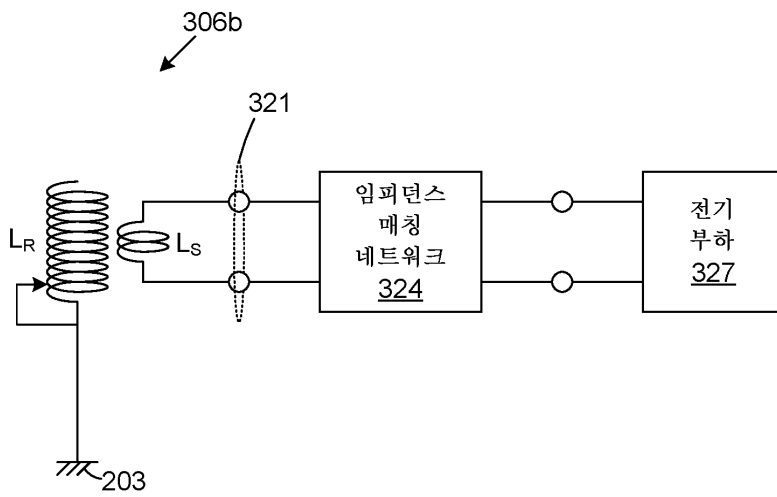
도면18a



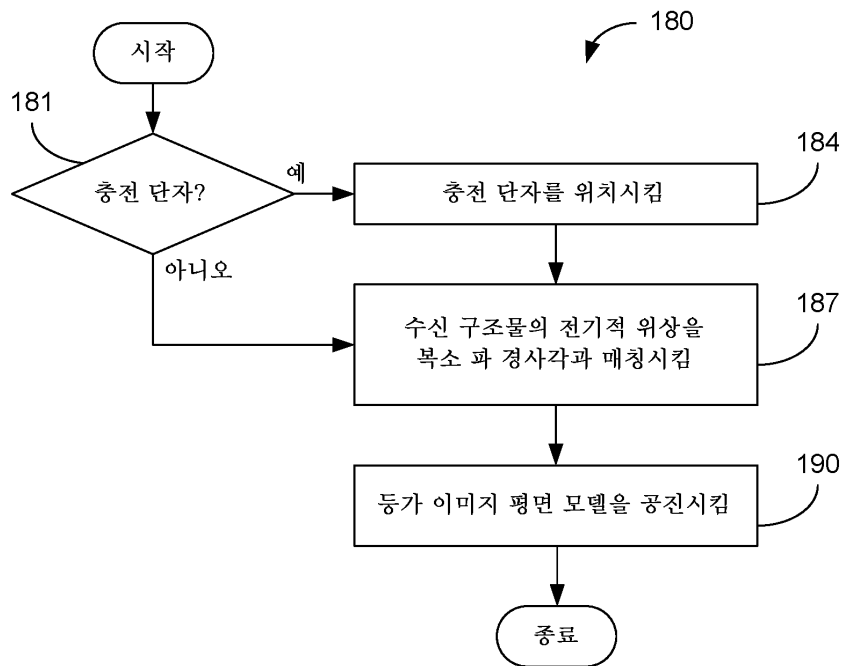
도면18b



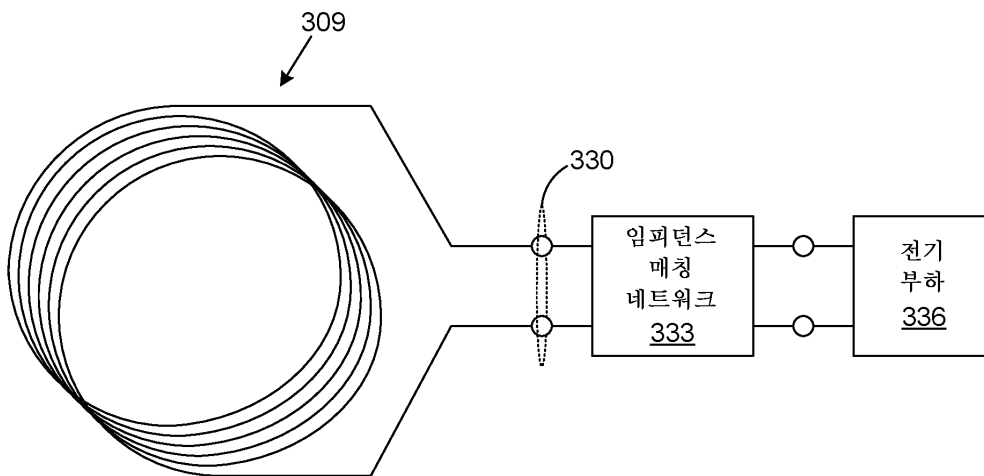
도면18c



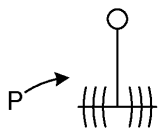
도면18d



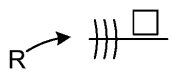
도면19



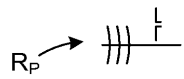
도면20a



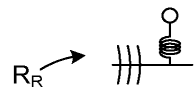
도면20b



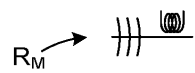
도면20c



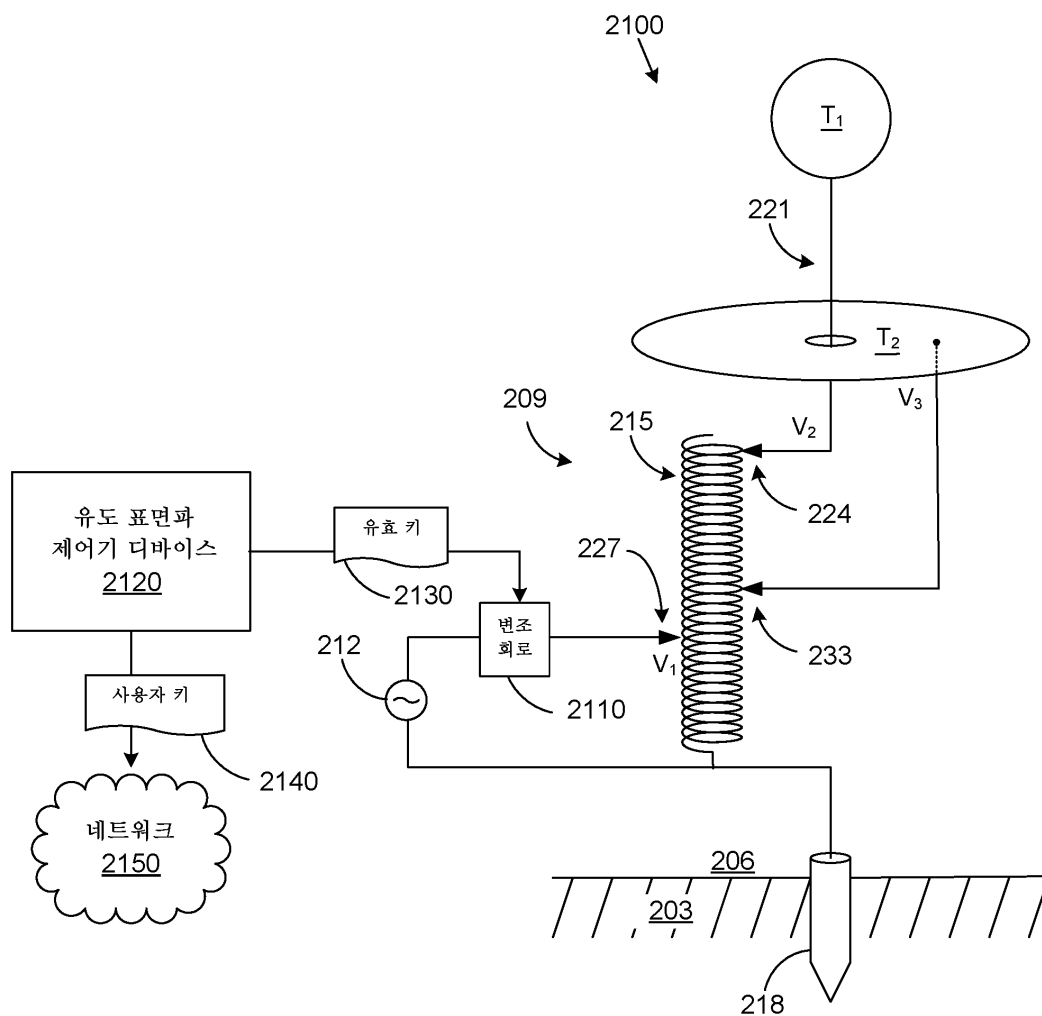
도면20d



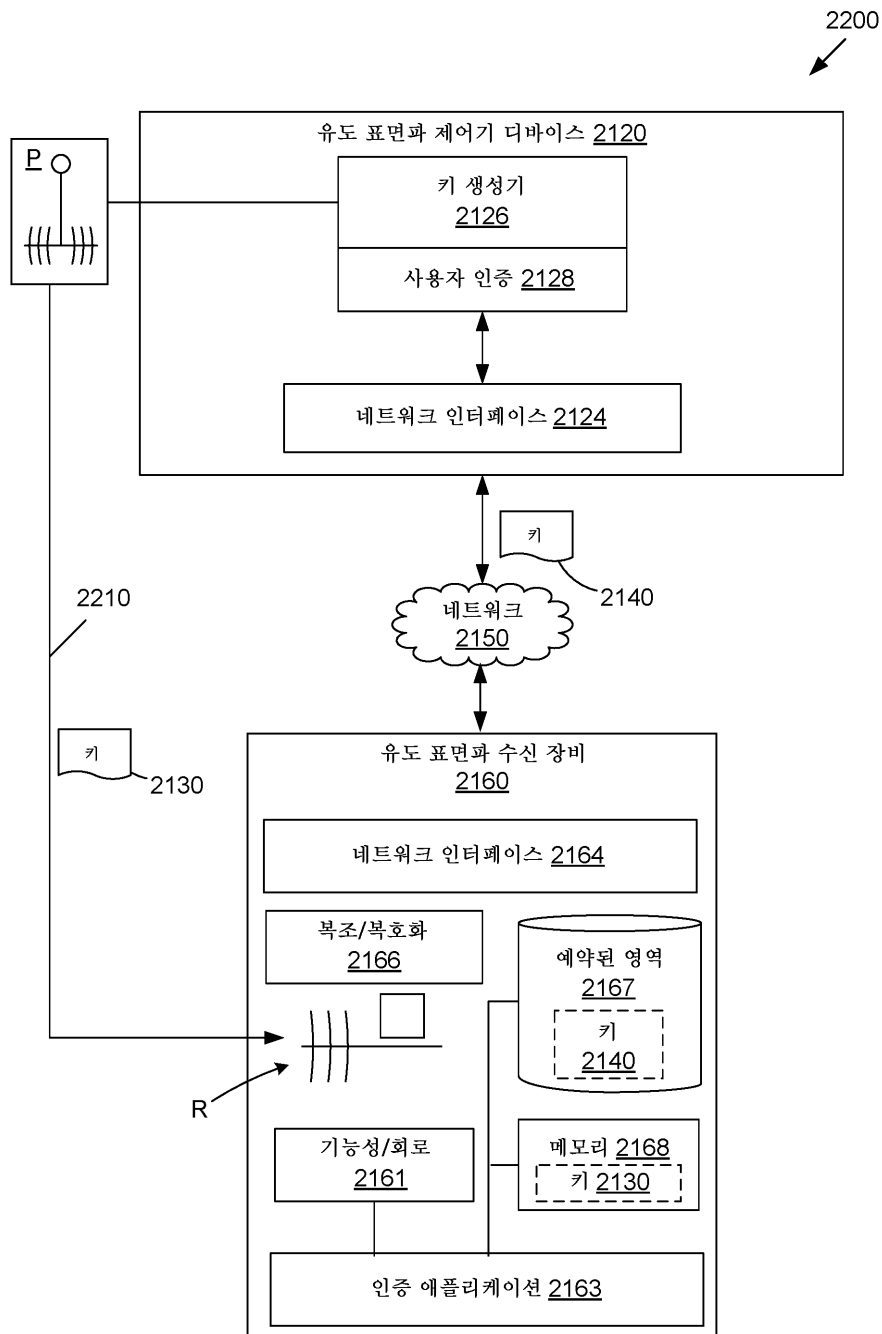
도면20e



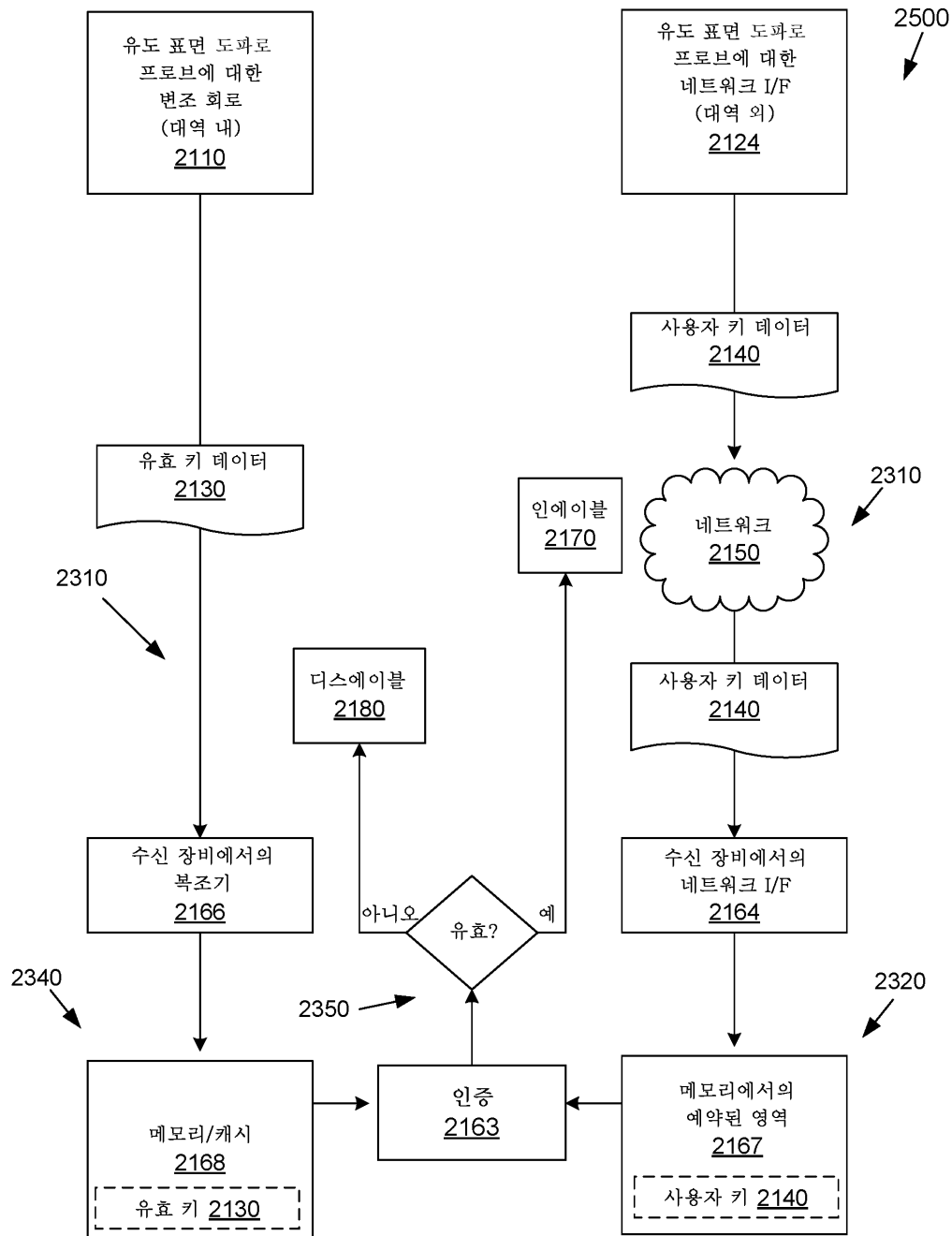
도면21



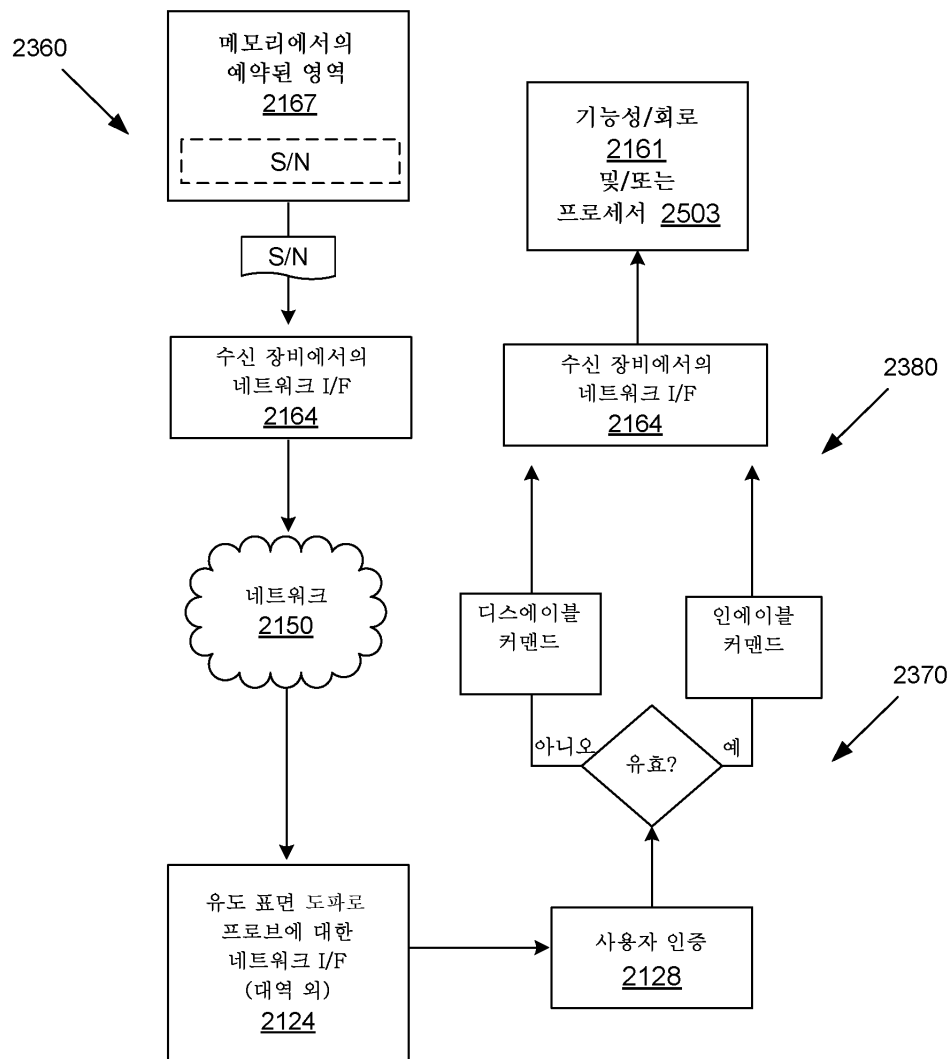
도면22



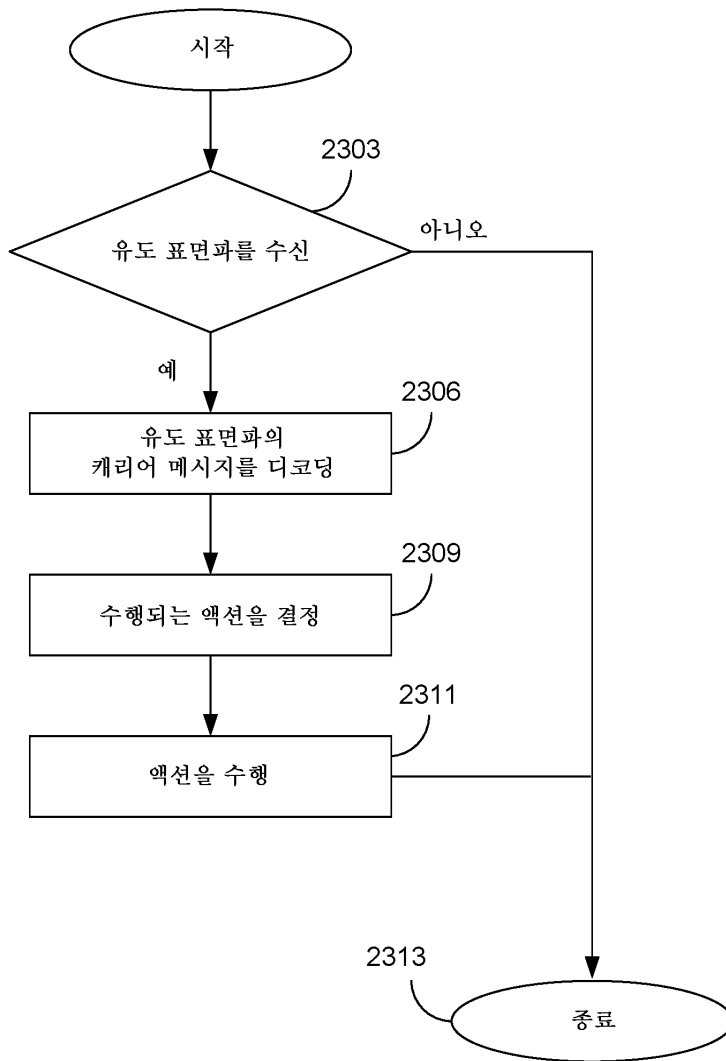
도면23a



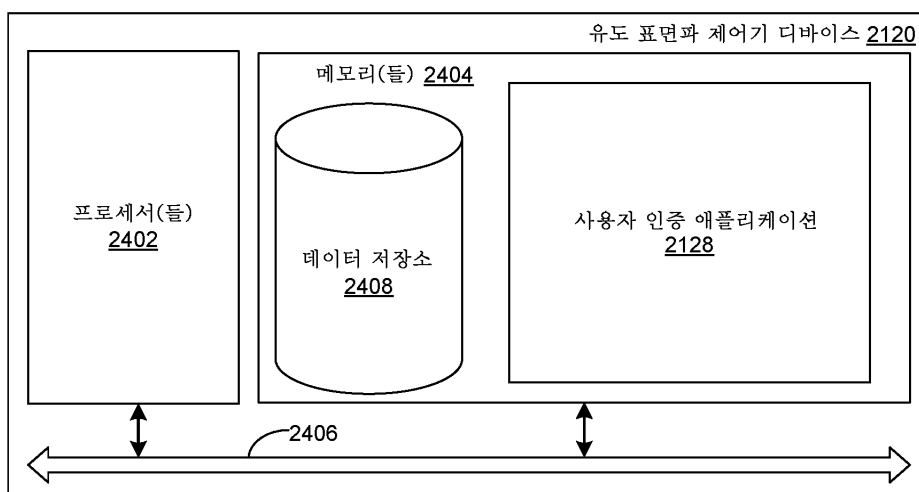
도면23b



도면24



도면25



도면26

